(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

정정판

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2018 년 8 월 2 일 (02.08.2018)

WIPO | PCT

(10) 국제공개번호
WO 2018/139767 A9

(51) 국제특허분류:
C07D 409/12 (2006.01) *C07D 333/76* (2006.01)
C07D 407/12 (2006.01) *H01L 51/00* (2006.01)
C07D 307/91 (2006.01) *H01L 51/50* (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2017/015256

(22) 국제출원일: 2017 년 12 월 21 일 (21.12.2017)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2017-0012952 2017 년 1 월 26 일 (26.01.2017) KR
10-2017-0149677 2017 년 11 월 10 일 (10.11.2017) KR

(71) 출원인: **주식회사 엘지화학 (LG CHEM, LTD.)** [KR/KR]; 07336 서울시 영등포구 여의대로 128, Seoul (KR).

(72) 발명자: **차용범 (CHA, Yong Bum)**; 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). **전상영 (JEON, Sang Young)**; 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). **조연호 (CHO, Yeon Ho)**; 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR). **김연환 (KIM, Yeon Hwan)**; 34122 대전시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원, Daejeon (KR).

(74) 대리인: **유미특허법인 (YOU ME PATENT AND LAW FIRM)**; 06134 서울시 강남구 테헤란로 115, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:
— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(48) 본 정정판 공개일:
2019 년 3 월 14 일 (14.03.2019)

(15) 정정사항에 관한 정보:
2019 년 3 월 14 일 (14.03.2019) 자 공지 참조

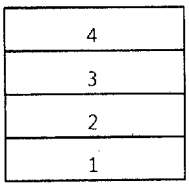
(54) **Title:** NOVEL AMINE-BASED COMPOUND AND ORGANIC LIGHT EMITTING DEVICE USING SAME

(54) **발명의 명칭:** 신규한 아민계 화합물 및 이를 이용한 유기발광 소자

(57) **Abstract:** The present invention provides a novel amine-based compound and an organic light emitting device using the same.

(57) **요약서:** 본 발명은 신규한 아민계 화합물 및 이를 이용한 유기발광 소자를 제공한다.

【도 1】



WO 2018/139767 A9

【발명의 명칭】

신규한 아민계 화합물 및 이를 이용한 유기발광 소자

【기술분야】

관련 출원(들)과의 상호 인용

본 출원은 2017년 1월 26일자 한국 특허 출원 제 10-2017-0012952호, 및 2017년 11월 10일자 한국 특허 출원 제 10-2017-0149677호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원들의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.

본 발명은 신규한 아민계 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로 유기 발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기 발광 현상을 이용하는 유기 발광 소자는 넓은 시야각, 우수한 콘트라스트, 빠른 응답 시간을 가지며, 휘도, 구동 전압 및 응답 속도 특성이 우수하여 많은 연구가 진행되고 있다.

유기 발광 소자는 일반적으로 양극과 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 상기 유기물층은 유기 발광 소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다. 이러한 유기 발광 소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공이, 음극에서는 전자가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 다시 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다.

상기와 같은 유기 발광 소자에 사용되는 유기물에 대하여 새로운 재료의 개발이 지속적으로 요구되고 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 0001) 한국특허 공개번호 제10-2000-0051826호

【발명의 내용】

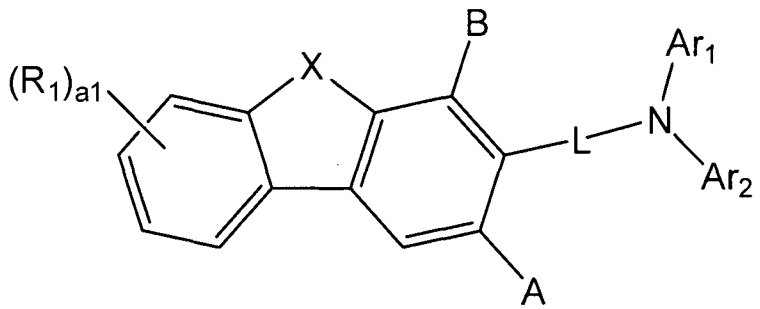
【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 신규한 아민계 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자에 관한 것이다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다:

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

X는 O 또는 S이고,

A 및 B는 각각 독립적으로, 수소; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 내지 3개 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴이되, A 및 B가 모두 수소인 경우는 제외하고,

L은 단일 결합; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴렌; 또는 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 이상을 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴렌이고,

Ar_1 및 Ar_2는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 내지 3개 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴이고,

R_1은 수소; 중수소; 할로겐; 시아노; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 알킬; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 할로알킬; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 알콕시; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 할로알콕시; 치환 또는 비치환된 C_{3-60} 사이클로알킬; 치환 또는 비치환된 C_{2-60} 알케닐; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴옥시; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C_{2-60} 헤테로고리기이고,

a1은 0 내지 4의 정수이다.

또한, 본 발명은 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자를 제공한다.

【발명의 효과】

상술한 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자의 유기물층의 재료로서 사용될 수 있으며, 유기 발광 소자에서 효율의 향상, 낮은 구동전압 및/또는 수명 특성을 향상시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 기판(1), 양극(2), 발광층(3), 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.

도 2는 기판(1), 양극(2), 정공주입층(5), 정공수송층(6), 발광층(7), 전자수송층(8) 및 음극(4)로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

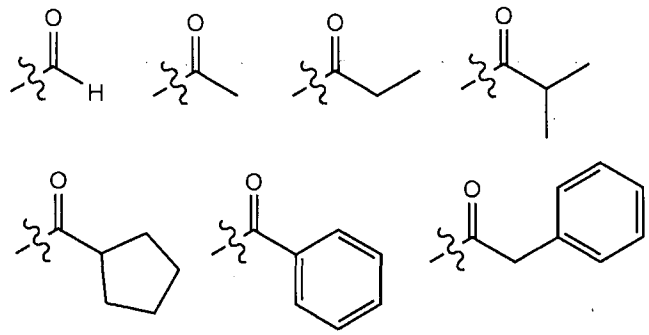
이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 보다 상세히 설명한다.

본 명세서에서, $\overset{\S}{\S}$ 는 다른 치환기에 연결되는 결합을 의미하고, 단일

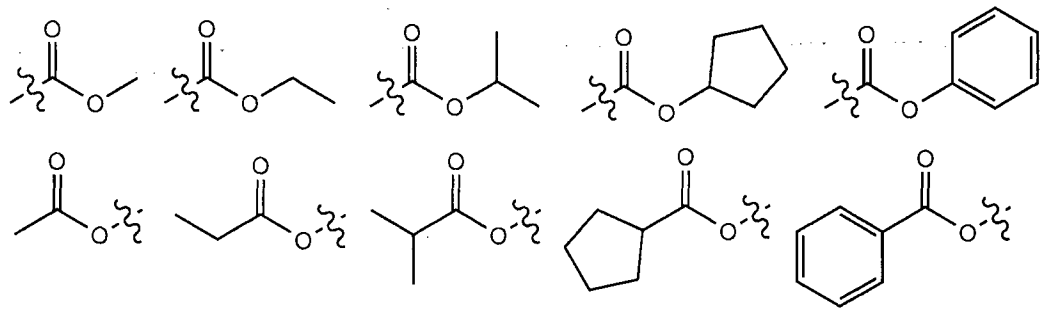
결합은 L로 표시되는 부분에 별도의 원자가 존재하지 않은 경우를 의미한다.

본 명세서에서 "치환 또는 비치환된" 이라는 용어는 중수소; 할로겐기; 시아노기; 니트릴기; 니트로기; 히드록시기; 카보닐기; 에스테르기; 이미드기; 아미노기; 포스핀옥사이드기; 알콕시기; 아릴옥시기; 알킬티옥시기; 아릴티옥시기; 알킬술폭시기; 아릴술폭시기; 실릴기; 붕소기; 알킬기; 사이클로알킬기; 알케닐기; 아릴기; 아르알킬기; 아르알케닐기; 알킬아릴기; 알킬아민기; 아랄킬아민기; 헤테로아릴아민기; 아릴아민기; 아릴포스핀기; 또는 N, O 및 S 원자 중 1개 이상을 포함하는 헤테로고리기로 이루어진 군에서 선택된 1개 이상의 치환기로 치환 또는 비치환되거나, 상기 예시된 치환기 중 2 이상의 치환기가 연결된 치환 또는 비치환된 것을 의미한다. 예컨대, "2 이상의 치환기가 연결된 치환기"는 바이페닐기일 수 있다. 즉, 바이페닐기는 아릴기일 수도 있고, 2개의 페닐기가 연결된 치환기로 해석될 수도 있다.

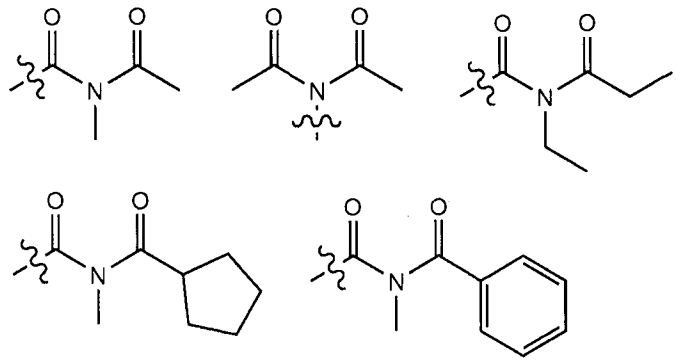
본 명세서에서 카보닐기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 40인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



본 명세서에 있어서, 에스테르기는 에스테르기의 산소가 탄소수 1 내지 25의 직쇄, 분지쇄 또는 고리쇄 알킬기 또는 탄소수 6 내지 25의 아릴기로 치환될 수 있다. 구체적으로, 하기 구조식의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



본 명세서에 있어서, 이미드기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 1 내지 25인 것이 바람직하다. 구체적으로 하기와 같은 구조의 화합물이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.



본 명세서에 있어서, 실릴기는 구체적으로 트리메틸실릴기, 트리에틸실릴기, t-부틸디메틸실릴기, 비닐디메틸실릴기, 프로필디메틸실릴기, 트리페닐실릴기, 디페닐실릴기, 페닐실릴기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.

본 명세서에 있어서, 붕소기는 구체적으로 트리메틸붕소기, 트리에틸붕소기, t-부틸디메틸붕소기, 트리페닐붕소기, 페닐붕소기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.

본 명세서에 있어서, 할로겐기의 예로는 불소, 염소, 브롬 또는 요오드가 있다.

본 명세서에 있어서, 상기 알킬기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나 1 내지 40인 것이 바람직하다. 일

실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알킬기의 탄소수는 1 내지 6이다. 알킬기의 구체적인 예로는 메틸, 에틸, 프로필, n-프로필, 이소프로필, 부틸, n-부틸, 이소부틸, tert-부틸, sec-부틸, 1-메틸-부틸, 1-에틸-부틸, 펜틸, n-펜틸, 이소펜틸, 네오펜틸, tert-펜틸, 헥실, n-헥실, 1-메틸펜틸, 2-메틸펜틸, 4-메틸-2-펜틸, 3,3-디메틸부틸, 2-에틸부틸, 헵틸, n-헵틸, 1-메틸헥실, 사이클로펜틸메틸, 사이클로헥틸메틸, 옥틸, n-옥틸, tert-옥틸, 1-메틸헵틸, 2-에틸헥실, 2-프로필펜틸, n-노닐, 2,2-디메틸헵틸, 1-에틸-프로필, 1,1-디메틸-프로필, 이소헥실, 2-메틸펜틸, 4-메틸헥실, 5-메틸헥실 등이 있으나, 이들에 한정되지 않는다.

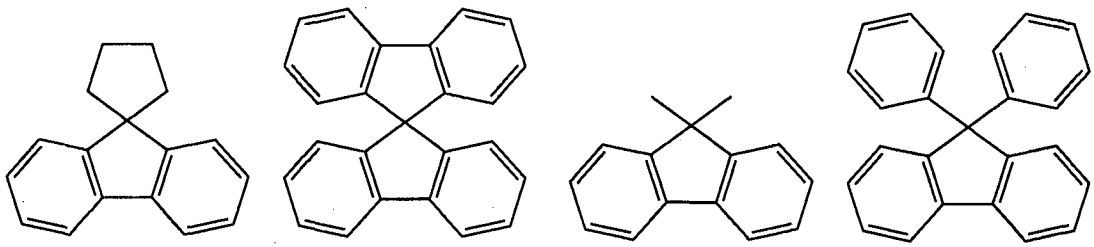
본 명세서에 있어서, 상기 알케닐기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 2 내지 40인 것이 바람직하다. 일 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 10이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 알케닐기의 탄소수는 2 내지 6이다. 구체적인 예로는 비닐, 1-프로페닐, 이소프로페닐, 1-부테닐, 2-부테닐, 3-부테닐, 1-펜테닐, 2-펜테닐, 3-펜테닐, 3-메틸-1-부테닐, 1,3-부타디에닐, 알릴, 1-페닐비닐-1-일, 2-페닐비닐-1-일, 2,2-디페닐비닐-1-일, 2-페닐-2-(나프틸-1-일)비닐-1-일, 2,2-비스(디페닐-1-일)비닐-1-일, 스틸베닐기, 스티레닐기 등이 있으나 이들에 한정되지 않는다.

본 명세서에 있어서, 사이클로알킬기는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 3 내지 60인 것이 바람직하며, 일 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 30이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 20이다. 또 하나의 실시상태에 따르면, 상기 사이클로알킬기의 탄소수는 3 내지 6이다. 구체적으로 사이클로프로필, 사이클로부틸, 사이클로펜틸, 3-메틸사이클로펜틸, 2,3-디메틸사이클로펜틸, 사이클로헥실, 3-메틸사이클로헥실, 4-메틸사이클로헥실, 2,3-

디메틸사이클로헥실, 3,4,5-트리메틸사이클로헥실, 4-tert-부틸사이클로헥실, 사이클로헵틸; 사이클로옥틸 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

본 명세서에 있어서, 아릴기는 특별히 한정되지 않으나 탄소수 6 내지 60인 것이 바람직하며, 단환식 아릴기 또는 다환식 아릴기일 수 있다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 30이다. 일 실시상태에 따르면, 상기 아릴기의 탄소수는 6 내지 20이다. 상기 아릴기가 단환식 아릴기로는 페닐기, 바이페닐기, 터페닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 다환식 아릴기로는 나프틸기, 안트라세닐기, 페난트릴기, 파이레닐기, 페릴레닐기, 크라이세닐기, 플루오레닐기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

본 명세서에 있어서, 플루오레닐기는 치환될 수 있고, 치환기 2개가 서로 결합하여 스피로 구조를 형성할 수 있다. 상기 플루오레닐기가 치환되는 경우,



등이 될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니다.

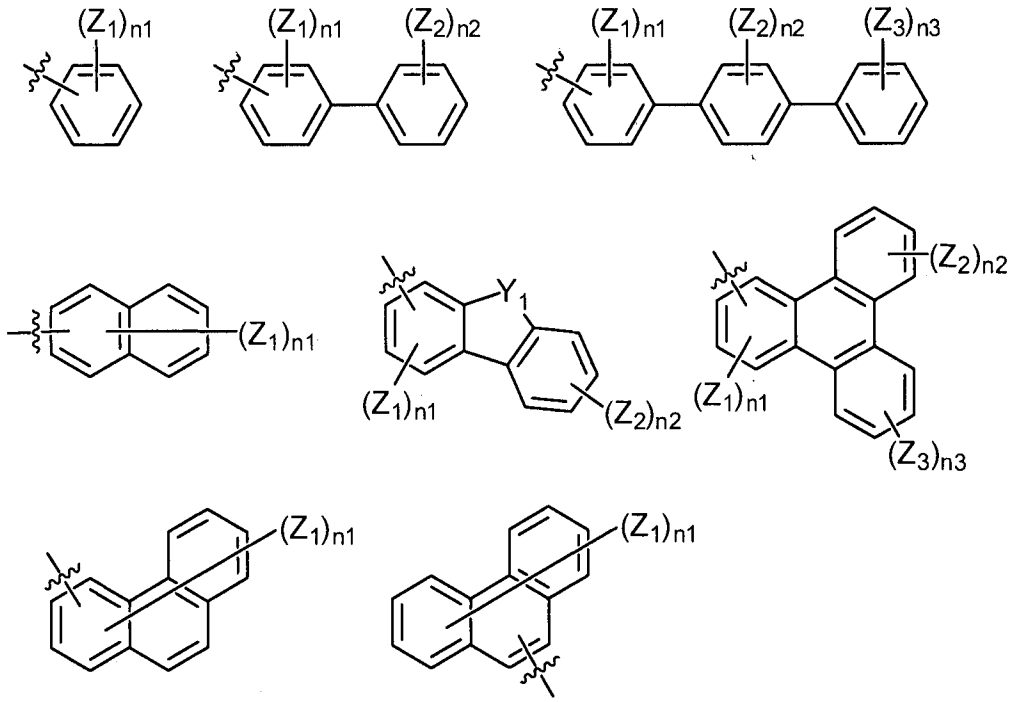
본 명세서에 있어서, 헤테로고리기는 이종 원소로 O, N, Si 및 S 중 1개 이상을 포함하는 헤테로고리기로서, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 2 내지 60인 것이 바람직하다. 헤테로고리기의 예로는 티오펜기, 퓨란기, 피롤기, 이미다졸기, 티아졸기, 옥사졸기, 옥사디아졸기, 트리아졸기, 피리딜기, 비피리딜기, 피리미딜기, 트리아진기, 트리아졸기, 아크리딜기, 피리다진기, 피라지닐기, 퀴놀리닐기, 퀴나졸린기, 퀴녹살리닐기, 프탈라지닐기, 피리도 피리미디닐기, 피리도 피라지닐기, 피라지노 피라지닐기, 이소퀴놀린기, 인돌기, 카바졸기, 벤조옥사졸기, 벤조이미다졸기, 벤조티아졸기, 벤조카바졸기, 벤조티오펜기, 디벤조티오펜기, 벤조퓨라닐기,

페난쓰롤린기(phenanthroline), 티아졸릴기, 이소옥사졸릴기, 옥사디아졸릴기, 티아디아졸릴기, 벤조티아졸릴기, 페노티아지닐기 및 디벤조퓨라닐기 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 아르알케닐기, 알킬아릴기, 아릴아민기 중의 아릴기는 전술한 아릴기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아르알킬기, 알킬아릴기, 알킬아민기 중 알킬기는 전술한 알킬기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴아민 중 헤테로아릴은 전술한 헤테로고리기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 아르알케닐기 중 알케닐기는 전술한 알케닐기의 예시와 같다. 본 명세서에 있어서, 아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 아릴기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로아릴렌은 2가기인 것을 제외하고는 전술한 헤테로고리기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 탄화수소 고리는 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 아릴기 또는 사이클로알킬기에 관한 설명이 적용될 수 있다. 본 명세서에 있어서, 헤테로고리는 1가기가 아니고, 2개의 치환기가 결합하여 형성한 것을 제외하고는 전술한 헤테로고리기에 관한 설명이 적용될 수 있다.

한편, 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 제공한다.

상기 화학식 1에서, A 및 B는 각각 독립적으로, 수소, 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다. 즉, 상기 화학식 1에서, A 및 B 중 하나가 수소이고 나머지 하나가 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나이거나, A 및 B 모두가 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:



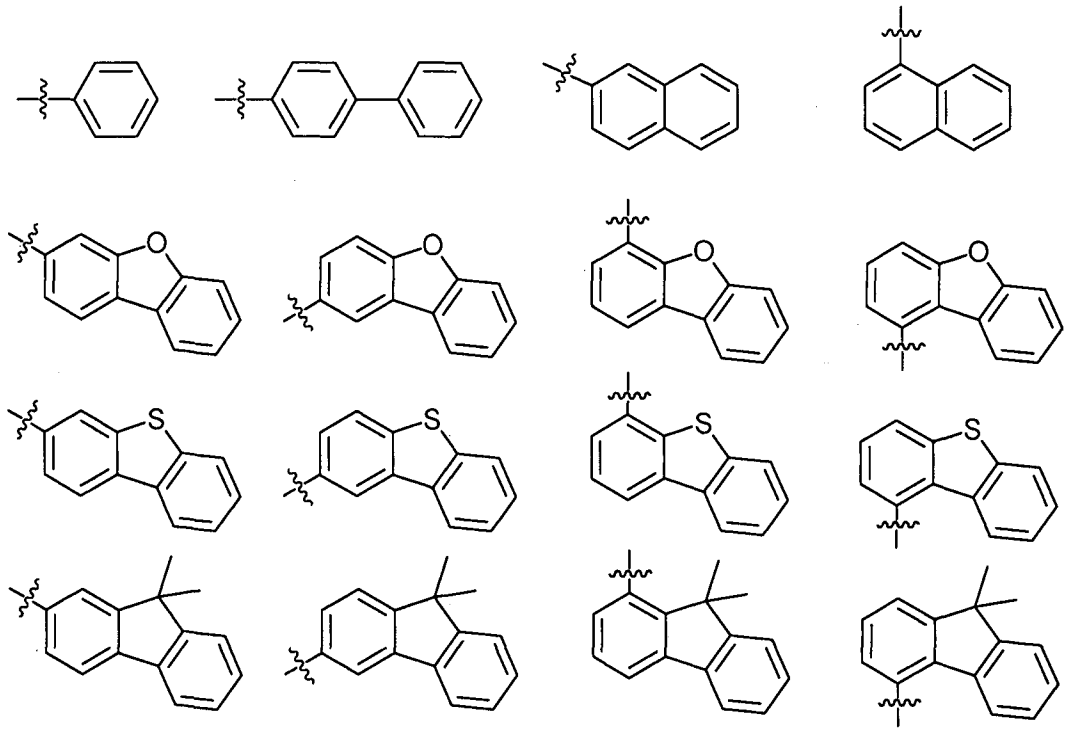
상기에서,

Y_1은 O, S, 또는 CZ_4Z_5이고,

Z_1 내지 Z_5는 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로겐; 시아노; 니트로; 아미노; C_{1-20} 알킬; C_{1-20} 할로알킬; C_{6-20} 아릴; O 또는 S의 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴이고,

n1 내지 n3는 각각 독립적으로, 0 내지 3의 정수이다.

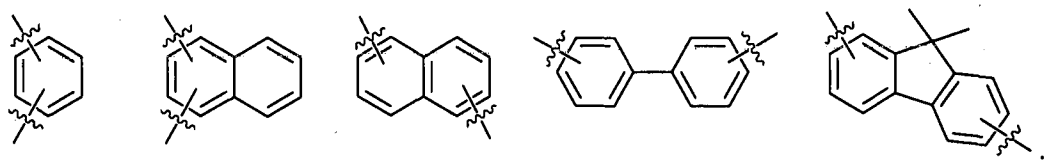
예를 들어, A 및 B는 각각 독립적으로, 수소, 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:



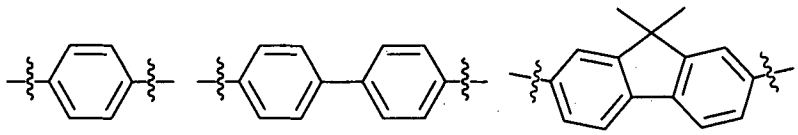
구체적으로, 상기 화학식 1에서, A 및 B가 모두 수소인 화합물을 전자억제층 또는 정공수송층으로 사용하여 제조된 유기 발광 소자의 경우, 효율이 10% 이상, 수명은 30% 이상 떨어지는 한계가 있다. 이에 따라, 상기 화학식 1에서, A 및 B가 각각 독립적으로, 수소, 또는 상기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나를 만족할 경우, 소자의 효율을 높여주는 동시에 안정성이 크게 증가할 수 있다.

또한, L은 단일 결합, 치환 또는 비치환된 페닐렌, 치환 또는 비치환된 바이페닐렌, 치환 또는 비치환된 나프틸렌, 치환 또는 비치환된 페난트레닐렌, 치환 또는 비치환된 안트라세닐렌, 치환 또는 비치환된 플루오란테닐렌, 치환 또는 비치환된 트리페닐레닐렌, 치환 또는 비치환된 파이레닐렌, 치환 또는 비치환된 카바졸일렌, 치환 또는 비치환된 플루오레닐렌, 또는 치환 또는 비치환된 스파이로-플루오레닐렌일 수 있다.

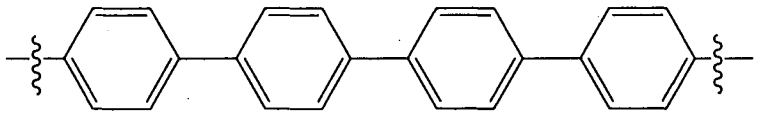
예를 들어, L은 단일 결합, 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:



구체적으로 예를 들어, L은 단일 결합, 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:

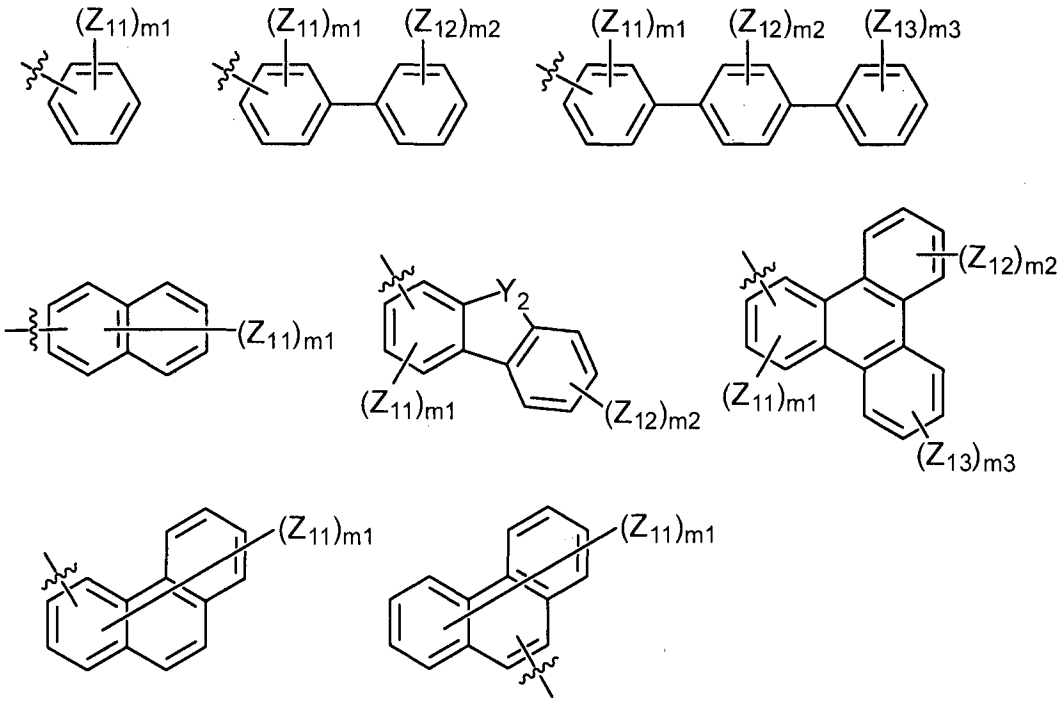


상기 L이 하기와 같이 긴 사슬을 가질 경우, 상기 화학식1에서 코어와 아릴아민기 사이의 거리가 너무 멀어짐에 따라, 유기 발광 소자의 특성이 크게 나빠질 수 있다:



또한, Ar_1 및 Ar_2는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C_{6-20} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 O 또는 S의 헤테로원자를 1개 내지 3개 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴일 수 있다.

예를 들어, Ar_1 및 Ar_2는 각각 독립적으로, 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:



상기에서,

Y_2는 O, S, 또는 $CZ_{14}Z_{15}$이고,

Z_{11} 내지 Z_{15}는 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로겐; 시아노; 니트로; 아미노; 실릴; C_{1-20} 알킬; C_{1-20} 할로알킬; C_{6-20} 아릴; O 또는 S의 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴이되, Z_{14} 및 Z_{15}는 서로 연결되어 단환 또는 다환의 고리를 형성할 수 있고,

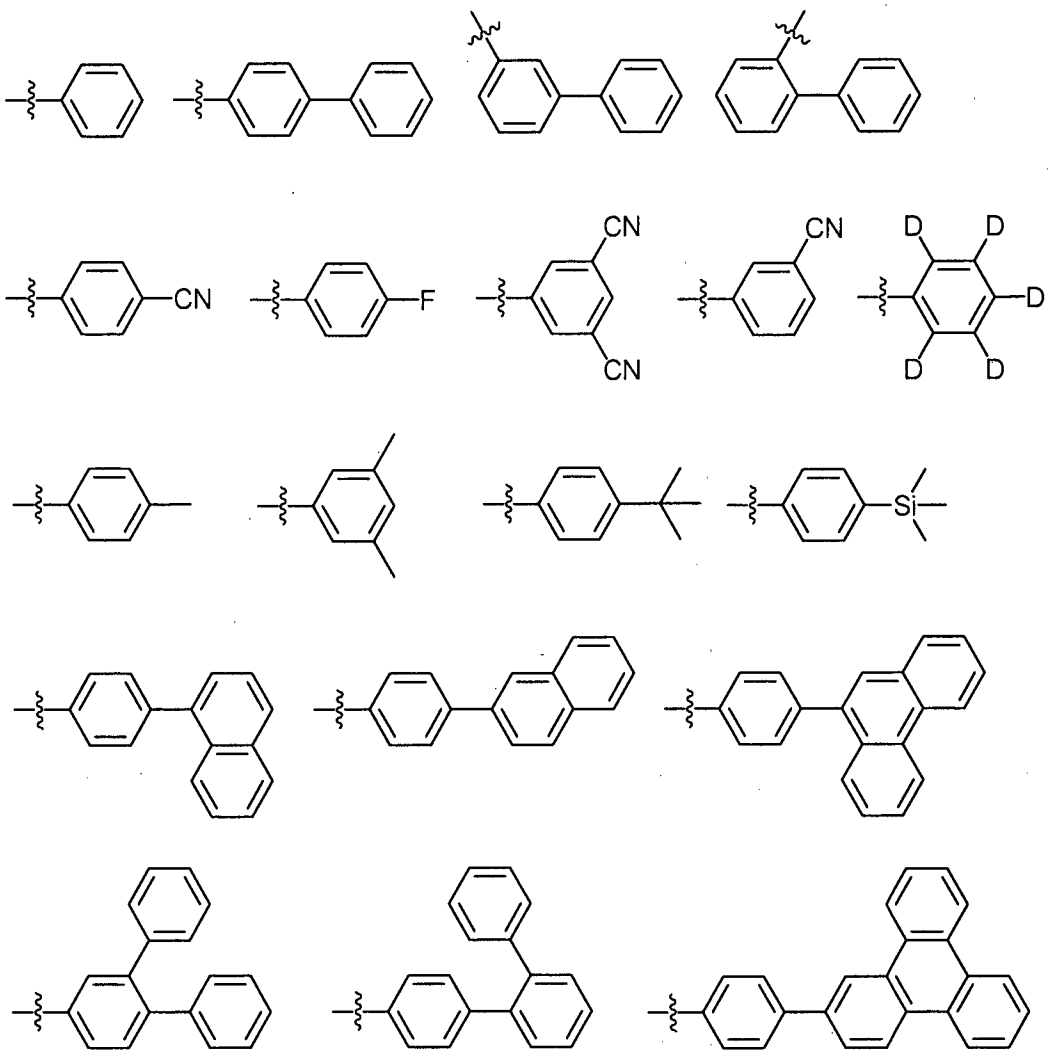
m1 내지 m3는 각각 독립적으로, 0 내지 3의 정수이다.

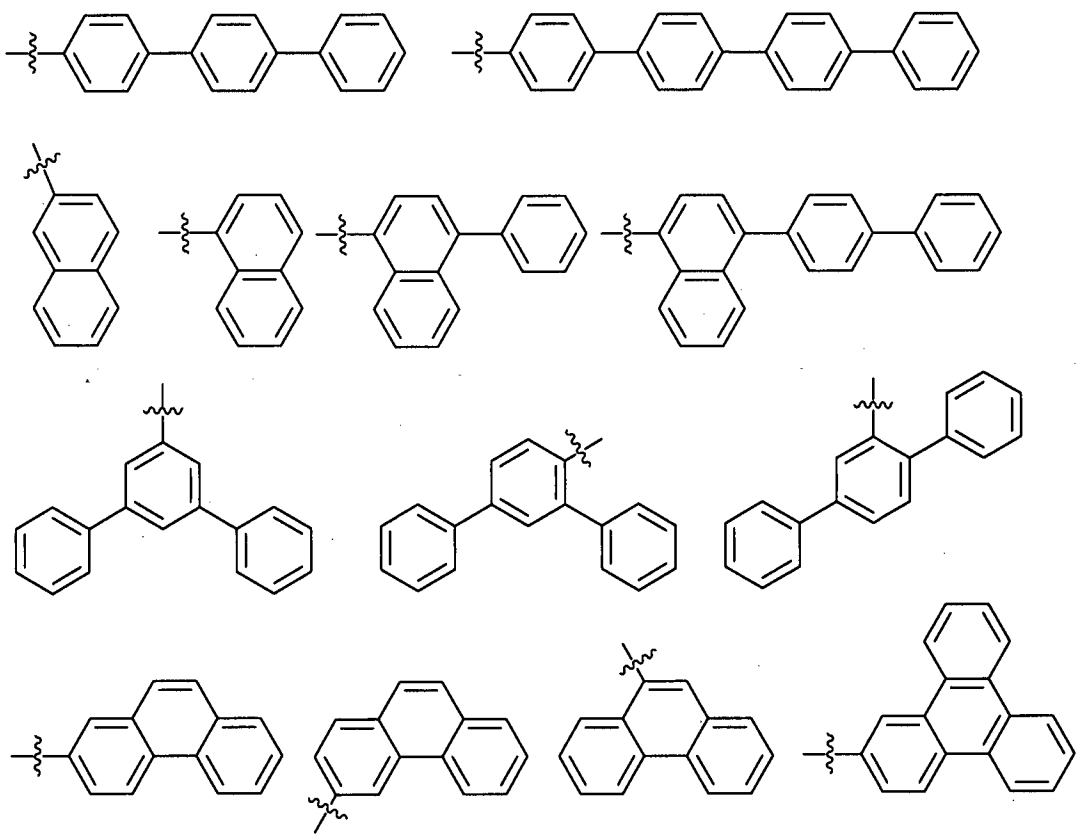
이때, Z_{11} 내지 Z_{13}은 각각 독립적으로, 수소, 중수소, 할로겐, 시아노, 트리메틸실릴, 메틸, tert-부틸, 페닐, 나프틸, 트리페닐레닐, 디벤조퓨라닐, 또는 디벤조티오페닐이고,

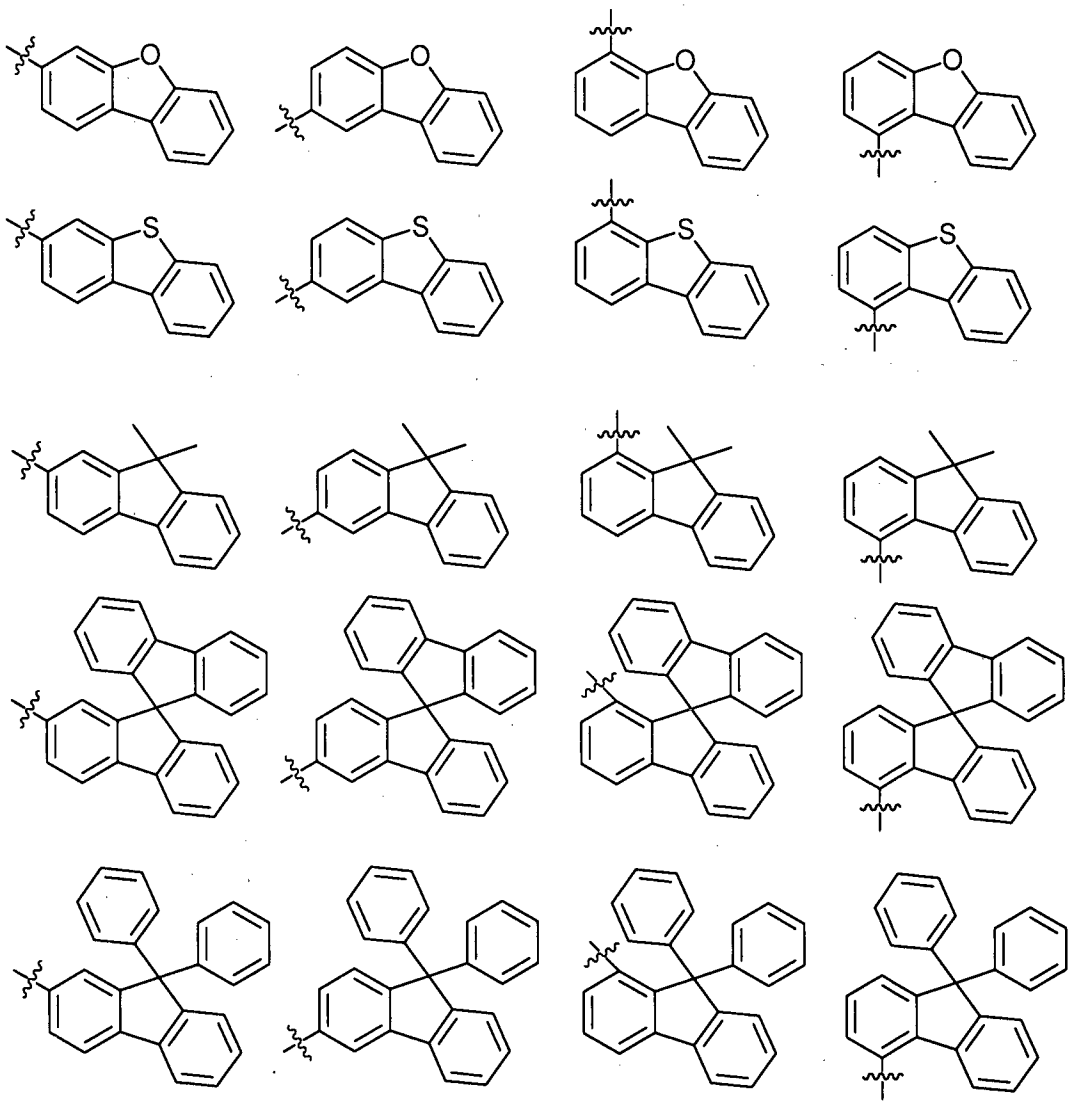
Z_{14} 및 Z_{15}는 각각 독립적으로, 메틸이거나, 또는 서로 연결되어 단환 또는 다환의 고리를 형성하고,

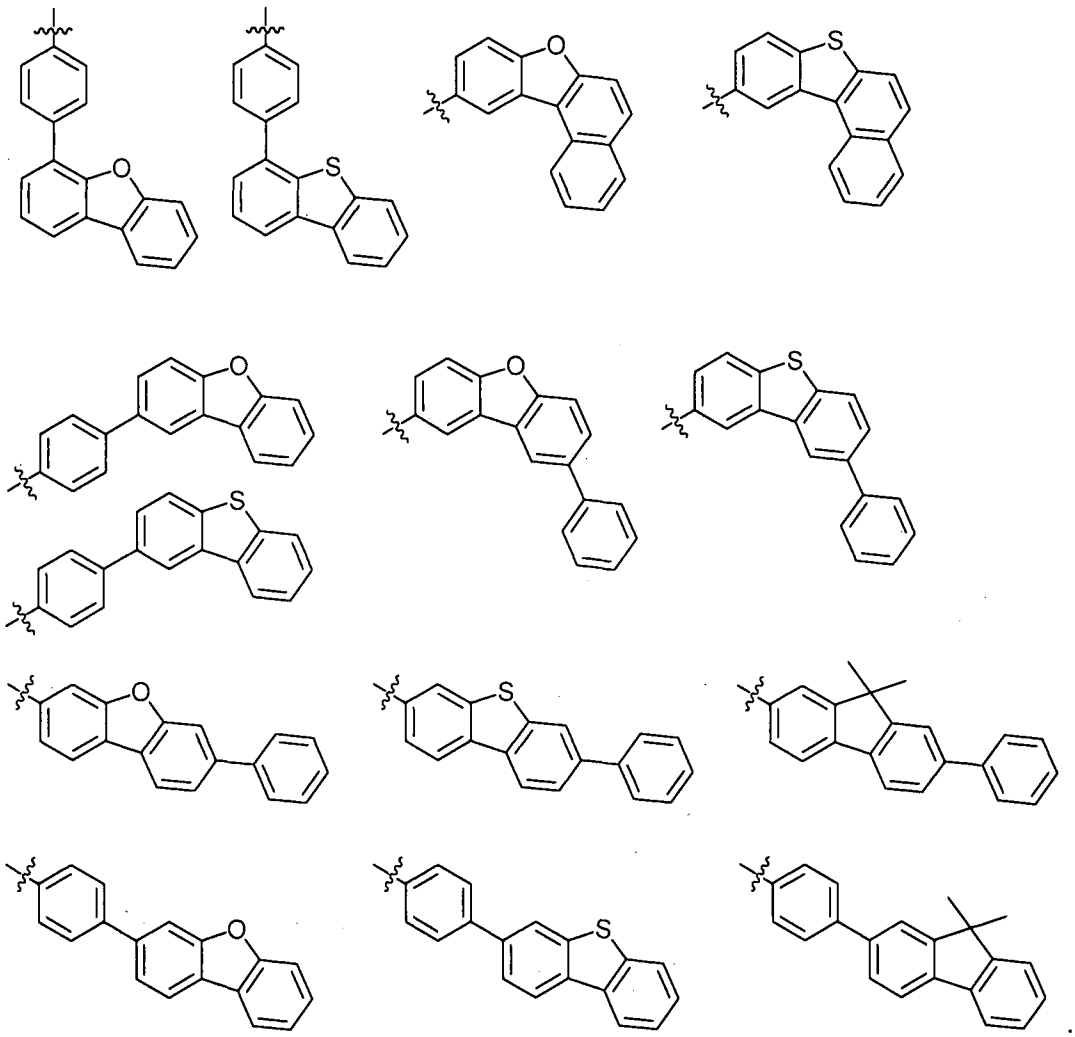
m1 내지 m3는 각각 독립적으로, 0, 또는 1이다.

구체적으로 예를 들어, Ar_1 및 Ar_2는 각각 독립적으로, 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:


CN
F
CN
CN
CN
D
D
D
D
D
Si







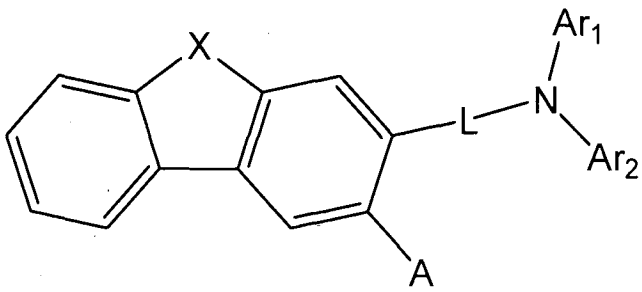
또한, R_1은 수소; 중수소; 할로겐; 시아노; 니트로; C_{1-20} 알킬; 또는 C_{6-20} 아릴일 수 있다.

예를 들어, R_1은 수소, 중수소, 할로겐, 시아노, 니트로, 메틸, 또는 페닐일 수 있고, a1은 0 또는 1일 수 있다.

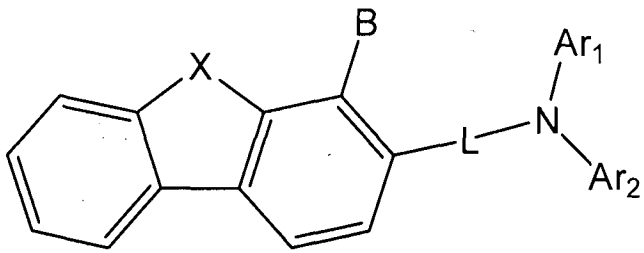
이때, a1은 R_1의 개수를 나타낸 것으로서, a1이 2 이상일 경우, 2 이상의 R_1은 서로 동일하거나 상이할 수 있다. n1 내지 n3 및 m1 내지 m3에 대한 설명은 상기 a1에 대한 설명 및 상기 화학식 1의 구조를 참조하여 이해될 수 있다.

한편, 상기 화합물은 하기 화학식 1A 또는 1B로 표시될 수 있다:

[화학식 1A]



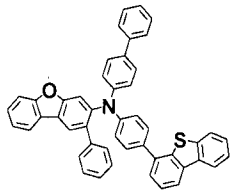
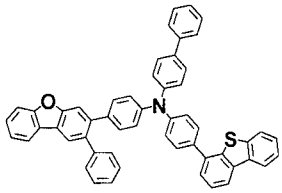
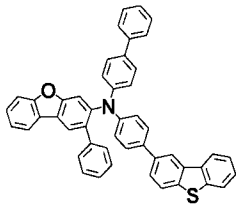
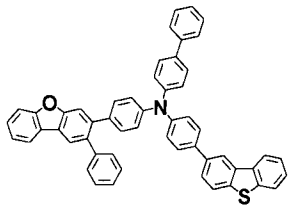
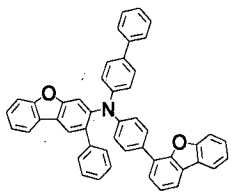
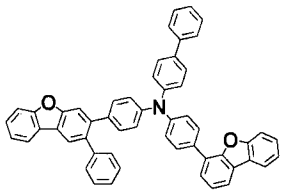
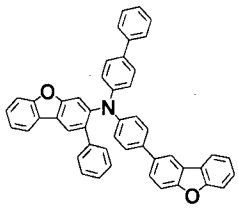
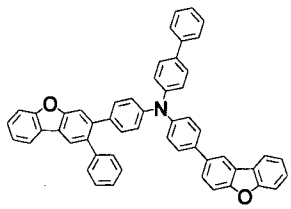
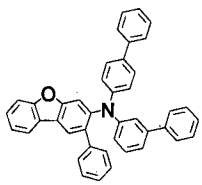
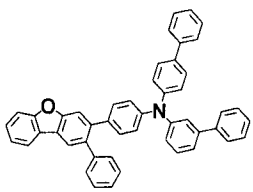
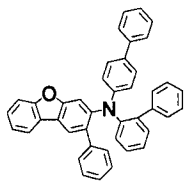
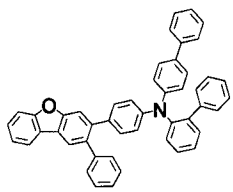
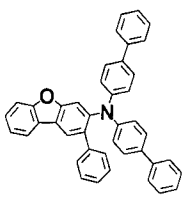
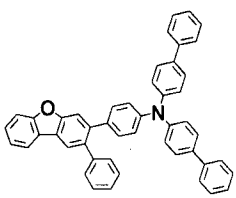
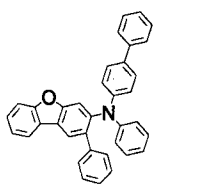
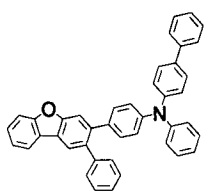
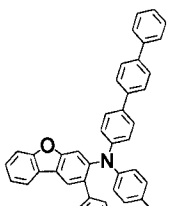
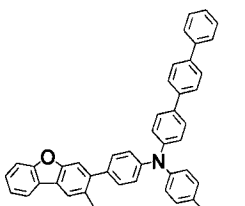
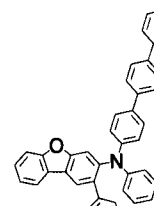
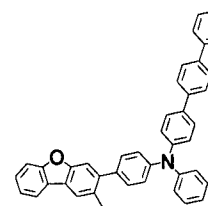
[화학식 1B]

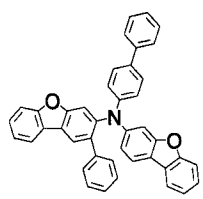
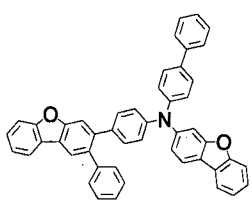
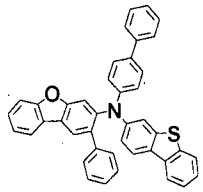
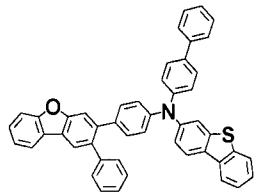
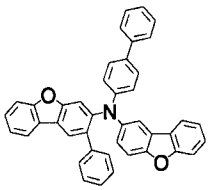
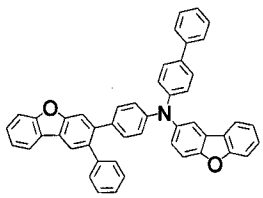
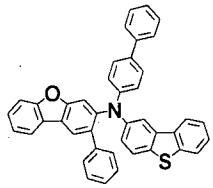
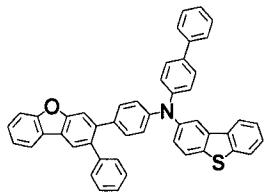
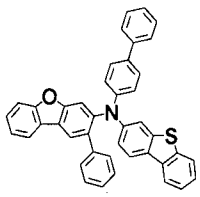
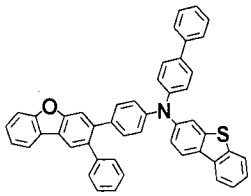
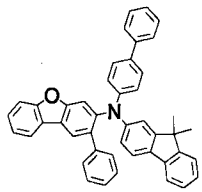
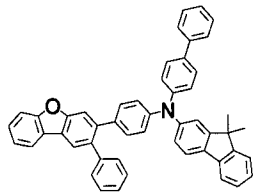
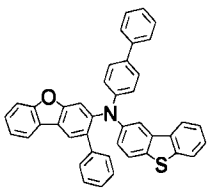
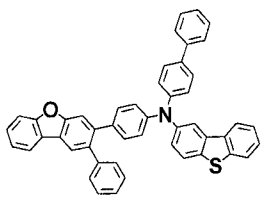
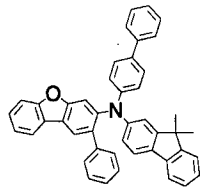
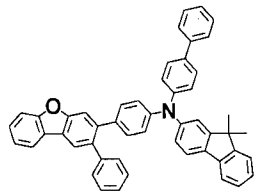
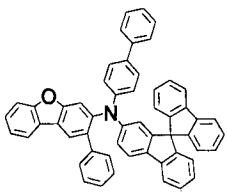
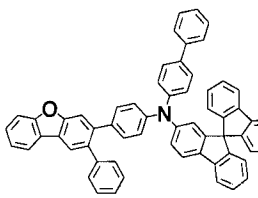
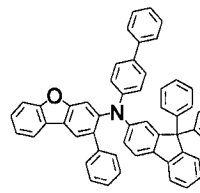
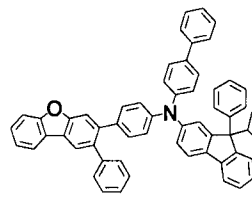


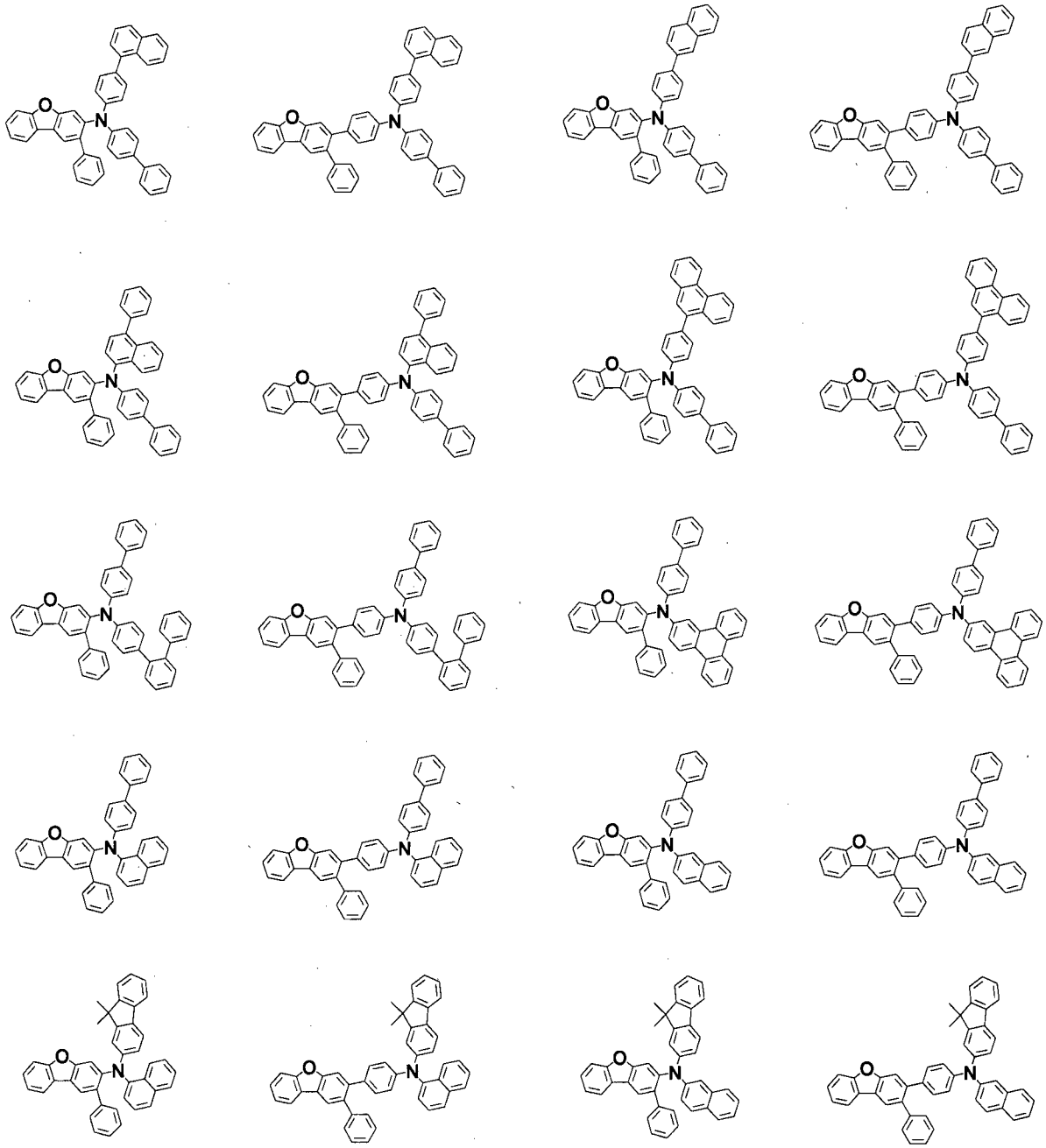
상기 화학식 1A 및 1B 에서,

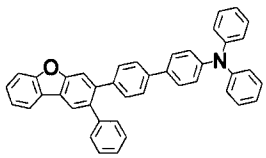
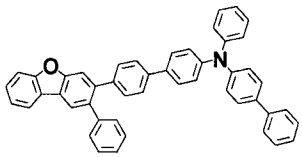
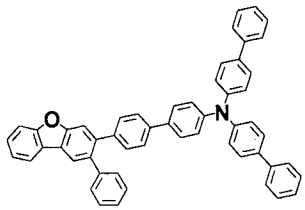
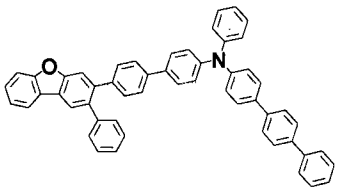
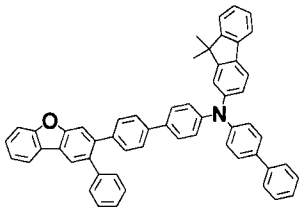
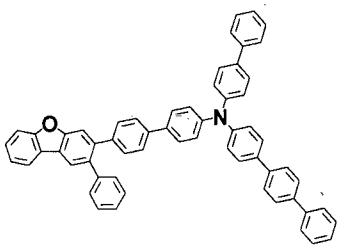
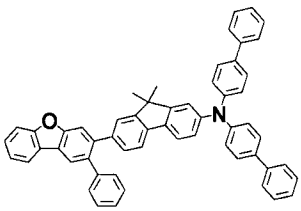
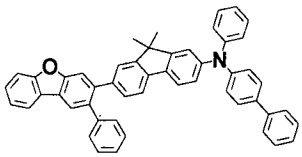
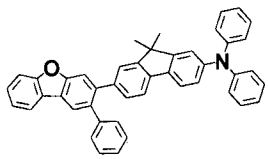
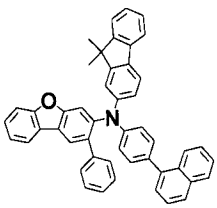
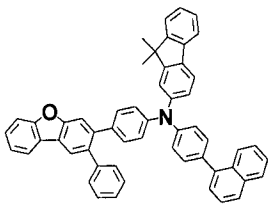
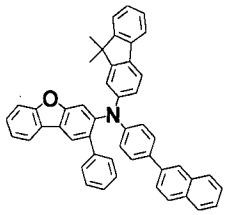
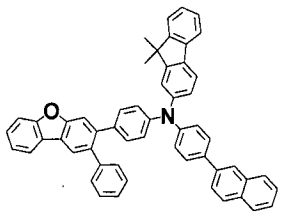
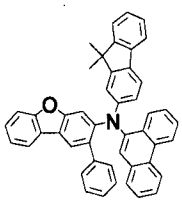
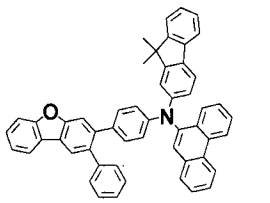
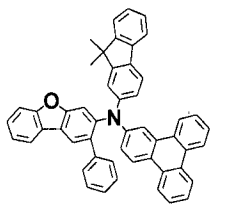
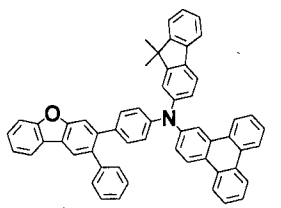
X, A, B, L, Ar_1 및 Ar_2에 대한 설명은 상기 화학식 1에서 정의한 바와 같다.

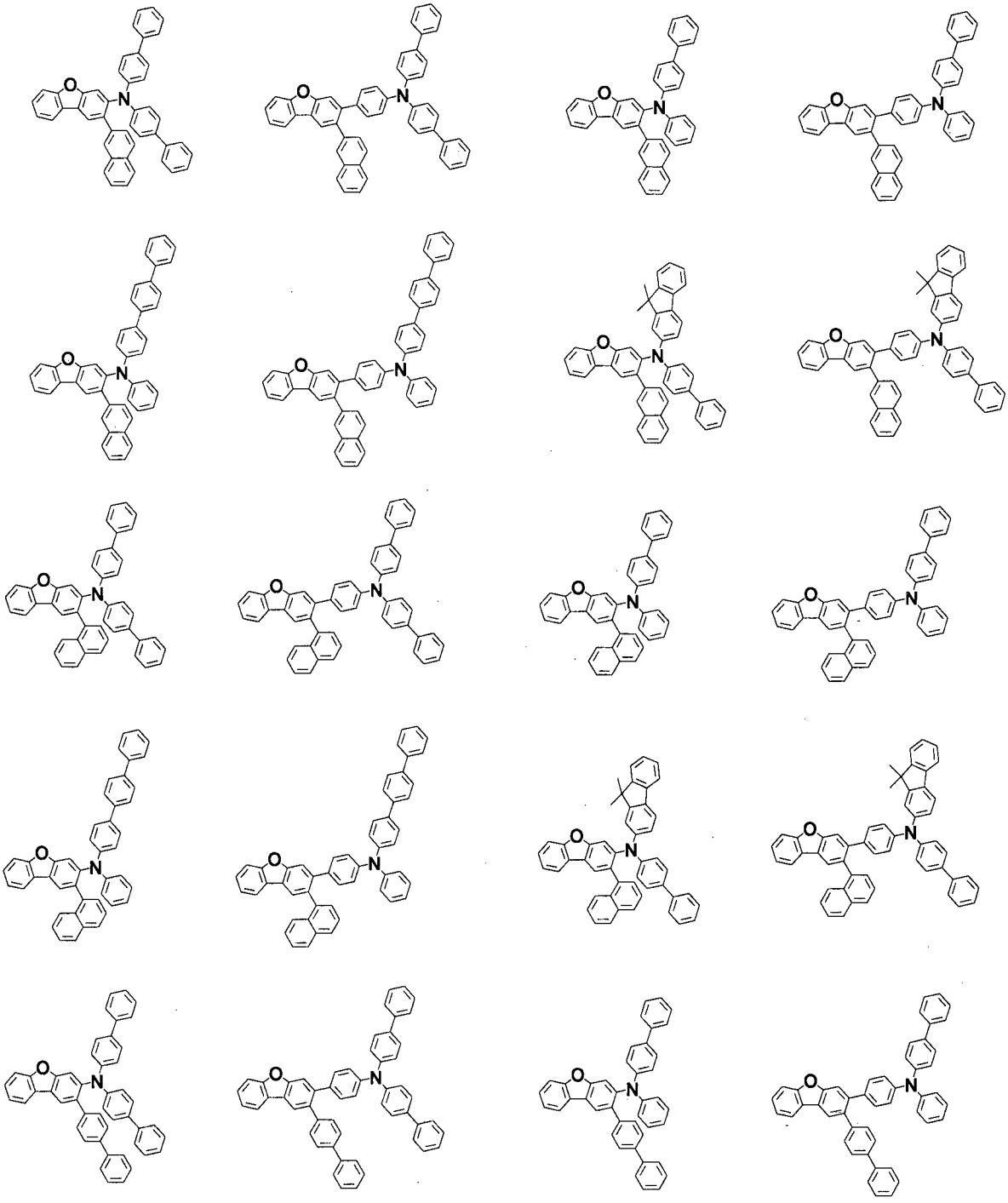
예를 들어, 상기 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나일 수 있다:

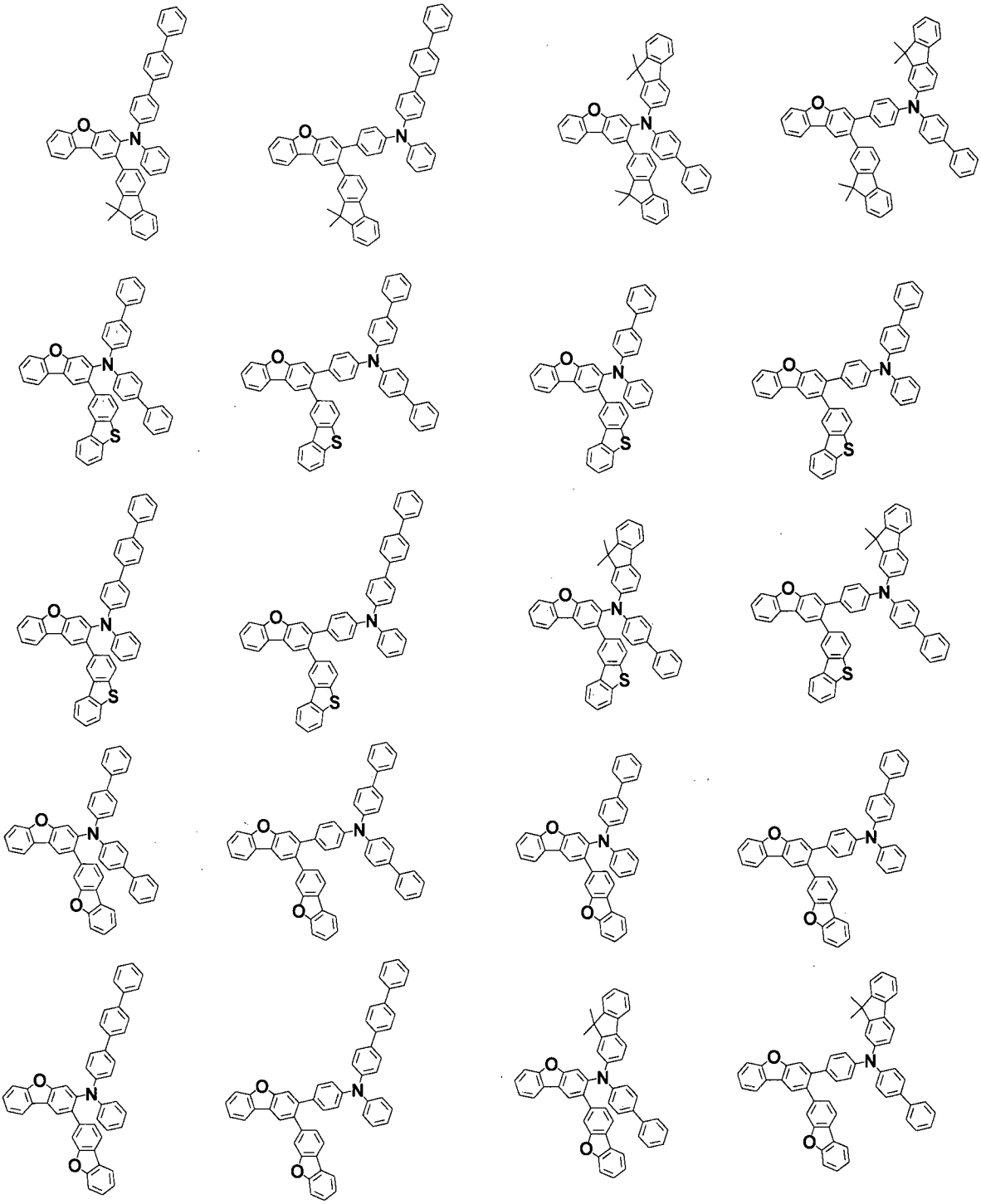





















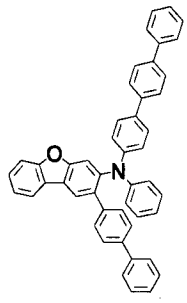
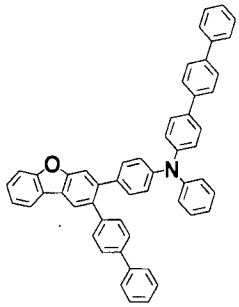
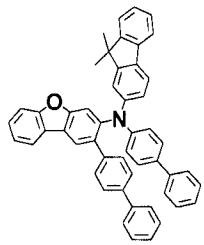
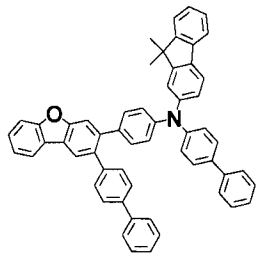
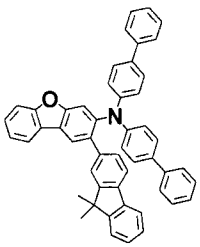
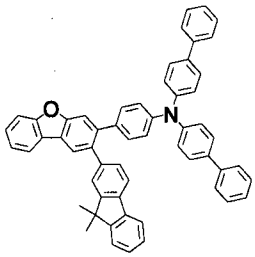
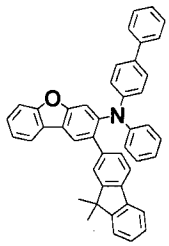
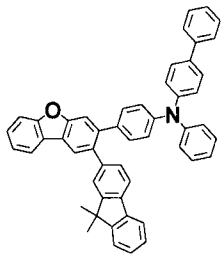
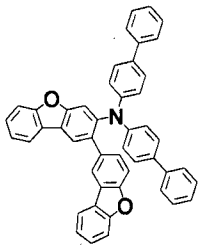
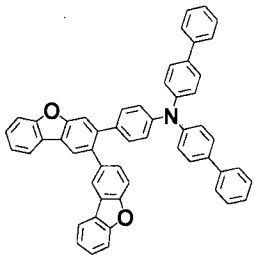
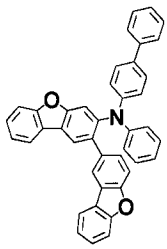
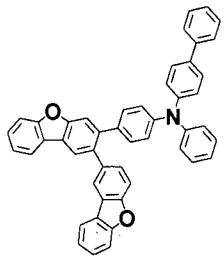
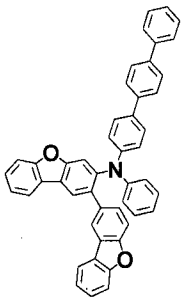
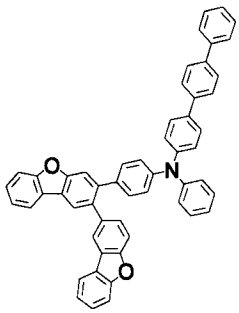
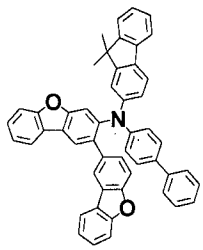
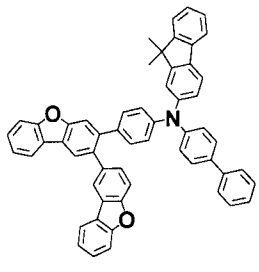





















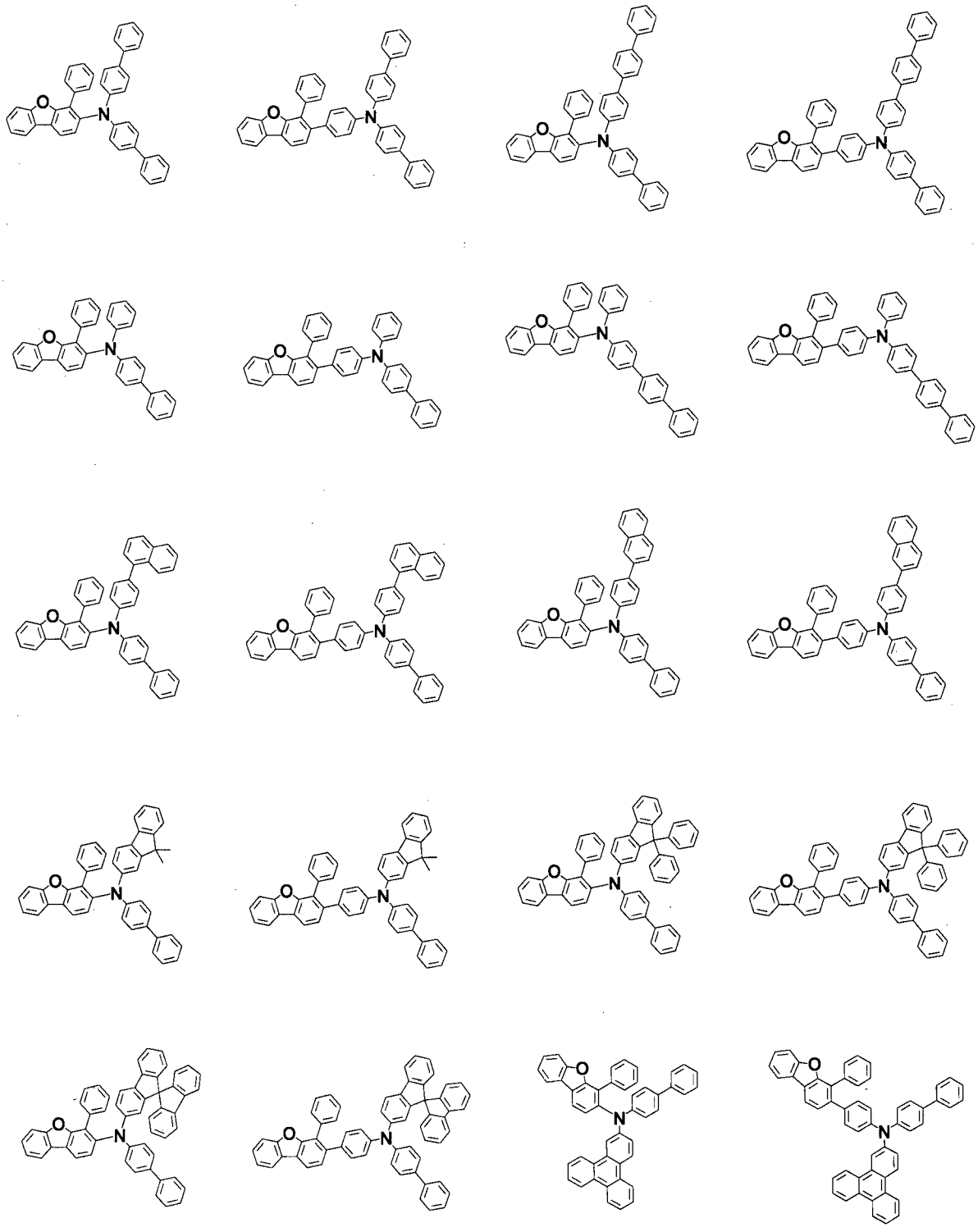


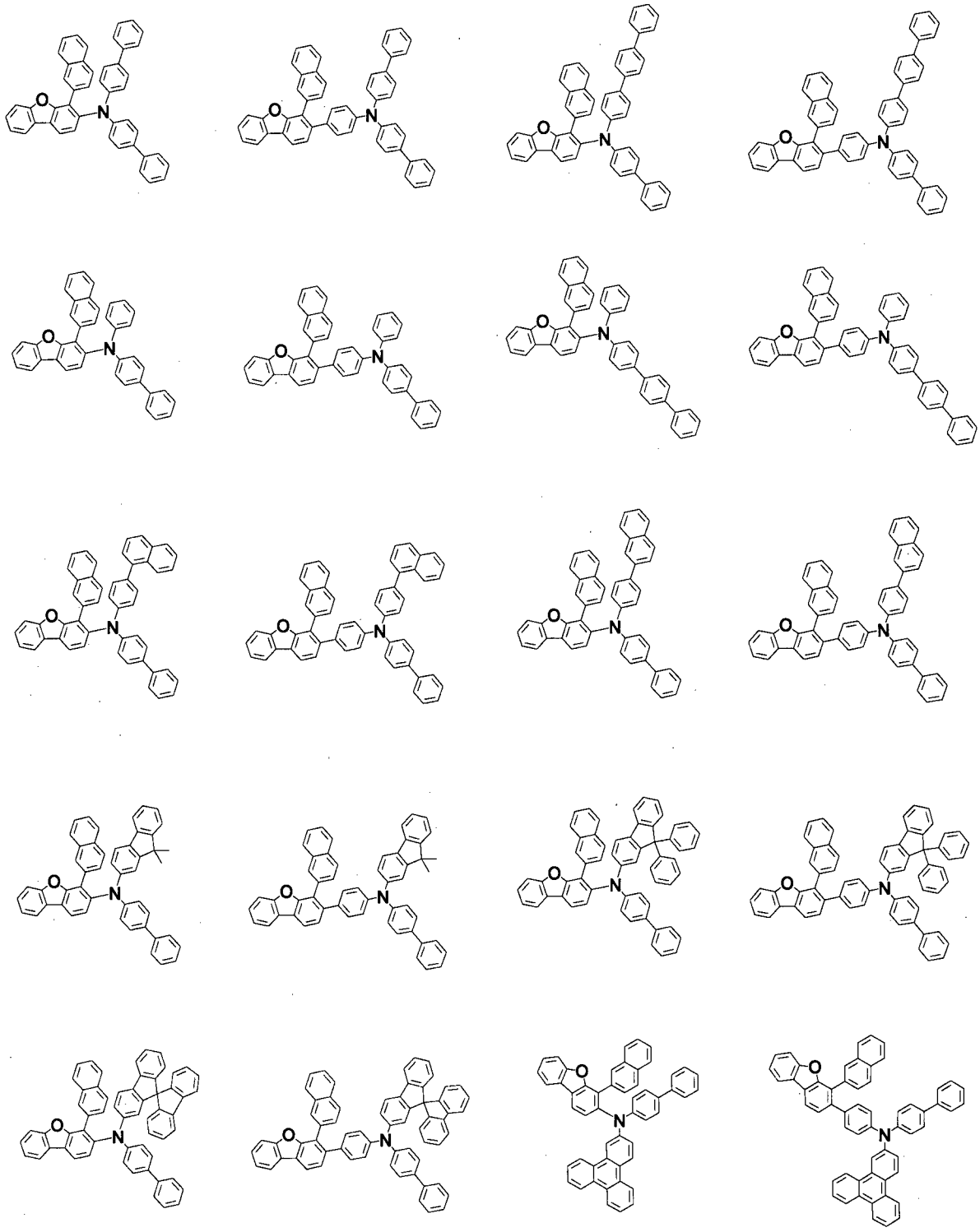


















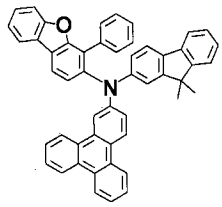
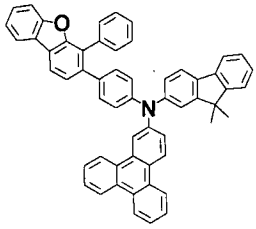
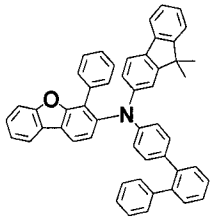
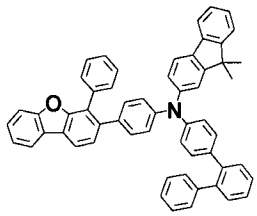
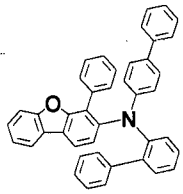
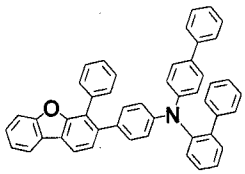
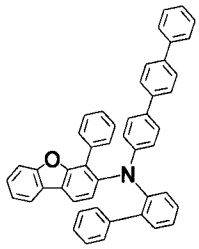
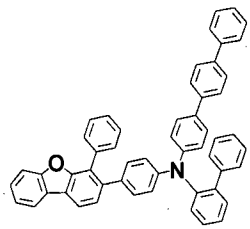
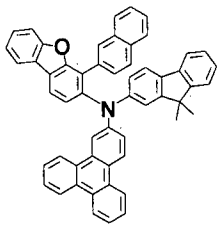
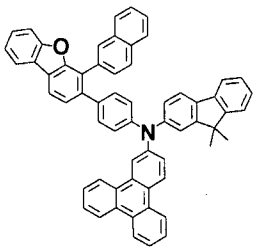
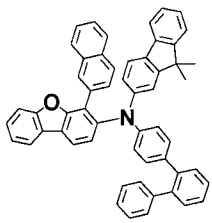
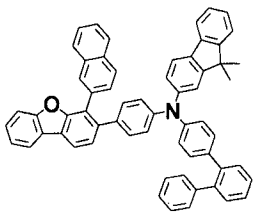
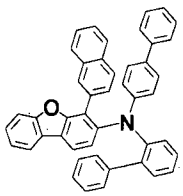
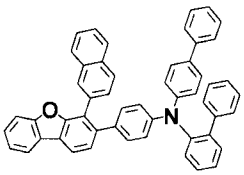
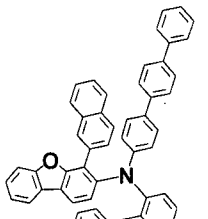
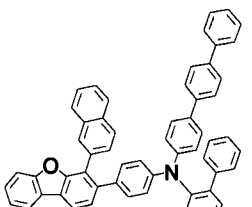


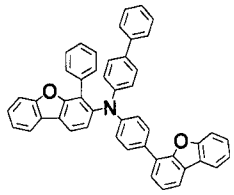
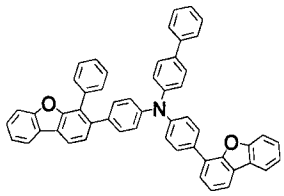
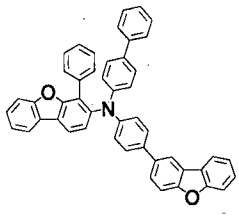
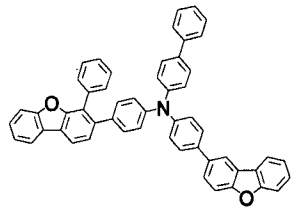
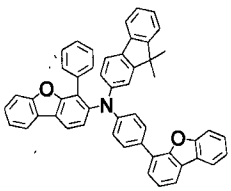
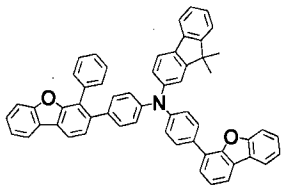
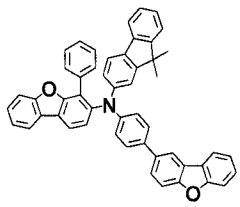
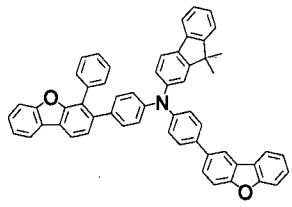
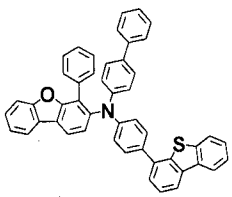
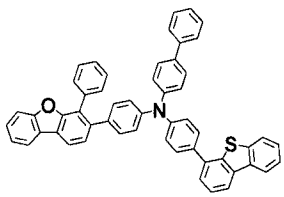
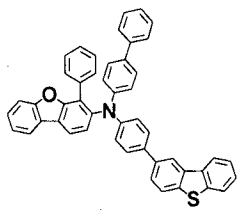
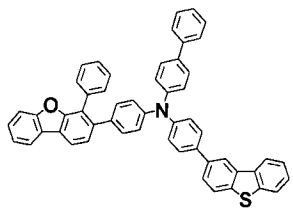
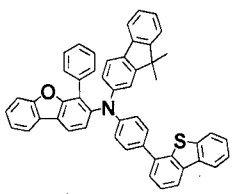
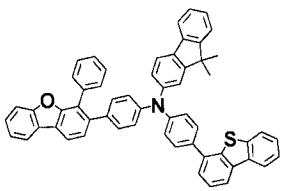
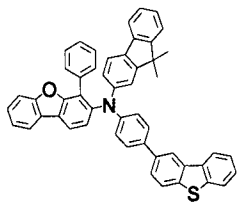
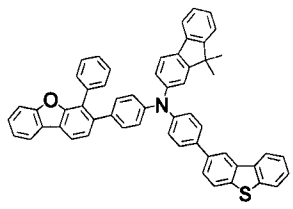
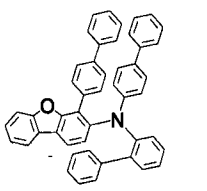


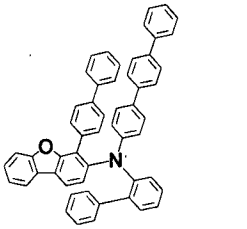
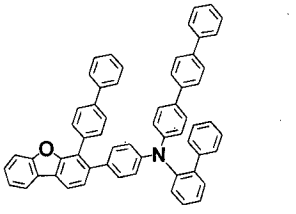

















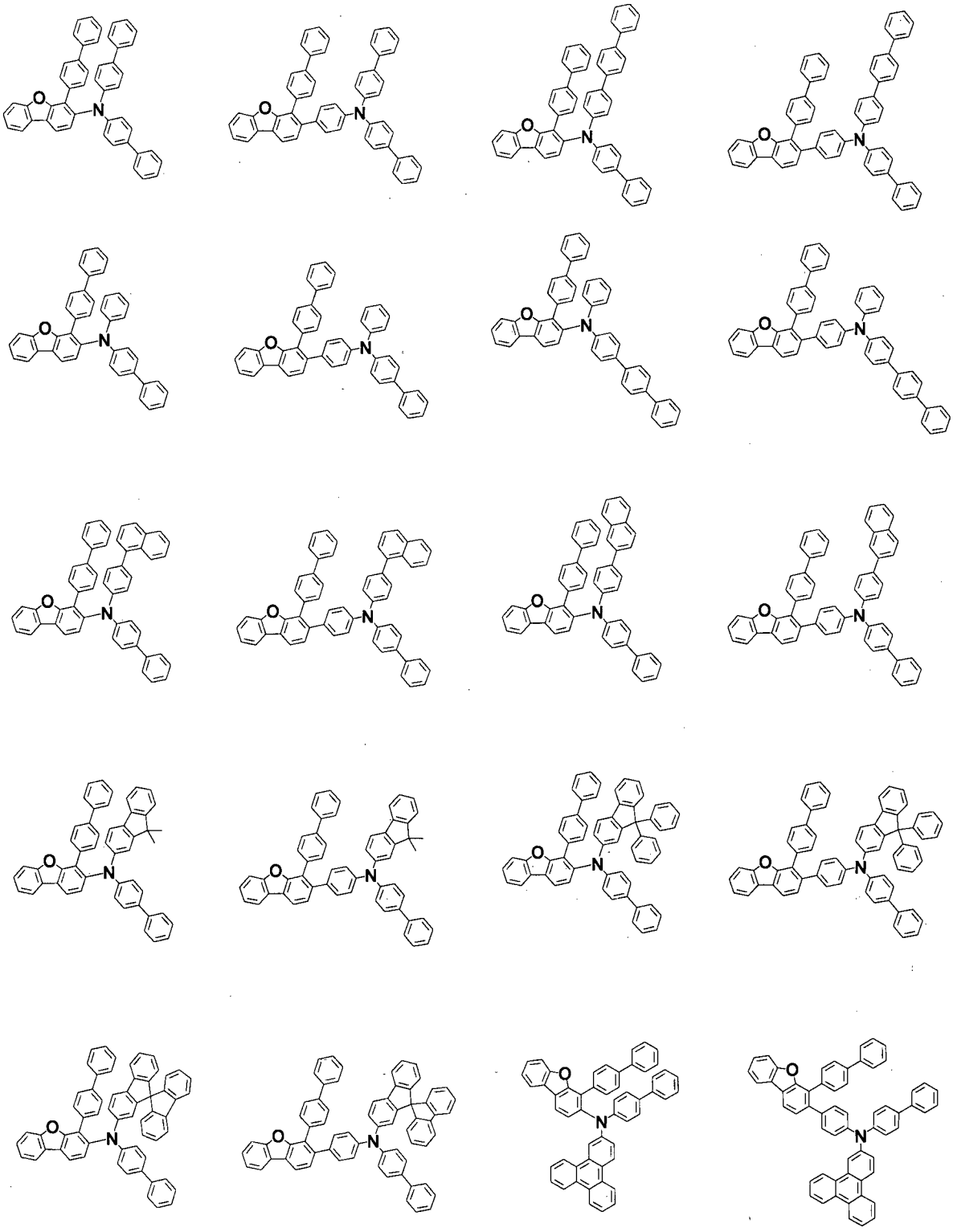


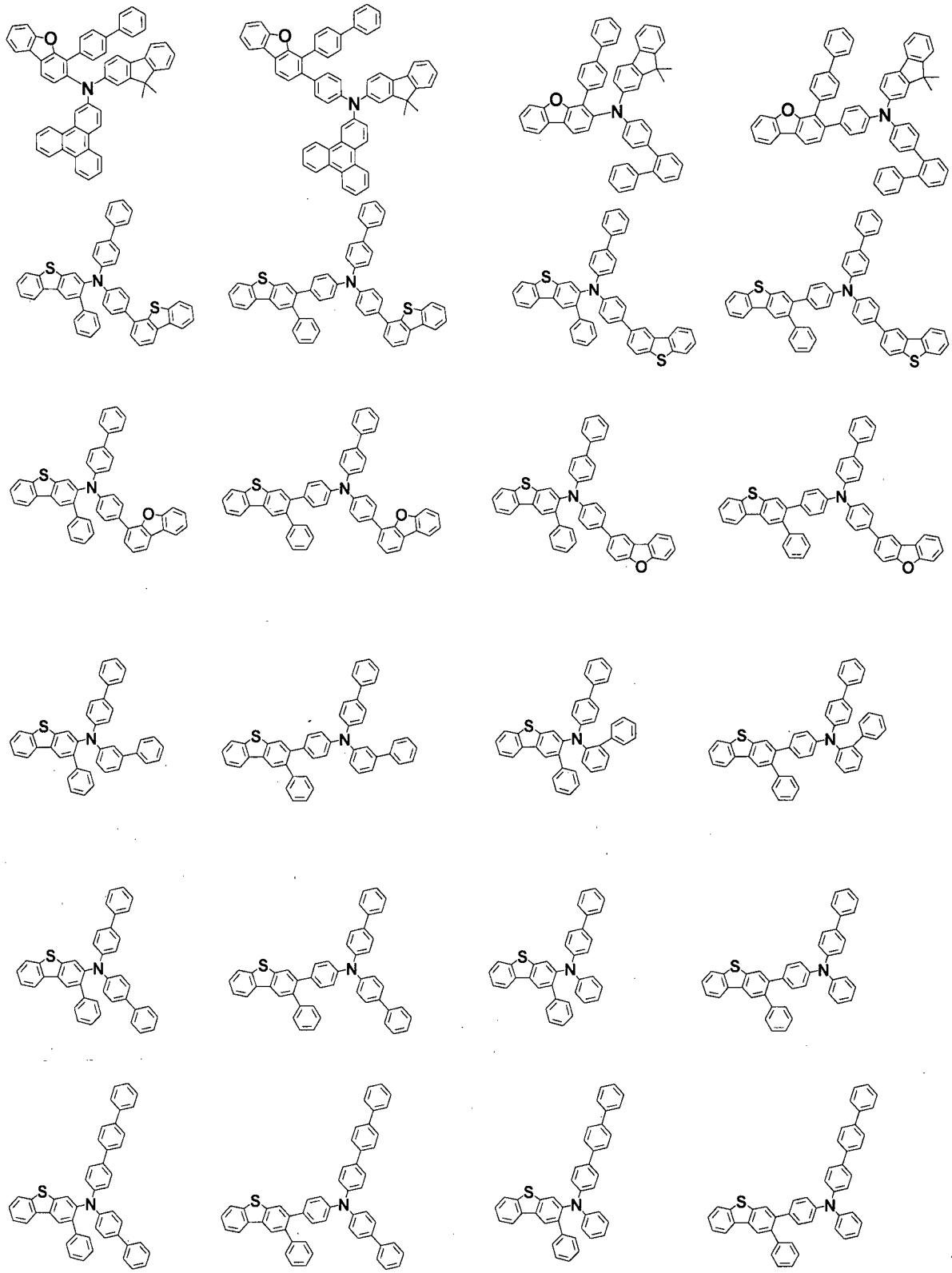


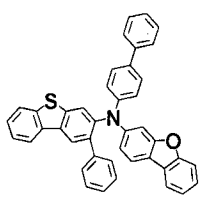
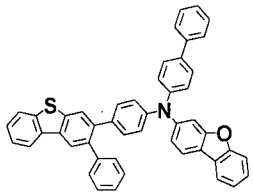
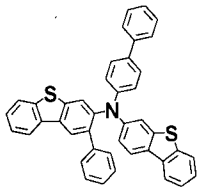
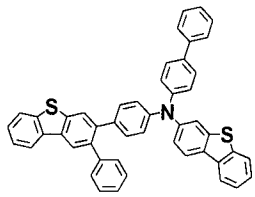
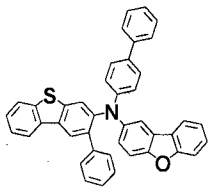
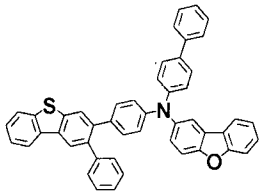
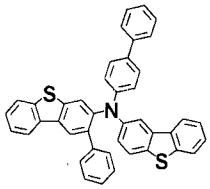
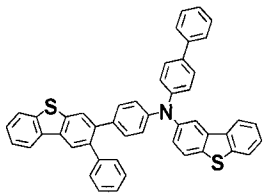
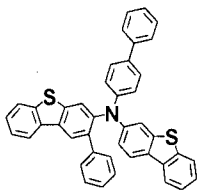
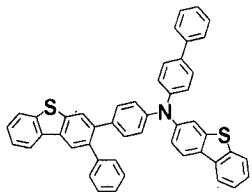
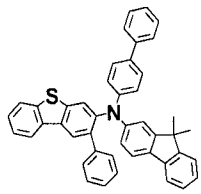
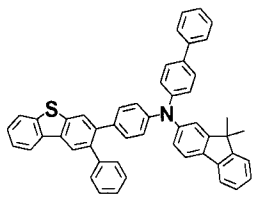
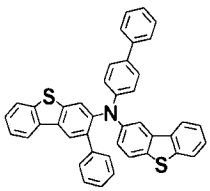
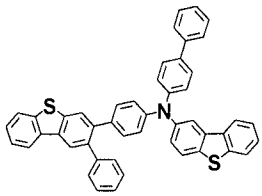
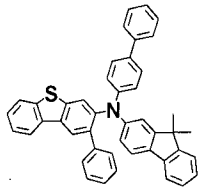
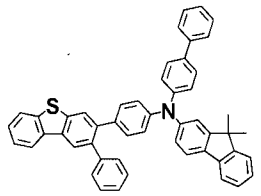
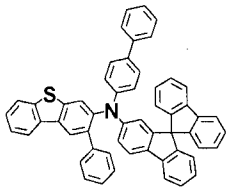
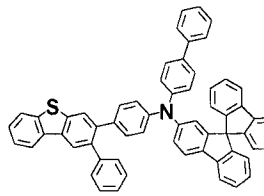
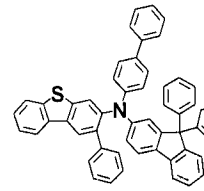
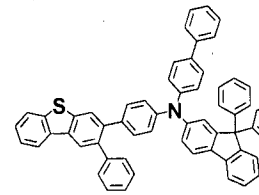

















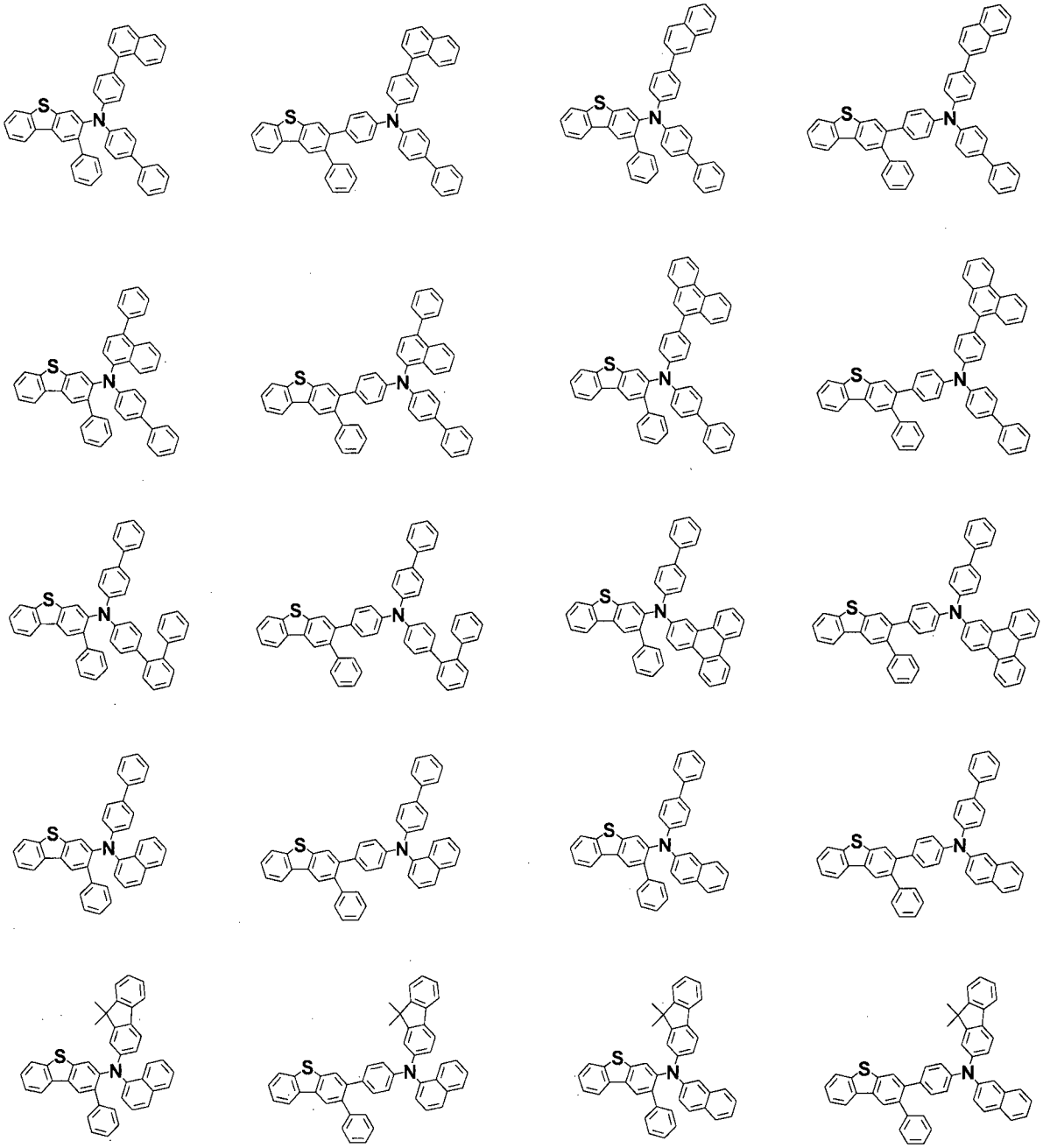


















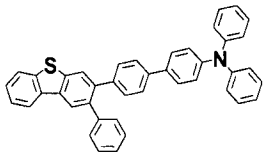
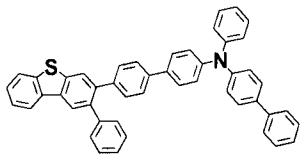
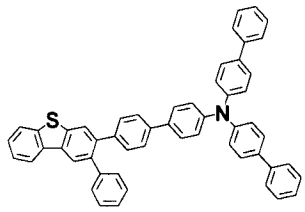
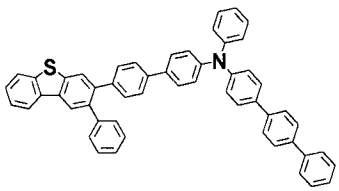
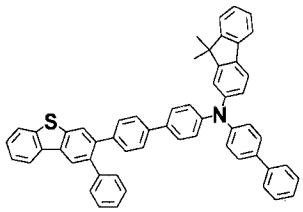
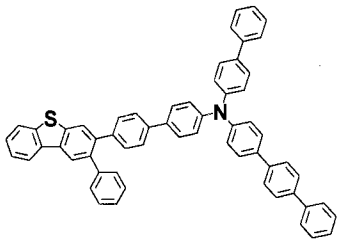
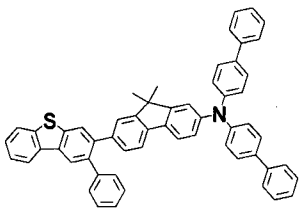
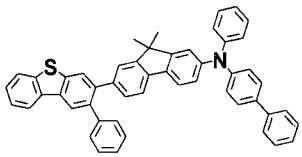
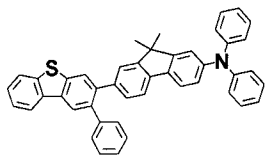
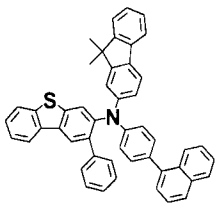
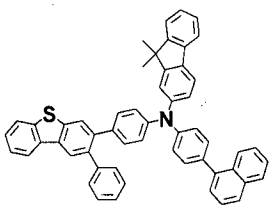
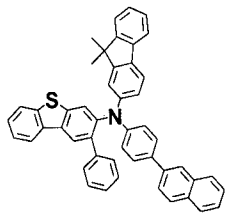
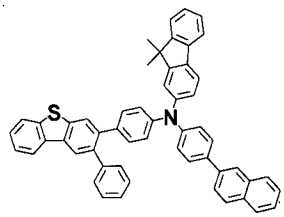
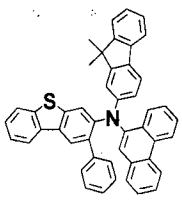
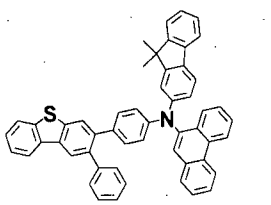
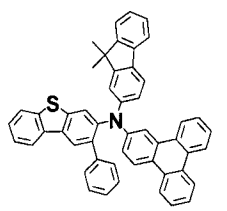
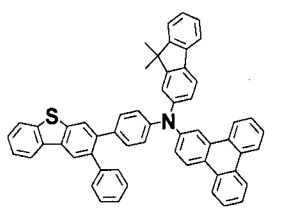



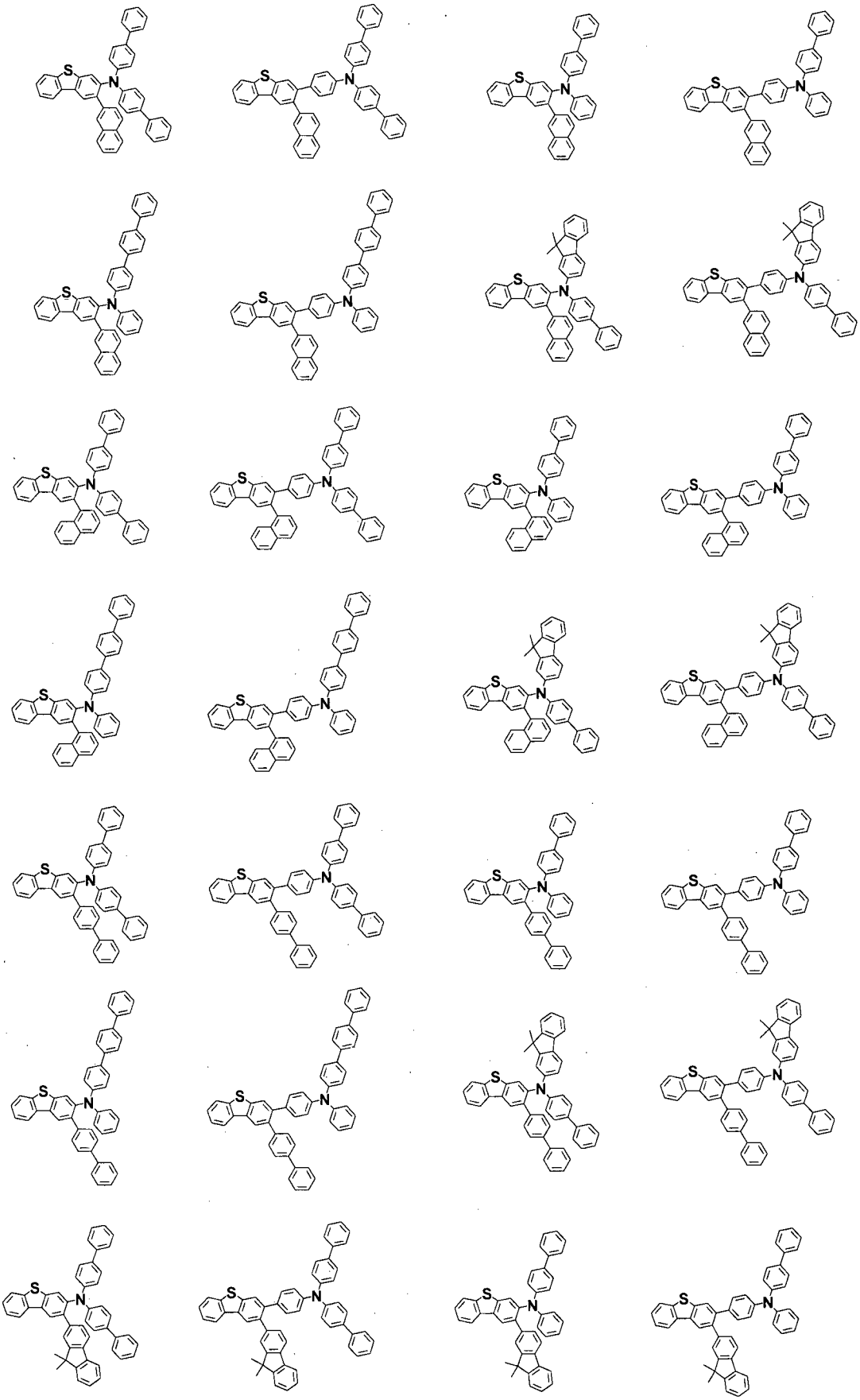


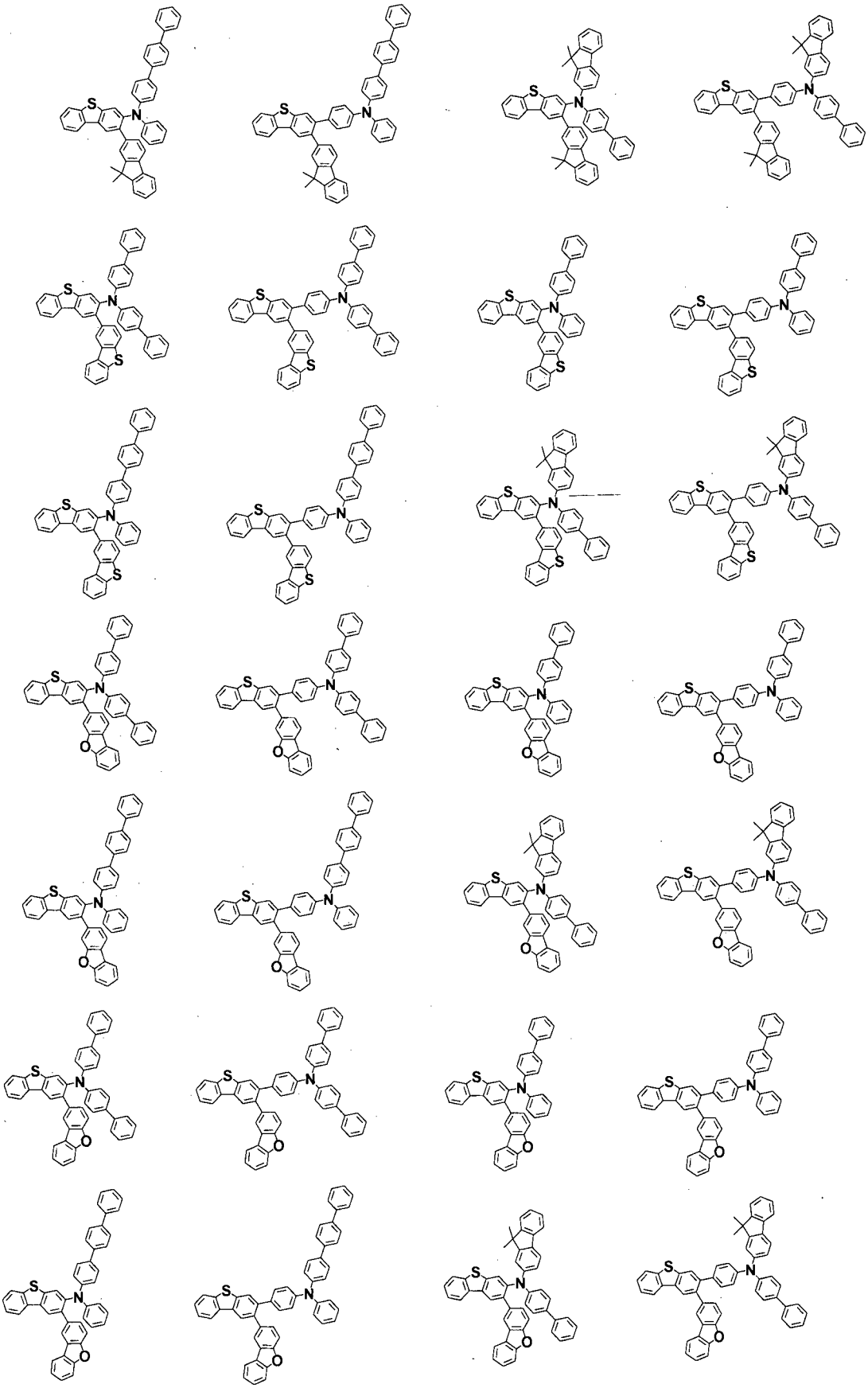


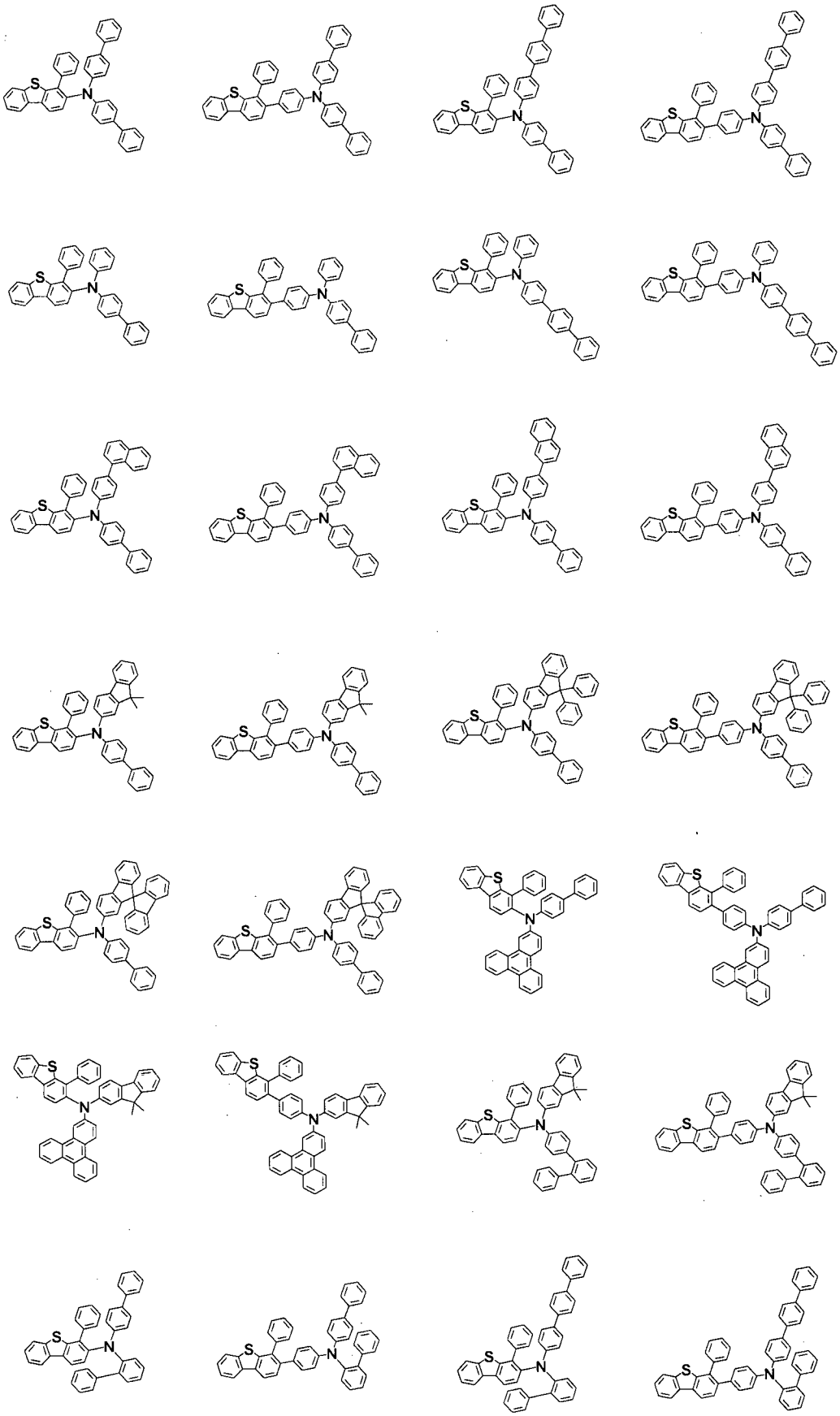





















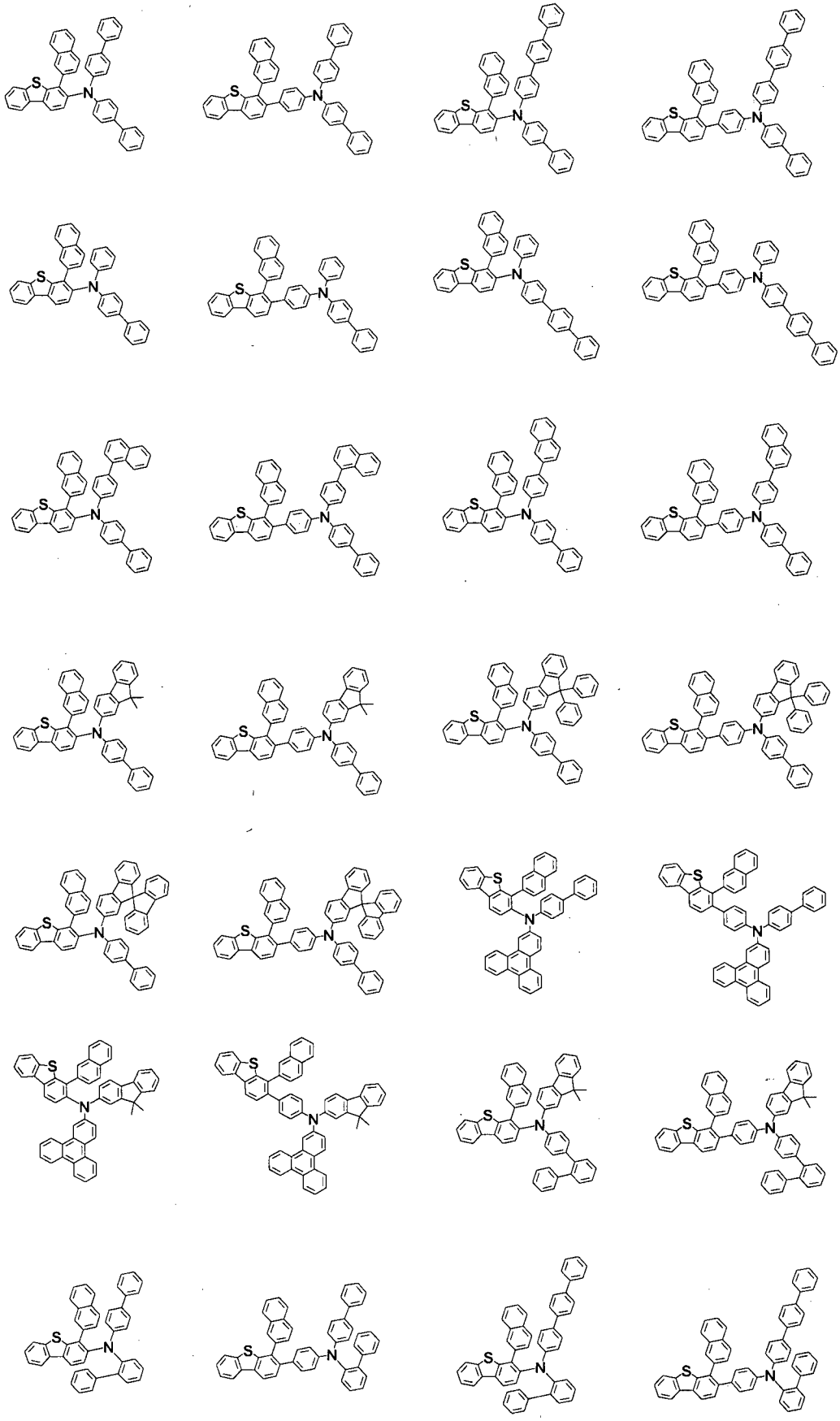


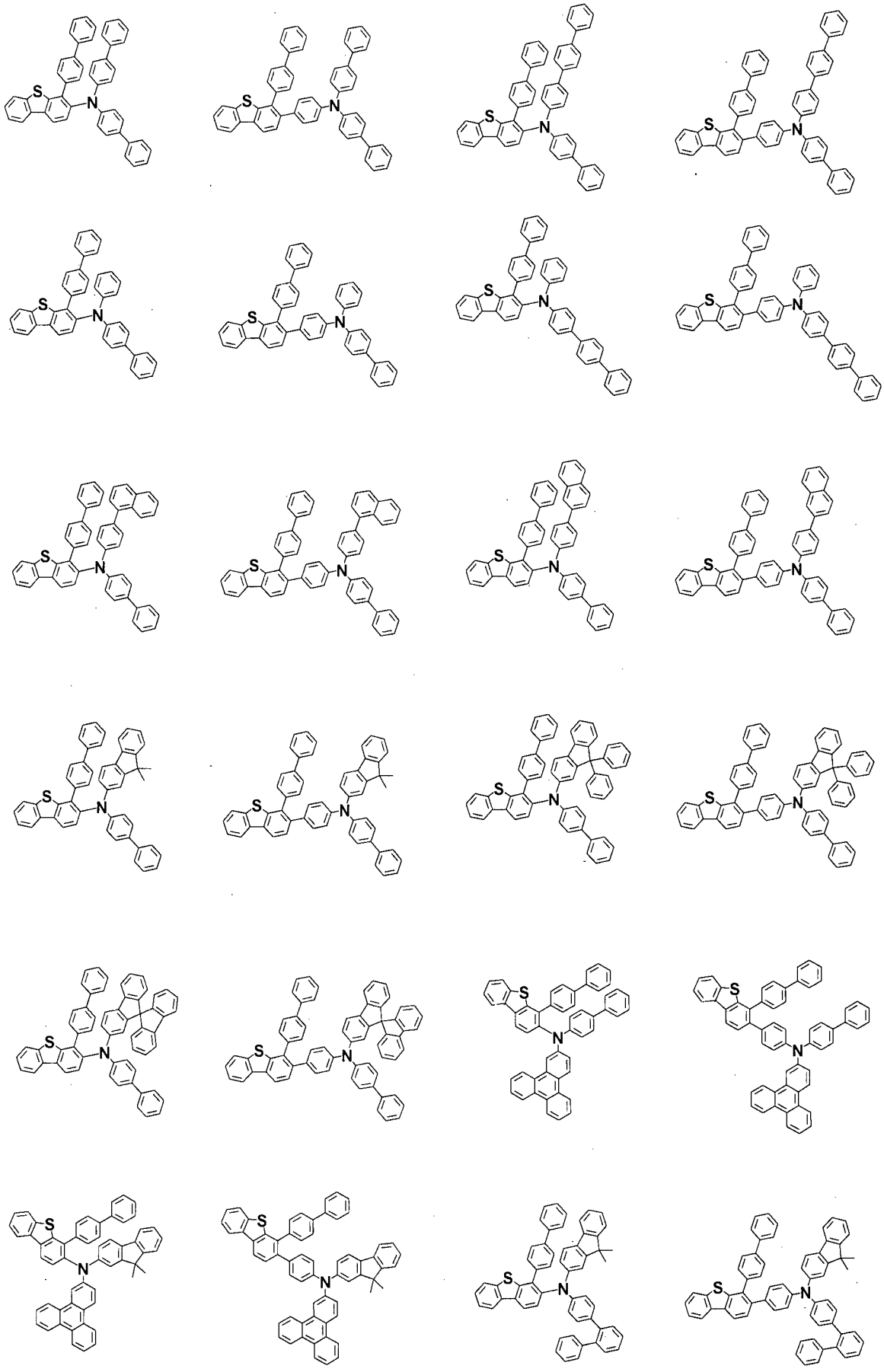


















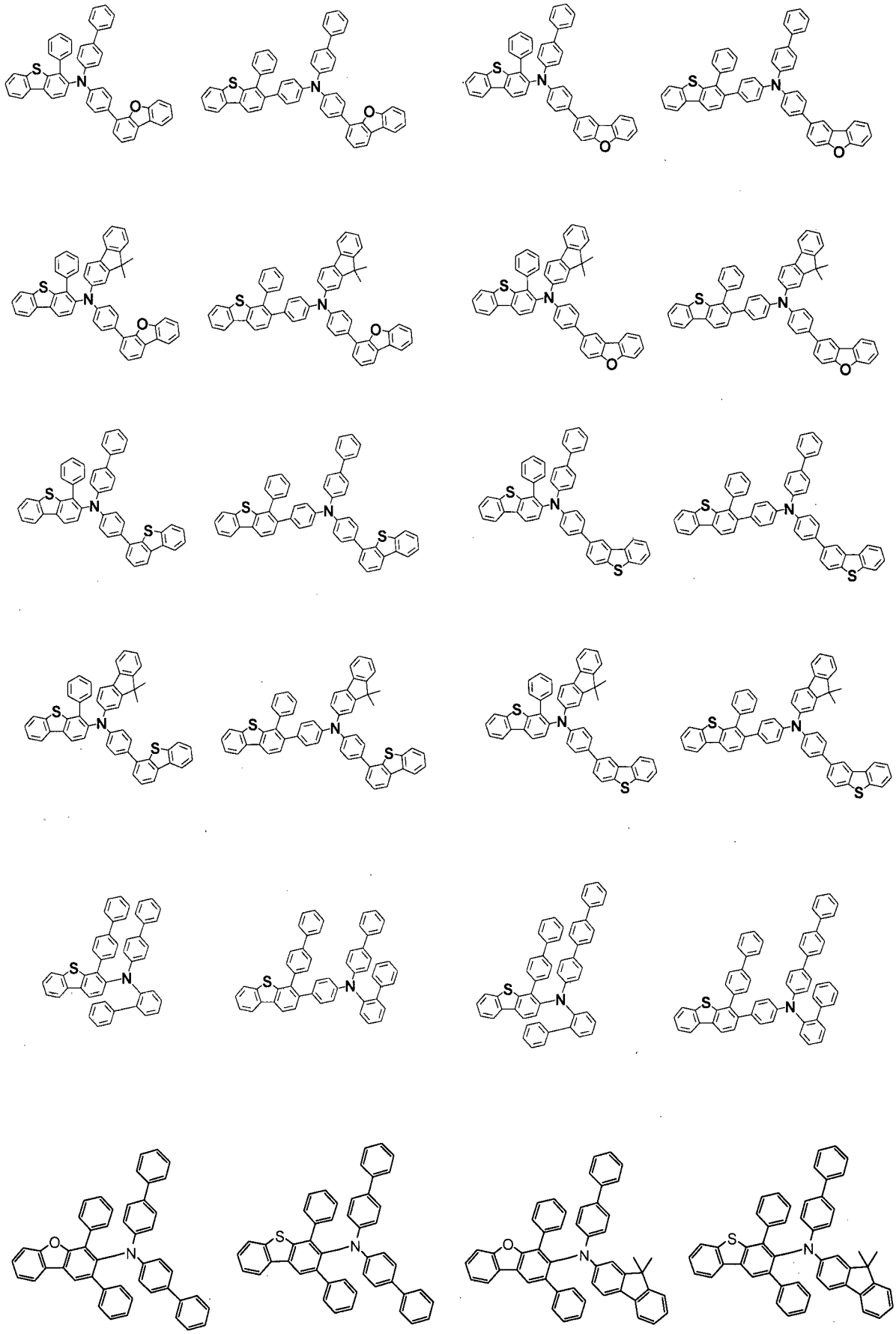








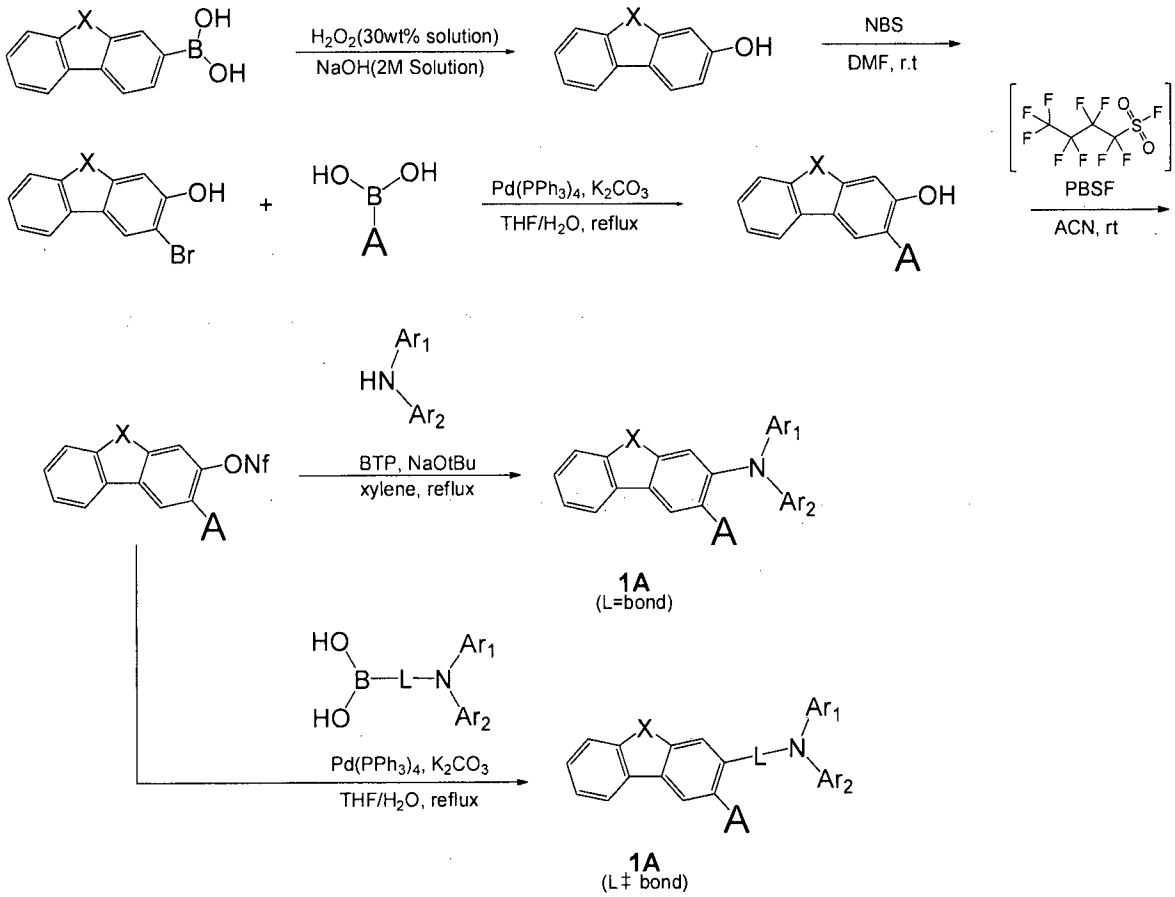




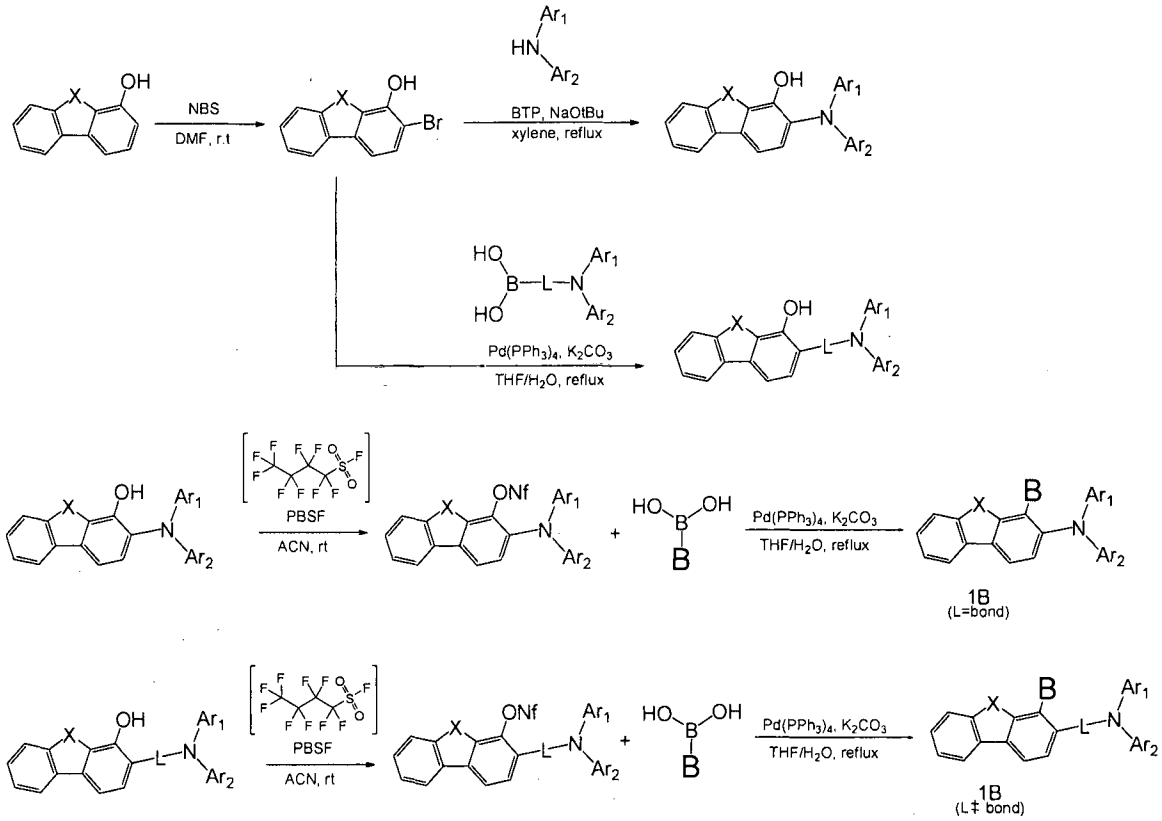
상기 화학식 1로 표시되는 화합물은, 디벤조퓨란/디벤조티오펜 코어의 특정 위치에 A 또는 B, 및 아릴아민 치환기가 연결된 구조를 가짐으로써, 이를 이용한 유기 발광 소자는 고효율, 저 구동 전압, 고휘도 및 장수명 등을 가질 수 있다.

한편, 상기 화학식 1A로 표시되는 화합물은 일례로 하기 반응식 1과 같은 제조 방법으로 제조할 수 있고, 상기 화학식 1B로 표시되는 화합물은 일례로 하기 반응식 2와 같은 제조 방법으로 제조할 수 있다.

[반응식 1]



[반응식 2]



상기 반응식 1 및 2 에서, X, A, B, L, Ar_1 및 Ar_2에 대한 설명은 상기 화학식 1에서 정의한 바와 같다.

상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 상기 반응식 1 및 2를 참고하여 제조하고자 하는 화합물의 구조에 맞추어 출발 물질을 적절히 대체하여 제조할 수 있다.

한편, 본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 유기 발광 소자를 제공한다. 일례로, 본 발명은 제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는, 유기 발광 소자를 제공한다.

상기 유기물층은 정공주입층, 정공수송층, 또는 정공 주입과 수송을

동시에 하는 층을 포함할 수 있다.

또한, 상기 유기물층은 발광층을 포함할 수 있고, 상기 발광층은 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함할 수 있다.

또한, 상기 전자수송층, 전자주입층, 또는 전자수송 및 전자주입을 동시에 하는 층을 포함할 수 있다.

또한, 상기 유기 발광 소자는 상기 유기층 외에도, 상기 정공 수송층과 상기 발광층 사이에 위치하는 전자 차단층(Electron blocking layer: EBL) 및/또는 상기 발광층과 상기 전자 수송층 사이에 위치하는 정공 차단층(Hole blocking layer: HBL)을 더 포함할 수 있다. 그리고, 상기 전자 차단층과 상기 정공 차단층은 각각 발광층과 인접하는 유기물층일 수 있다.

이때, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 상기 정공 수송층 및/또는 상기 전자 차단층에 포함될 수 있다.

본 발명의 유기 발광 소자의 유기물층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다. 예컨대, 본 발명의 유기 발광 소자는 유기물층 으로서 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등을 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나 유기 발광 소자의 구조는 이에 한정되지 않고 더 적은 수의 유기층을 포함할 수 있다.

본 발명의 유기 발광 소자의 유기물 층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다. 예컨대, 본 발명의 유기 발광 소자는 유기물 층으로서 발광층 이외에, 상기 제1전극과 상기 발광층 사이의 정공주입층 및 정공수송층, 및 상기 발광층과 상기 제2전극 사이의 전자수송층 및 전자주입층을 더 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나 유기 발광 소자의 구조는 이에 한정되지 않고 더 적은 수 또는 더 많은

수의 유기층을 포함할 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는, 기판 상에 양극, 1층 이상의 유기물층 및 음극이 순차적으로 적층된 구조(normal type)의 유기 발광 소자일 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는 기판 상에 음극, 1층 이상의 유기물층 및 양극이 순차적으로 적층된 역방향 구조(inverted type)의 유기 발광 소자일 수 있다. 예컨대, 본 발명의 일실시예에 따른 유기 발광 소자의 구조는 도 1 및 2에 예시되어 있다.

도 1은 기판(1), 양극(2), 발광층(3), 음극(4)으로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 상기 발광층에 포함될 수 있다.

도 2는 기판(1), 양극(2), 정공주입층(5), 정공수송층(6), 발광층(7), 전자수송층(8) 및 음극(4)로 이루어진 유기 발광 소자의 예를 도시한 것이다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 상기 정공주입층, 정공수송층, 발광층 및 전자수송층 중 1층 이상에 포함될 수 있다.

본 발명에 따른 유기 발광 소자는, 상기 유기물층 중 1층 이상이 상기 화학식 1로 표시되는 화합물을 포함하는 것을 제외하고는 당 기술분야에 알려져 있는 재료와 방법으로 제조될 수 있다. 또한, 상기 유기 발광 소자가 복수개의 유기물층을 포함하는 경우, 상기 유기물층은 동일한 물질 또는 다른 물질로 형성될 수 있다.

예컨대, 본 발명에 따른 유기 발광 소자는 기판 상에 제1 전극, 유기물층 및 제2 전극을 순차적으로 적층시켜 제조할 수 있다. 이때, 스퍼터링법(sputtering)이나 전자빔 증발법(e-beam evaporation)과 같은 PVD(physical Vapor Deposition)방법을 이용하여, 기판 상에 금속 또는 전도성을 가지는 금속 산화물 또는 이들의 합금을 증착시켜 양극을 형성하고, 그 위에 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층 및 전자수송층을 포함하는

유기물층을 형성한 후, 그 위에 음극으로 사용할 수 있는 물질을 증착시켜 제조할 수 있다. 이와 같은 방법 외에도, 기판 상에 음극 물질부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 만들 수 있다.

또한, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자의 제조시 진공 증착법 뿐만 아니라 용액 도포법에 의하여 유기물층으로 형성될 수 있다. 여기서, 용액 도포법이라 함은 스핀 코팅, 딥코팅, 닥터 블레이딩, 잉크젯 프린팅, 스크린 프린팅, 스프레이법, 롤 코팅 등을 의미하지만, 이들만으로 한정되는 것은 아니다.

이와 같은 방법 외에도, 기판 상에 음극 물질로부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기 발광 소자를 제조할 수 있다(WO 2003/012890). 다만, 제조 방법이 이에 한정되는 것은 아니다.

일례로, 상기 제1 전극은 양극이고, 상기 제2 전극은 음극이거나, 또는 상기 제1 전극은 음극이고, 상기 제2 전극은 양극이다.

상기 양극 물질로는 통상 유기물층으로 정공 주입이 원활할 수 있도록 일함수가 큰 물질이 바람직하다. 상기 양극 물질의 구체적인 예로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금; 아연 산화물, 인듐 산화물, 인듐주석 산화물(ITO), 인듐아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물; ZnO:Al 또는 SNO_2:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합; 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDOT), 폴리피롤 및 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

상기 음극 물질로는 통상 유기물층으로 전자 주입이 용이하도록 일함수가 작은 물질인 것이 바람직하다. 상기 음극 물질의 구체적인 예로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 티타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석 및 납과 같은 금속 또는 이들의 합금; LiF/Al 또는 LiO_2/Al과 같은 다층 구조 물질 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

상기 정공주입층은 전극으로부터 정공을 주입하는 층으로, 정공 주입 물질로는 정공을 수송하는 능력을 가져 양극에서의 정공 주입효과, 발광층 또는 발광재료에 대하여 우수한 정공 주입 효과를 갖고, 발광층에서 생성된 여기자의 전자주입층 또는 전자주입재료에의 이동을 방지하며, 또한, 박막 형성 능력이 우수한 화합물이 바람직하다. 정공 주입 물질의 HOMO(highest occupied molecular orbital)가 양극 물질의 일함수와 주변 유기물층의 HOMO 사이인 것이 바람직하다. 정공 주입 물질의 구체적인 예로는 금속 포피린(porphyrin), 올리고티오펜, 아릴아민 계열의 유기물, 헥사니트릴헥사아자트리페닐렌 계열의 유기물, 퀴나크리돈(quinacridone)계열의 유기물, 페릴렌(perylene) 계열의 유기물, 안트라퀴논 및 폴리아닐린과 폴리티오펜 계열의 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정 되는 것은 아니다.

상기 정공수송층은 정공주입층으로부터 정공을 수취하여 발광층까지 정공을 수송하는 층으로, 정공 수송 물질로는 양극이나 정공 주입층으로부터 정공을 수송받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로 정공에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 아릴아민 계열의 유기물, 전도성 고분자, 및 공액 부분과 비공액 부분이 함께 있는 블록 공중합체 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

상기 발광 물질로는 정공 수송층과 전자 수송층으로부터 정공과 전자를 각각 수송받아 결합시킴으로써 가시광선 영역의 빛을 낼 수 있는 물질로서, 형광이나 인광에 대한 양자 효율이 좋은 물질이 바람직하다. 구체적인 예로 8-히드록시-퀴놀린 알루미늄 착물(Alq_3); 카르바졸 계열 화합물; 이량체화 스티릴(dimerized styryl) 화합물; BAlq; 10-히드록시벤조 퀴놀린-금속 화합물; 벤족사졸, 벤즈티아졸 및 벤즈이미다졸 계열의 화합물; 폴리(p-페닐렌비닐렌)(PPV) 계열의 고분자; 스피로(spiro) 화합물; 폴리플루오렌, 루브렌 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

상기 발광층은 상술한 바와 같이 호스트 재료 및 도펀트 재료를 포함할 수 있다. 호스트 재료는 축합 방향족환 유도체 또는 헤테로환 함유 화합물 등을 더 포함할 수 있다. 구체적으로 축합 방향족환 유도체로는 안트라센 유도체, 피렌 유도체, 나프탈렌 유도체, 펜타센 유도체, 페난트렌 화합물, 플루오란텐 화합물 등이 있고, 헤테로환 함유 화합물로는 카바졸 유도체, 디벤조퓨란 유도체, 래더형 퓨란 화합물, 피리미딘 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

도펀트 재료로는 방향족 아민 유도체, 스트릴아민 화합물, 붕소 착체, 플루오란텐 화합물, 금속 착체 등이 있다. 구체적으로 방향족 아민 유도체로는 치환 또는 비치환된 아릴아미노기를 갖는 축합 방향족환 유도체로서, 아릴아미노기를 갖는 피렌, 안트라센, 크리센, 페리플란텐 등이 있으며, 스티릴아민 화합물로는 치환 또는 비치환된 아릴아민에 적어도 1개의 아릴비닐기가 치환되어 있는 화합물로, 아릴기, 실릴기, 알킬기, 사이클로알킬기 및 아릴아미노기로 이루어진 군에서 1 또는 2 이상 선택되는 치환기가 치환 또는 비치환된다. 구체적으로 스티릴아민, 스티릴디아민, 스티릴트리아민, 스티릴테트라아민 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 금속 착체로는 이리듐 착체, 백금 착체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

상기 전자수송층은 전자주입층으로부터 전자를 수취하여 발광층까지 전자를 수송하는 층으로, 전자 수송 물질로는 음극으로부터 전자를 잘 주입받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로서, 전자에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 8-히드록시퀴놀린의 Al 착물; Alq_3를 포함한 착물; 유기 라디칼 화합물; 히드록시플라본-금속 착물 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다. 전자 수송층은 종래기술에 따라 사용된 바와 같이 임의의 원하는 캐소드 물질과 함께 사용할 수 있다. 특히, 적절한 캐소드 물질의 예는 낮은 일함수를 가지고 알루미늄층 또는 실버층이 뒤따르는 통상적인 물질이다. 구체적으로 세슘, 바륨, 칼슘, 이테르븀 및 사마륨이고, 각 경우 알루미늄 층 또는 실버층이 뒤따른다.

상기 전자주입층은 전극으로부터 전자를 주입하는 층으로, 전자를 수송하는 능력을 갖고, 음극으로부터의 전자 주입 효과, 발광층 또는 발광 재료에 대하여 우수한 전자주입 효과를 가지며, 발광층에서 생성된 여기자의 정공주입층에의 이동을 방지하고, 또한, 박막형성능력이 우수한 화합물이 바람직하다. 구체적으로는 플루오레논, 안트라퀴노다이메탄, 다이페노퀴논, 티오피란 다이옥사이드, 옥사졸, 옥사다이아졸, 트리아졸, 이미다졸, 페릴렌테트라카복실산, 프레오레닐리덴 메탄, 안트론 등과 그들의 유도체, 금속 착체 화합물 및 질소 함유 5원환 유도체 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

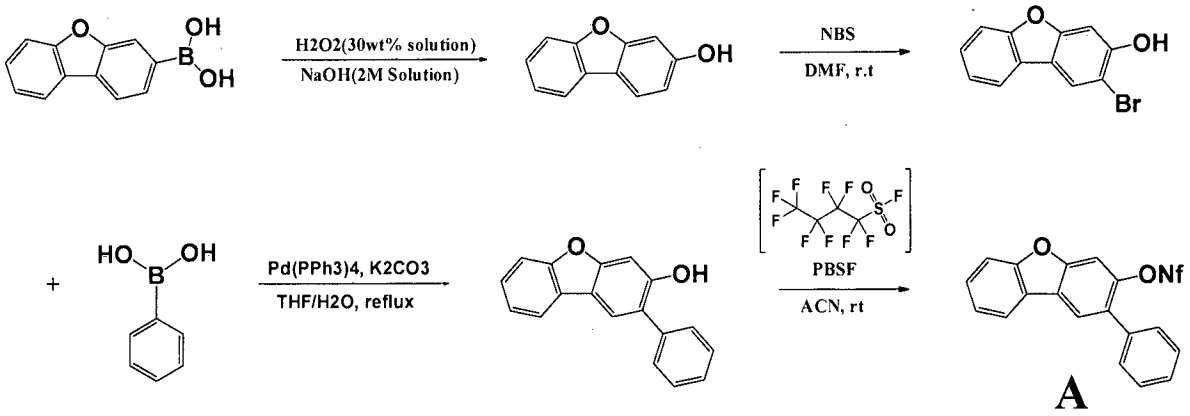
상기 금속 착체 화합물로서는 8-하이드록시퀴놀리나토 리튬, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)아연, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)구리, 비스(8-하이드록시퀴놀리나토)망간, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(2-메틸-8-하이드록시퀴놀리나토)알루미늄, 트리스(8-하이드록시퀴놀리나토)갈륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)베릴륨, 비스(10-하이드록시벤조[h]퀴놀리나토)아연, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)클로로갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(o-크레졸라토)갈륨, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(1-나프톨라토)알루미늄, 비스(2-메틸-8-퀴놀리나토)(2-나프톨라토)갈륨 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

본 발명에 따른 유기 발광 소자는 사용되는 재료에 따라 전면 발광형, 후면 발광형 또는 양면 발광형일 수 있다.

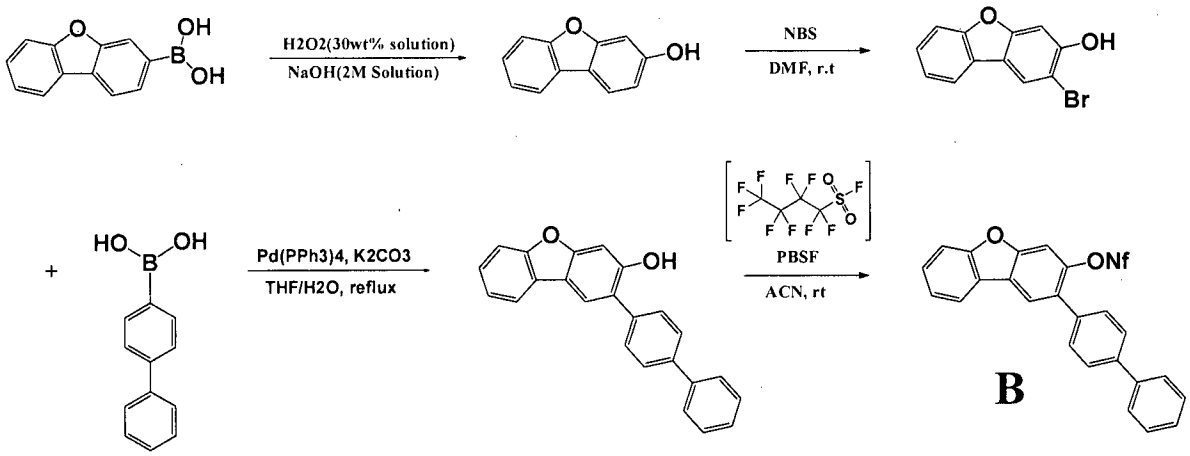
또한, 상기 화학식 1로 표시되는 화합물은 유기 발광 소자 외에도 유기 태양 전지 또는 유기 트랜지스터에 포함될 수 있다.

상기 화학식 1로 표시되는 화합물 및 이를 포함하는 유기 발광 소자의 제조는 이하 실시예에서 구체적으로 설명한다. 그러나 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명의 범위가 이들에 의하여 한정되는 것은 아니다.

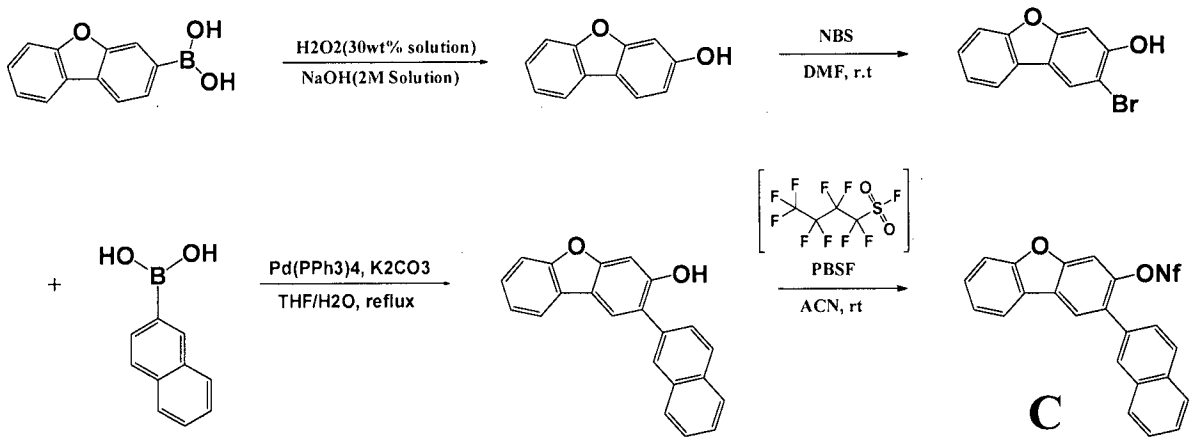
제조예 A: 중간체 화합물 A의 제조



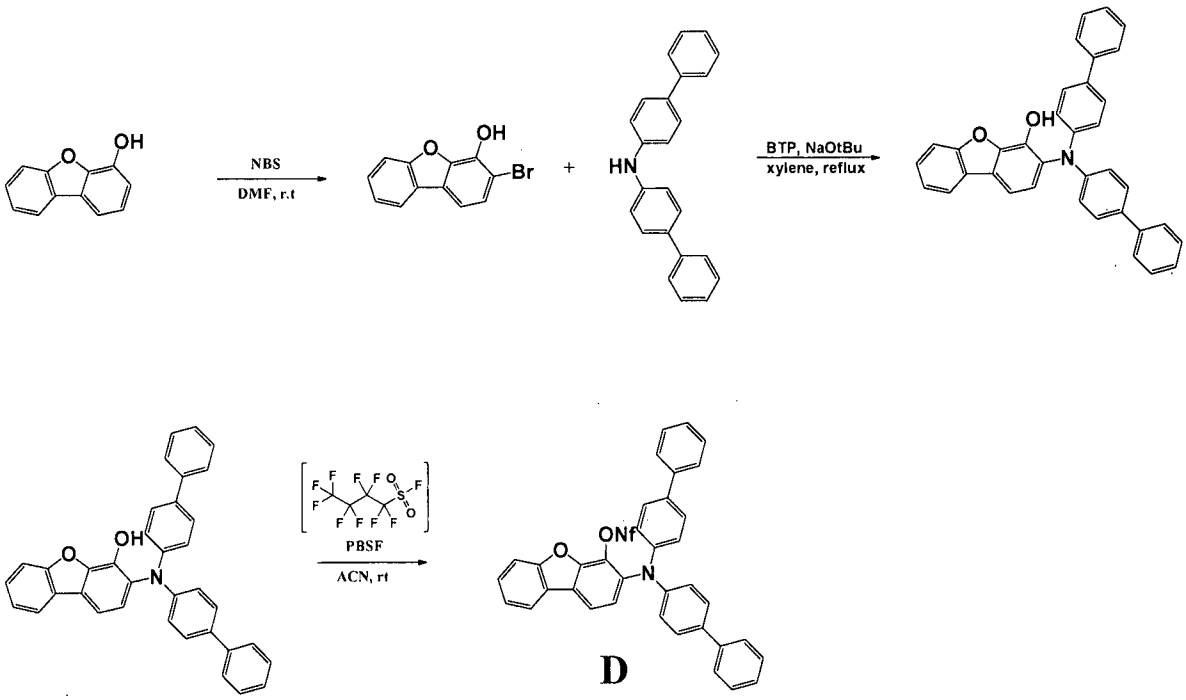
제조예 B: 중간체 화합물 B의 제조



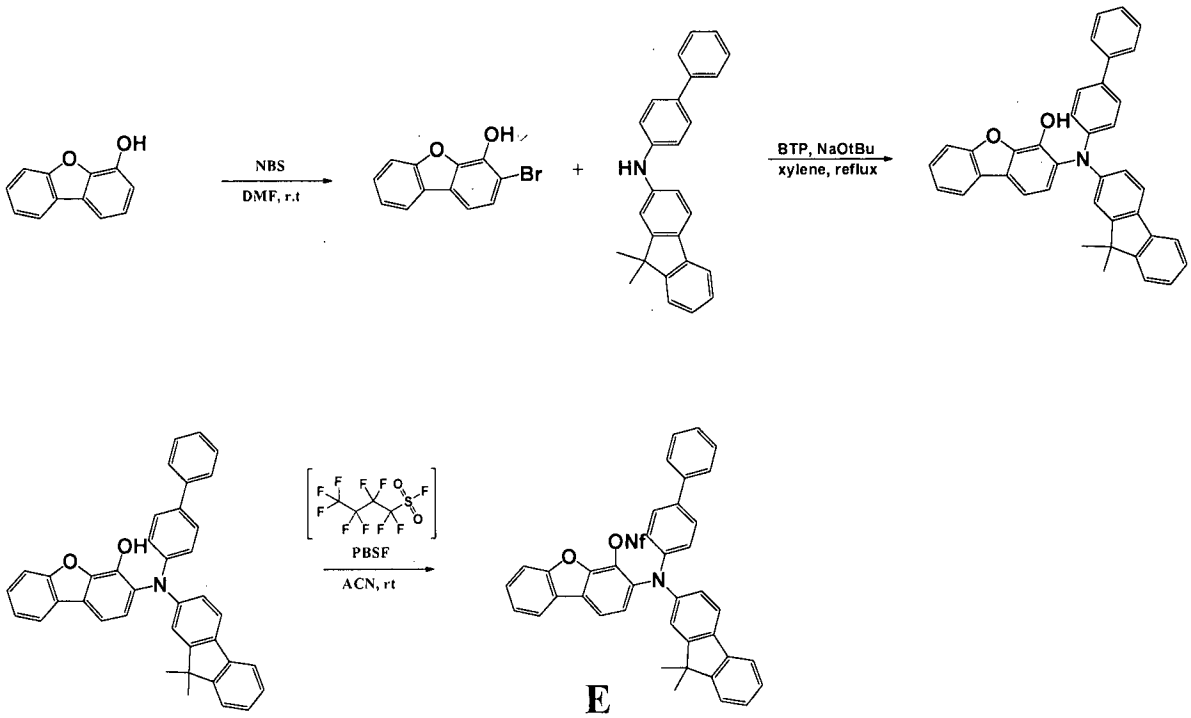
제조예 C: 중간체 화합물 C의 제조



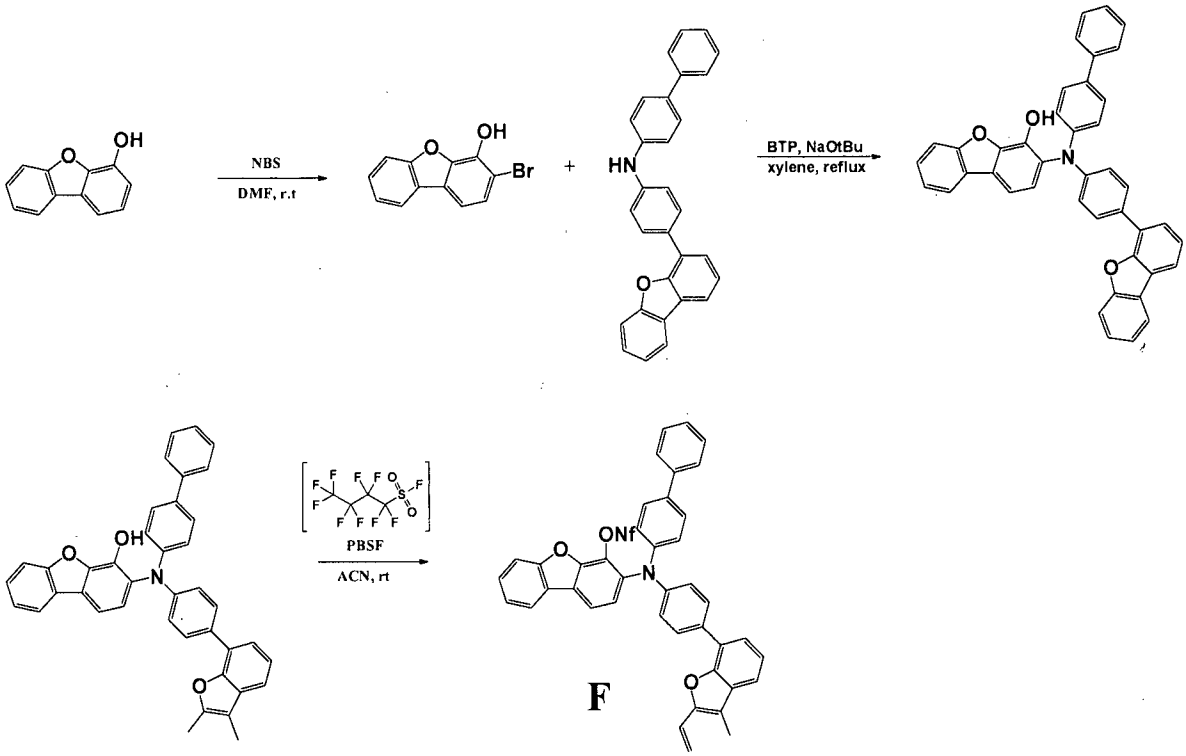
제조예 D: 중간체 화합물 D의 제조



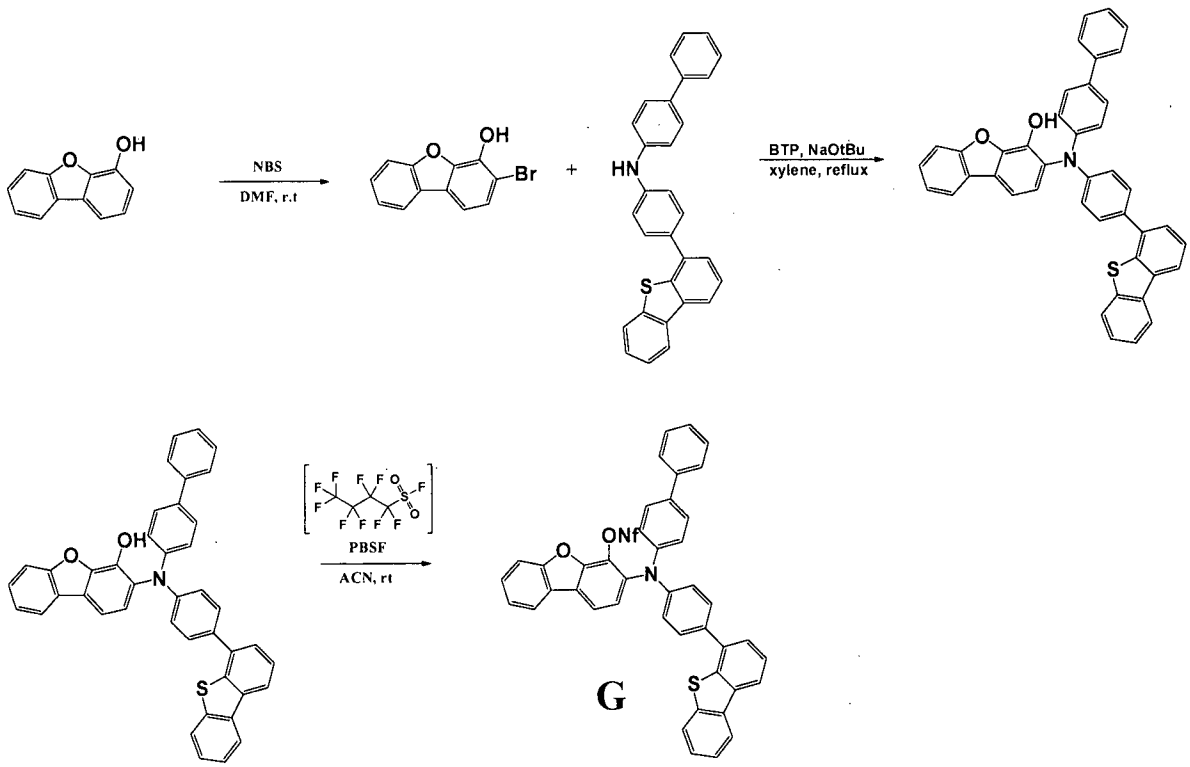
제조예 E: 중간체 화합물 E의 제조



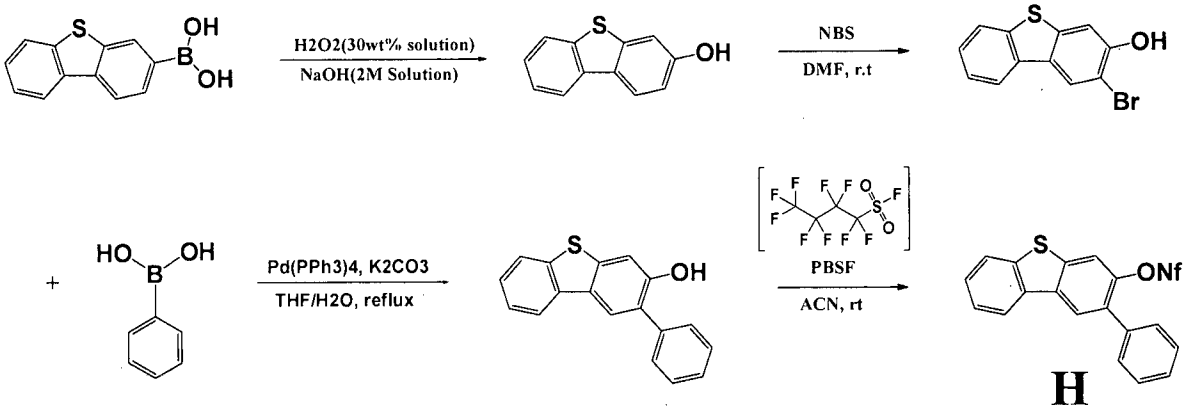
제조예 F: 중간체 화합물 F의 제조



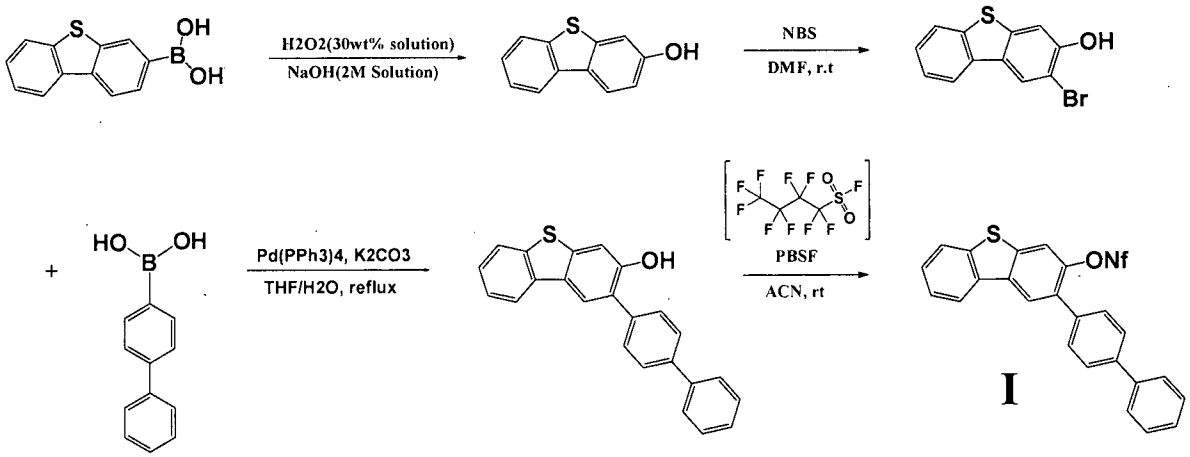
제조예 G: 중간체 화합물 G의 제조



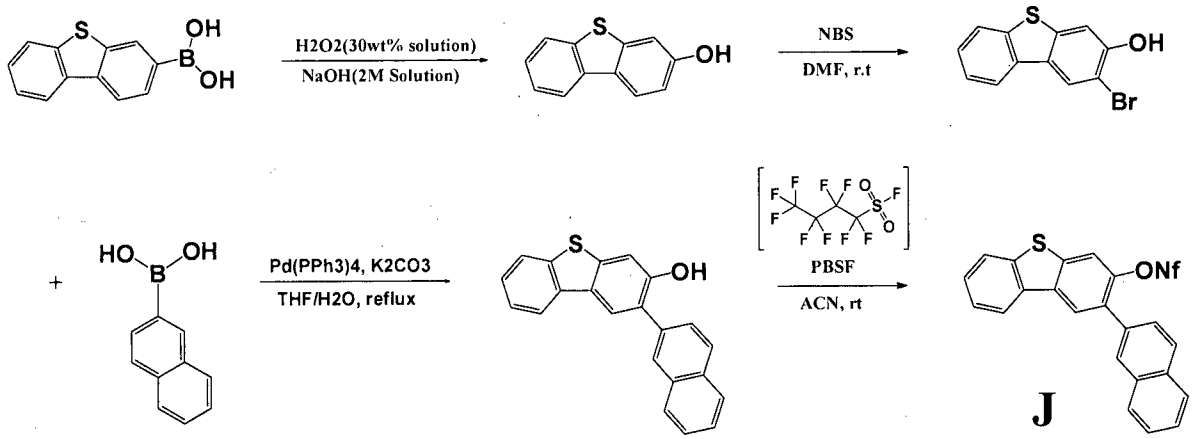
제조예 H: 중간체 화합물 H의 제조



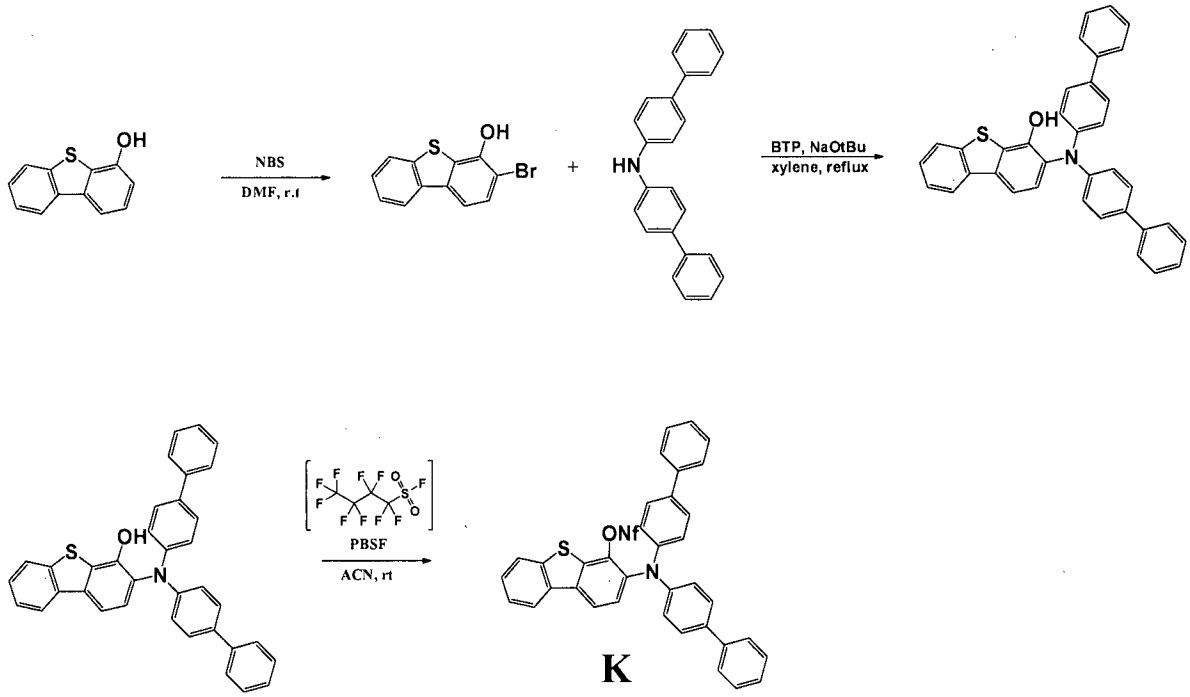
제조예 I: 중간체 화합물 I의 제조



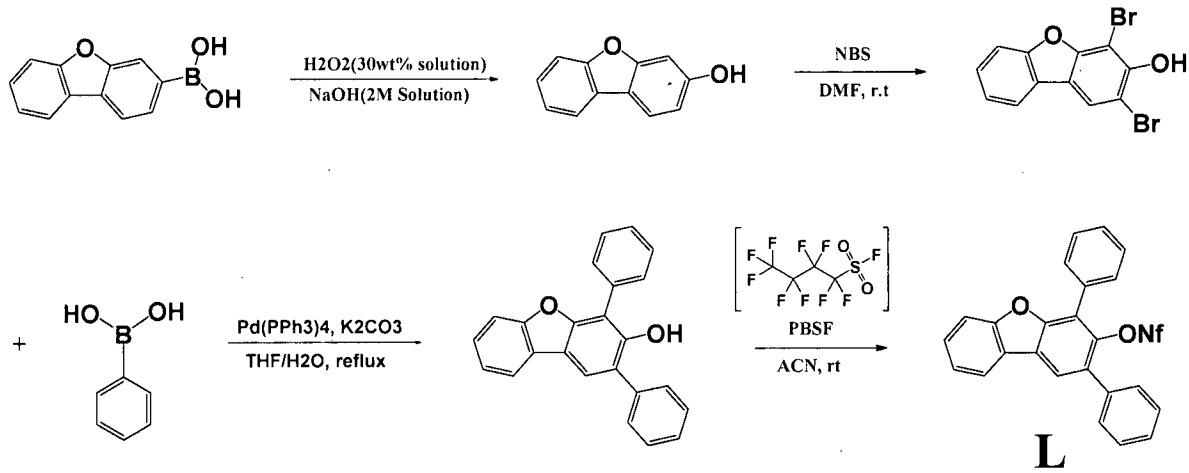
제조예 J: 중간체 화합물 J의 제조



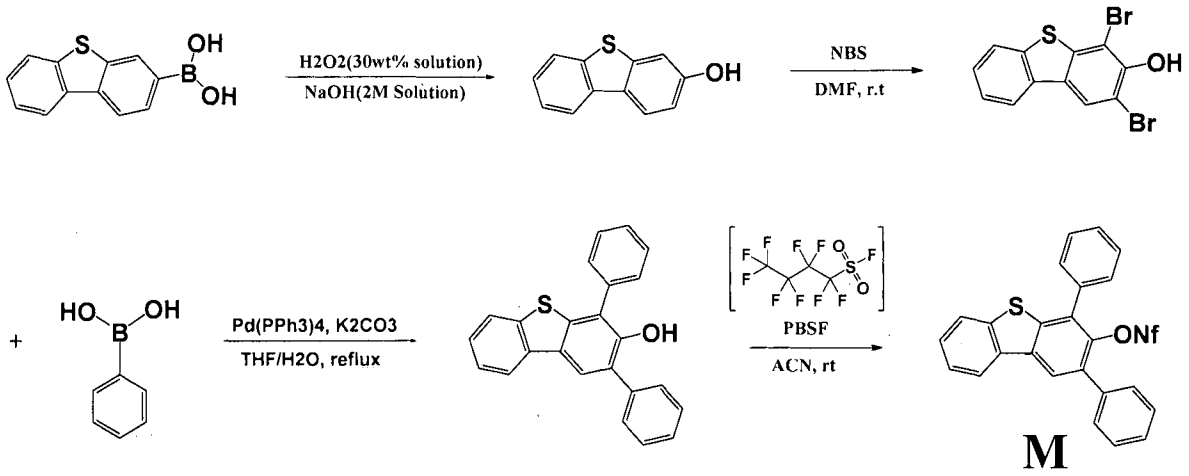
제조예 K: 중간체 화합물 K의 제조



제조예 L: 중간체 화합물 L의 제조

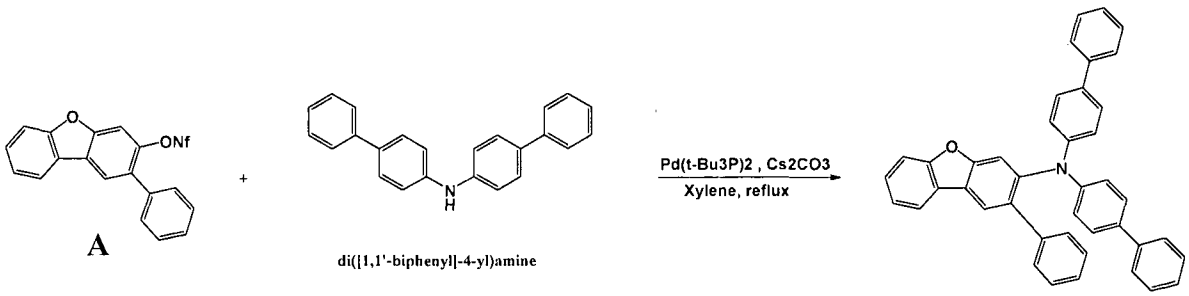


제조예 M: 중간체 화합물 M의 제조



제조예 1: 화합물 1의 제조

[화합물 1]

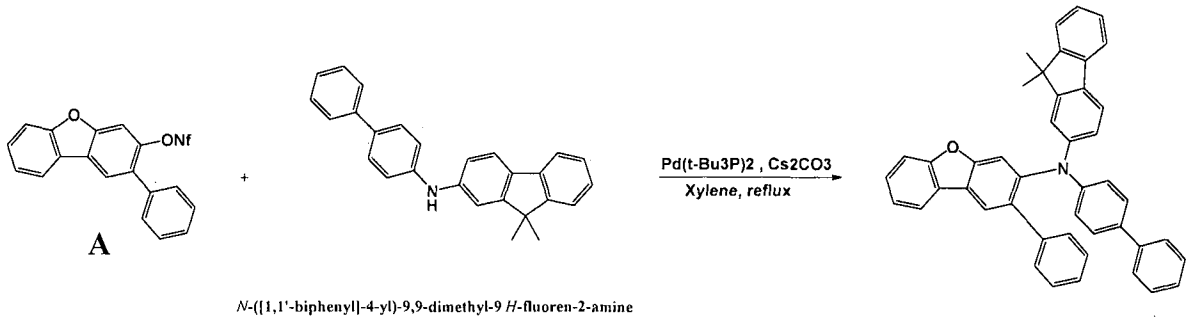


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 A(7.56g, 31.11mmol), di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine(10.99g, 34.22mmol)을 Xylene 220ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(12.13g, 37.33mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.08g, 0.16mmol)을 넣은 후 3시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 에틸아세테이트 180ml으로 재결정하여 상기 화합물 1(12.46g, 수율: 71%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 564

제조예 2: 화합물 2의 제조

[화합물 2]



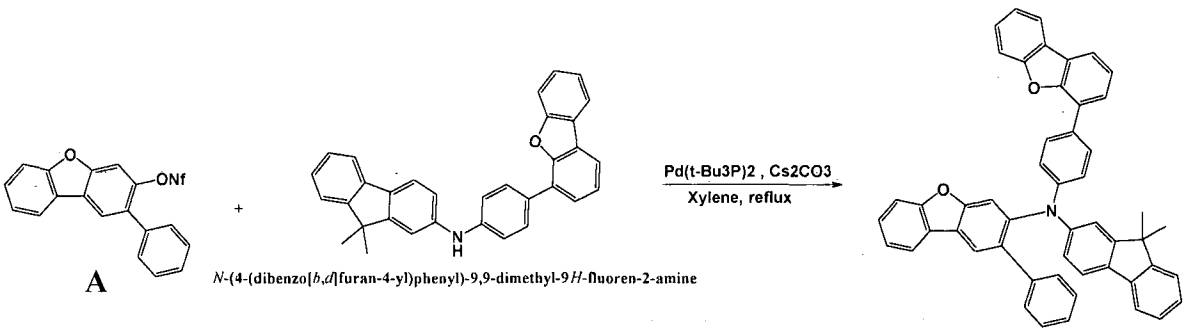
N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9*H*-fluoren-2-amine

질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 A(8.22g, 33.83mmol), N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine(13.43g, 37.21mmol)을 Xylene 250ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(13.19g, 40.59mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.09g, 0.17mmol)을 넣은 후 2 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 에틸아세테이트 130ml으로 재결정하여 상기 화합물 2(10.45g, 수율: 51%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 604

제조예 3: 화합물 3의 제조

[화합물 3]



N-(4-(dibenzo[*b*,*d*]furan-4-yl)phenyl)-9,9-dimethyl-9*H*-fluoren-2-amine

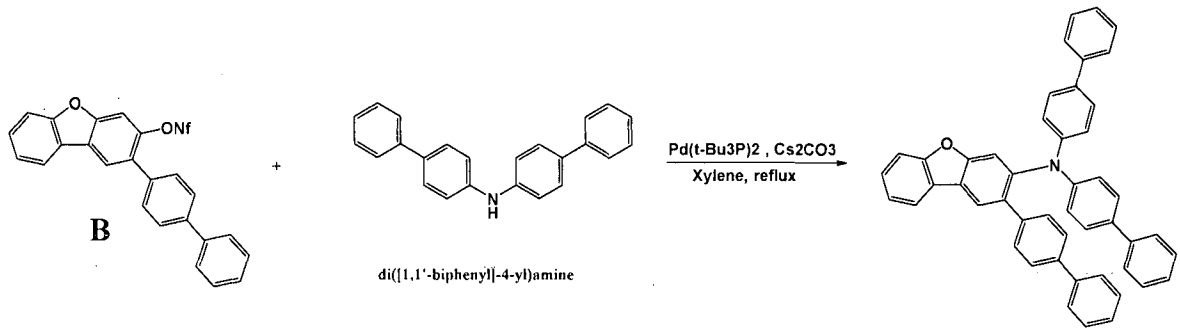
질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 A(6.73g, 27.70mmol), N-(4-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine(13.74g, 30.47mmol)을 Xylene 300ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(10.80g, 33.23mmol)를 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine)

palladium(0)(0.07g, 0.14mmol)을 넣은 후 6 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 테트라하이드로퓨란 260ml으로 재결정하여 상기 화합물 3(13.29g, 수율: 69%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+= 694$

제조예 4: 화합물 4의 제조

[화합물 4]

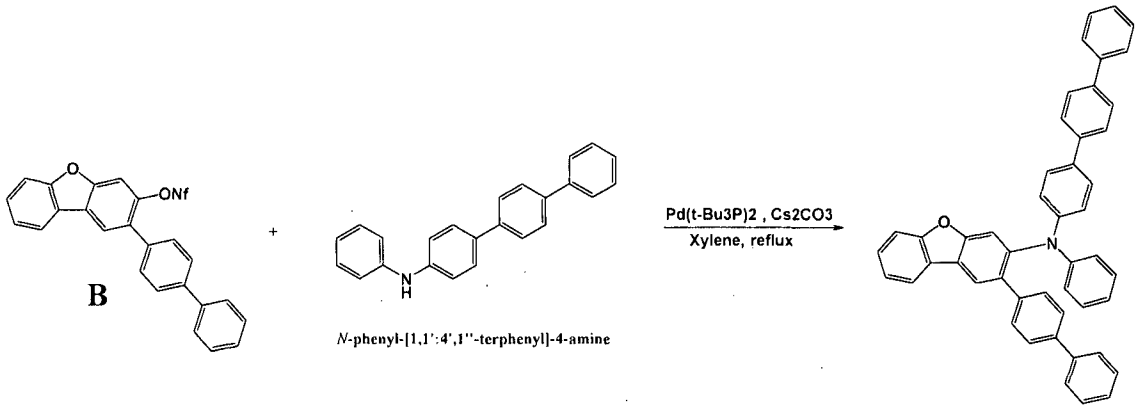


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 B(4.96g, 15.55mmol), di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine(5.49g, 17.10mmol)을 Xylene 260ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(6.06g, 18.66mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.04g, 0.08mmol)을 넣은 후 6 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 에틸아세테이트 220ml으로 재결정하여 상기 화합물 4(7.19g, 수율: 67%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+= 640$

제조예 5: 화합물 5의 제조

[화합물 5]

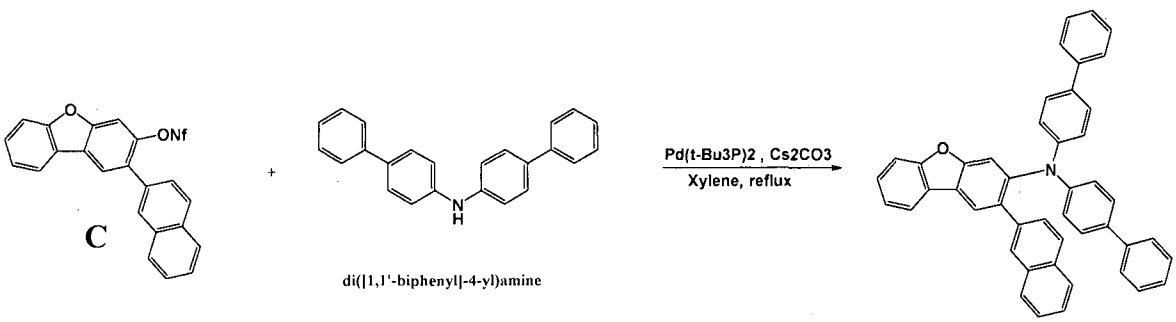


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 B(4.96g, 15.55mmol), N-phenyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-amine(5.49g, 17.10mmol)을 Xylene 260ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(6.06g, 18.66mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.04g, 0.08mmol)을 넣은 후 5 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml으로 재결정하여 상기 화합물 5(6.08g, 수율: 56%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 640

제조예 6: 화합물 6의 제조

[화합물 6]



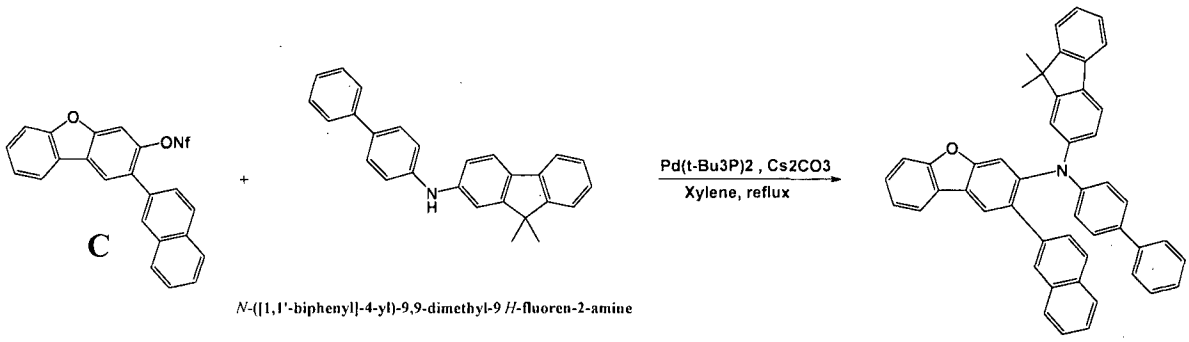
질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 C(5.13g, 17.51mmol), di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine(6.18g, 19.26mmol)을 Xylene 190ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(6.83g, 21.01mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.04g, 0.09mmol)을 넣은 후 4

시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml으로 재결정하여 상기 화합물 6(7.82g, 수율: 73%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 614

제조예 7: 화합물 7의 제조

[화합물 7]



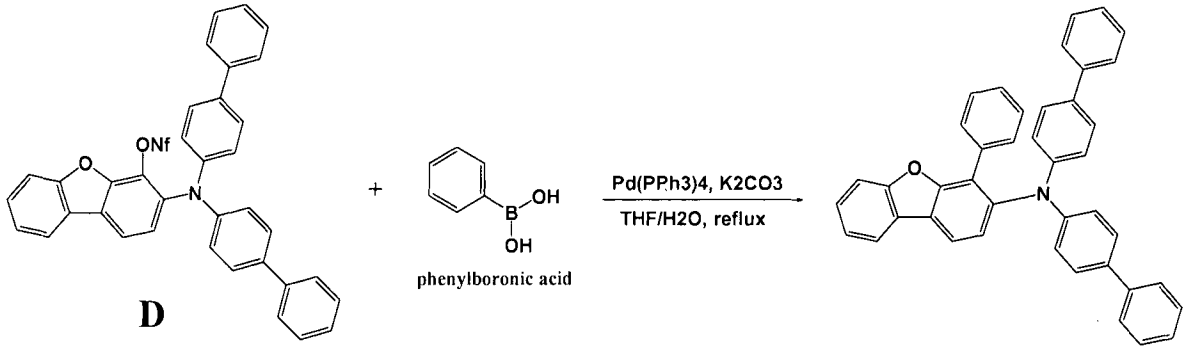
N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9*H*-fluoren-2-amine

질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 C(4.29g, 14.64mmol), N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine(5.81g, 16.11mmol)을 Xylene 280ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(5.71g, 17.57mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.04g, 0.07mmol)을 넣은 후 3 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 에틸아세테이트 130ml으로 재결정하여 상기 화합물 7(5.17g, 수율: 58%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 604

제조예 8: 화합물 8의 제조

[화합물 8]

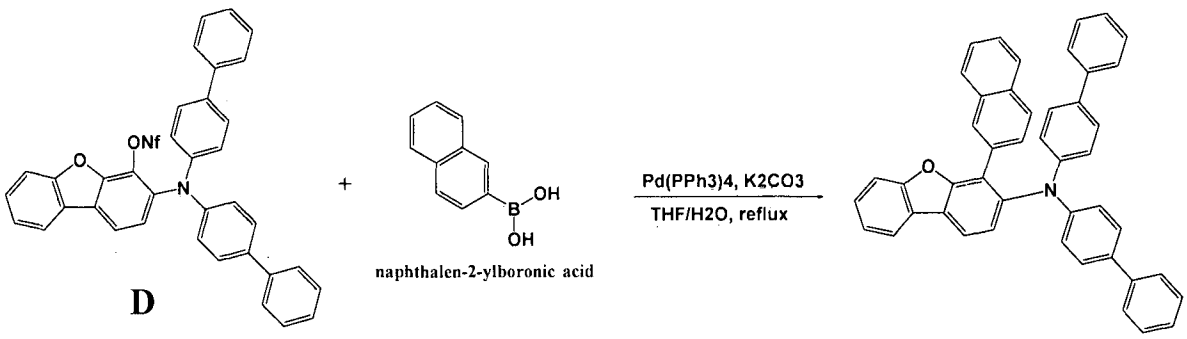


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 D(7.38g, 15.19mmol), phenylboronic acid(2.13g, 17.46mmol)을 테트라하이드로퓨란 240ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(120ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.62g, 0.58mmol)을 넣은 후 5 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml로 재결정하여 상기 화합물 8(6.27g, 수율: 73%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 564

제조예 9: 화합물 9의 제조

[화합물 9]



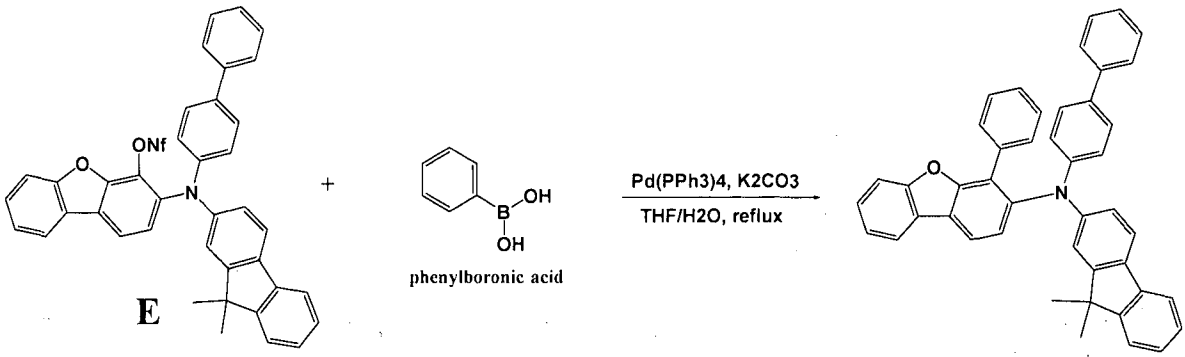
질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 D(7.38g, 15.19mmol), naphthalen-2-ylboronic acid(2.13g, 17.46mmol)을 테트라하이드로퓨란 280ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(140ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.61g, 0.57mmol)을 넣은 후 4

시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml로 재결정하여 상기 화합물 9(7.01g, 수율: 75%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 614

제조예 10: 화합물 10의 제조

[화합물 10]

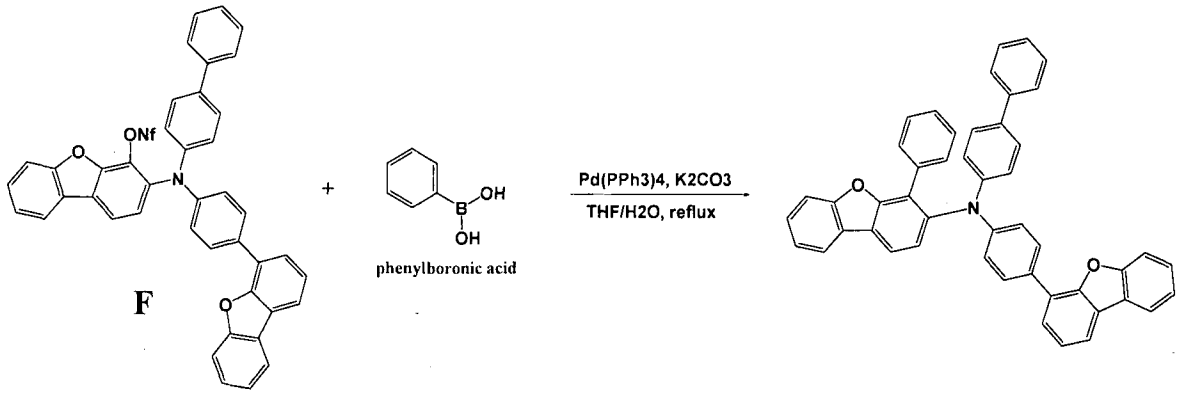


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 E(7.38g, 15.19mmol), phenylboronic acid(2.13g, 17.46mol)을 테트라하이드로퓨란 240ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(120ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.49g, 0.46mmol)을 넣은 후 6 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 240ml로 재결정하여 상기 화합물 10(8.26g, 수율: 79%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 604

제조예 11: 화합물 11의 제조

[화합물 11]

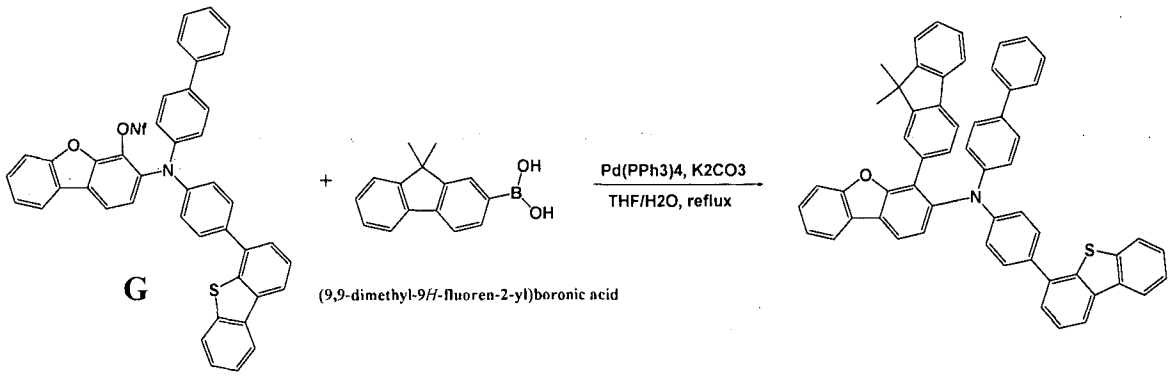


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 F(7.77g, 13.49mmol), phenylboronic acid(1.89g, 15.51mol)를 테트라하이드로퓨란 200ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(100ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.47g, 0.40mmol)을 넣은 후 6 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 260ml로 재결정하여 상기 화합물 11(8.26g, 수율: 79%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 654

제조예 12: 화합물 12의 제조

[화합물 12]



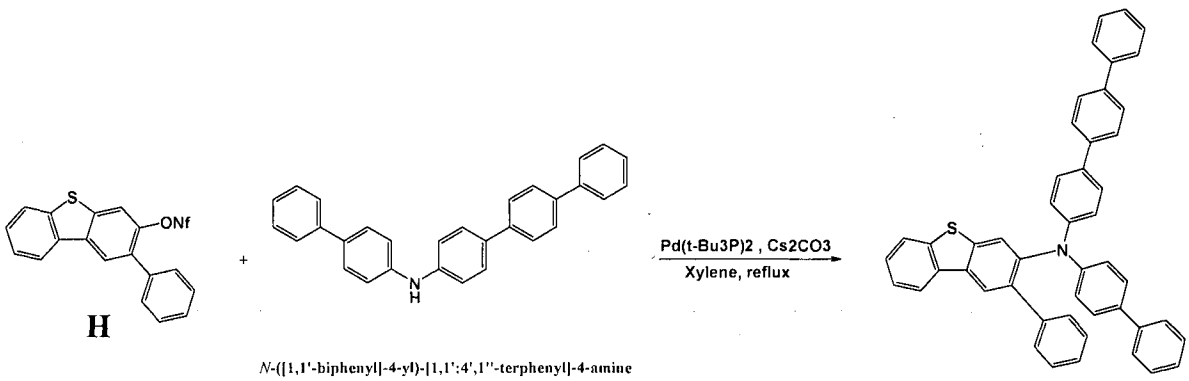
질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 G(6.64g, 11.22mmol), (9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid(3.07g, 12.90mmol)를 테트라하이드로퓨란 240ml에 완전히 녹인 후 2M

탄산칼륨수용액(120ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.39g, 0.34mmol)을 넣은 후 4 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 310ml로 재결정하여 상기 화합물 12(8.26g, 수율: 79%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 786

제조예 13: 화합물 13의 제조

[화합물 13]

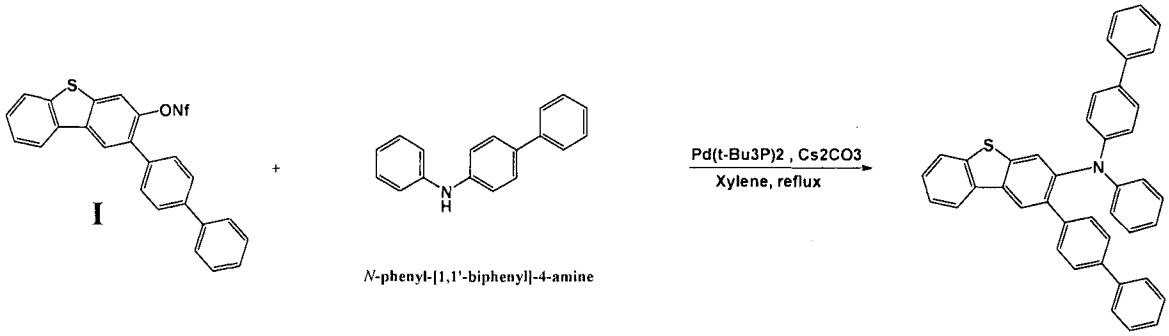


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 H(5.39g, 20.81mmol), N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-amine(9.17g, 23.10mmol)을 Xylene 250ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(8.66g, 27.05mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.11g, 0.21mmol)을 넣은 후 5 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 테트라하이드로퓨란 250ml으로 재결정하여 상기 화합물 13(11.67g, 수율: 70%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 656

제조예 14: 화합물 14의 제조

[화합물 14]

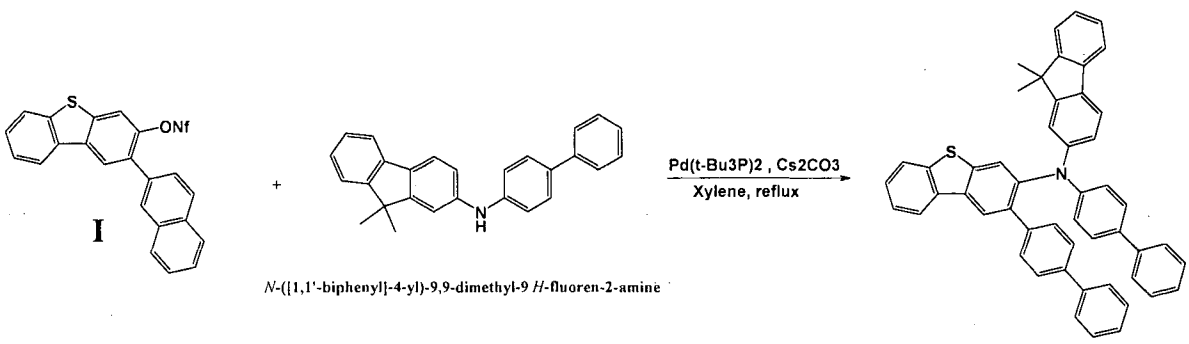


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 I(7.16g, 20.81mmol), N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine(5.81g, 23.72mmol)을 Xylene 300ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(8.89g, 27.79mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.11g, 0.21mmol)을 넣은 후 3 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 테트라하이드로퓨란 200ml으로 재결정하여 상기 화합물 14(8.88g, 수율: 72%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 580

제조예 15: 화합물 15의 제조

[화합물 15]



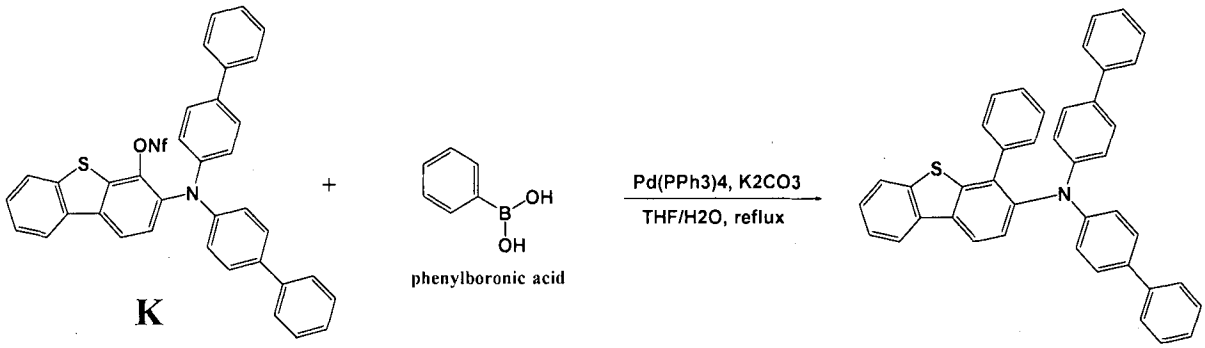
질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 I(4.28g, 13.85mmol), N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine(5.55g, 15.37mmol)을 Xylene 280ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(5.76g, 18.01mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.07g, 0.14mmol)을 넣은 후 4 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축

시키고 테트라하이드로퓨란 220ml으로 재결정하여 상기 화합물 15(4.39g, 수율: 46%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 696

제조예 16: 화합물 16의 제조

[화합물 16]



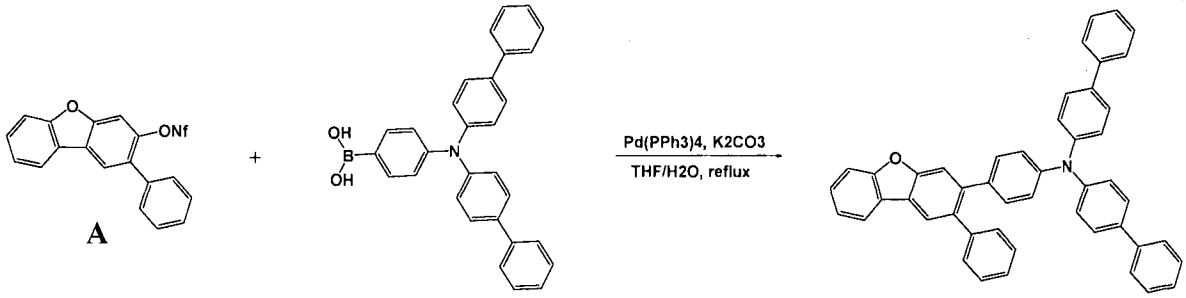
K

질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 K(9.68g, 19.28mmol), phenylboronic acid(2.61g, 21.40mmol)을 테트라하이드로퓨란 240ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(120ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.67g, 0.58mmol)을 넣은 후 4 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 220ml로 재결정하여 상기 화합물 16(6.09g, 수율: 54%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 580

제조예 17: 화합물 17의 제조

[화합물 17]



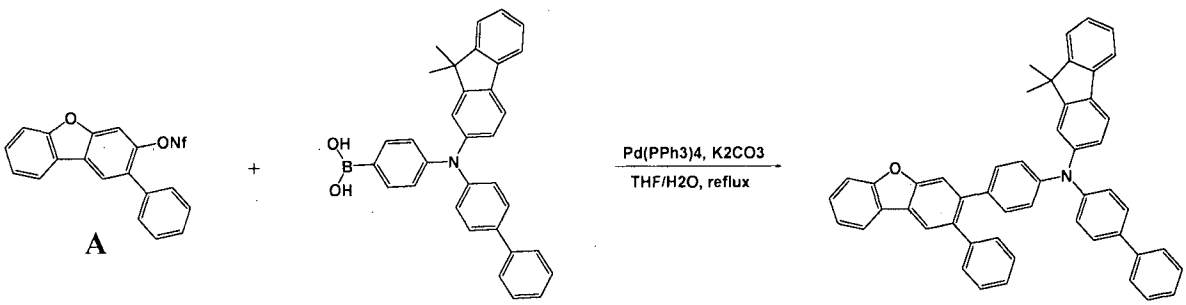
(4-(di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amino)phenyl)boronic acid

질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 A(5.32g,(4-(di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amino)phenyl)boronic acid(10.72g, 24.30mmol)을 테트라하이드로퓨란 240ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(120ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.76g, 0.66mmol)을 넣은 후 4 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml로 재결정하여 상기 화합물 17(7.12g, 수율: 51%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 640

제조예 18: 화합물 18의 제조

[화합물 18]



(4-([1,1'-biphenyl]-4-yl(9,9-dimethyl-9*H*-fluoren-2-yl)amino)phenyl)boronic acid

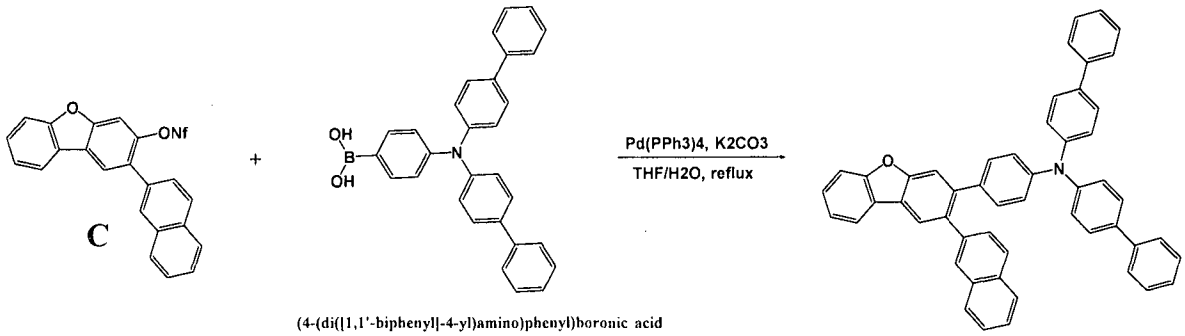
질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 A(6.67g, 27.45mmol),(4-([1,1'-biphenyl]-4-yl(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amino)phenyl)boronic acid(10.72g, 24.30mol)을 테트라하이드로퓨란 240ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(120ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.76g, 0.66mmol)을 넣은 후 4 시간 동안 가열

교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml로 재결정하여 상기 화합물 18(7.12g, 수율: 51%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 680

제조예 19: 화합물 19의 제조

[화합물 19]



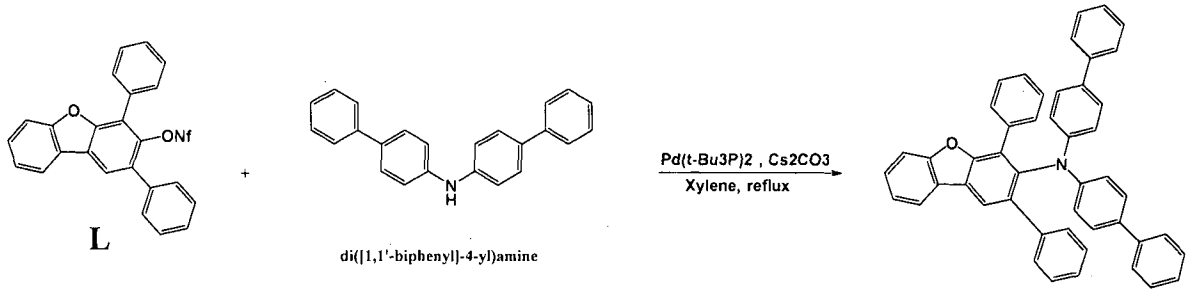
(4-(di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amino)phenyl)boronic acid

질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 C(7.75g, 27.45mmol),(4-([1,1'-biphenyl]-4-yl(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amino)phenyl)boronic acid(13.41g, 30.42mol)을 테트라하이드로퓨란 280ml에 완전히 녹인 후 2M 탄산칼륨수용액(140ml)을 첨가하고, 테트라키스-(트리페닐포스핀)팔라듐(0.92g, 079mmol)을 넣은 후 3 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 물 층을 제거하고 무수황산마그네슘으로 건조한 후 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml로 재결정하여 상기 화합물 19(15.26g, 수율: 84%)를 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 690

제조예 20: 화합물 20의 제조

[화합물 20]

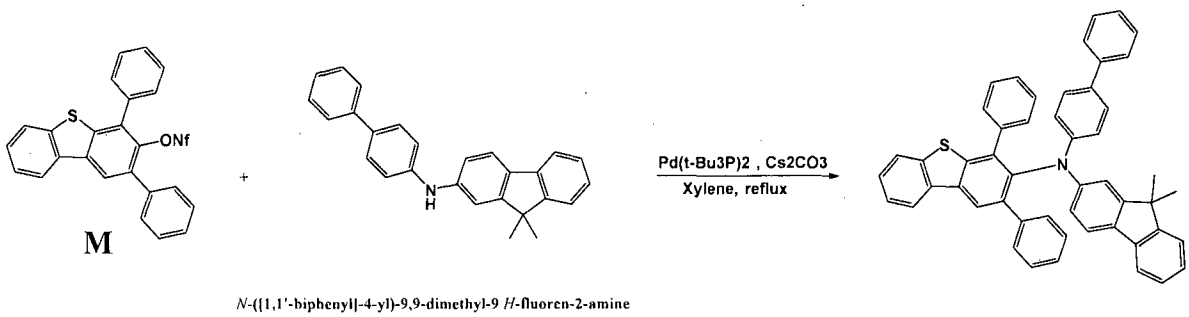


질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 L(5.47g, 17.15mmol), di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine(6.33g, 19.72mmol)을 Xylene 180ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(8.38g, 25.72mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.09g, 0.17mmol)을 넣은 후 6 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축 시키고 에틸아세테이트 250ml으로 재결정하여 상기 화합물 20(6.77g, 수율: 62%)을 제조하였다.

$MS[M+H]^+$= 640

제조예 21: 화합물 21의 제조

[화합물 21]



질소 분위기에서 500ml 둥근 바닥 플라스크에 화합물 M(7.54g, 22.51mmol), N-([1,1'-biphenyl]-4-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine(9.34g, 25.88mmol)을 Xylene 220ml에 완전히 녹인 후 Caesium carbonate(11.00g, 33.76mmol)을 첨가하고, Bis(tri-*tert*-butylphosphine) palladium(0)(0.12g, 0.23mmol)을 넣은 후 3 시간 동안 가열 교반하였다. 상온으로 온도를 낮추고 filter하여 base를 제거한 후에 Xylene을 감압농축

시키고 에틸아세테이트 180ml으로 재결정하여 상기 화합물 21(10.07g, 수율: 64%)를 제조하였다.

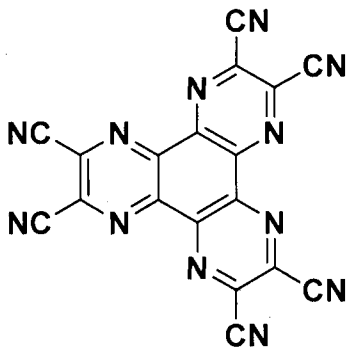
$MS[M+H]^+$= 696

실시예 1-1

ITO(indium tin oxide)가 1,000Å의 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 세제를 녹인 증류수에 넣고 초음파로 세척하였다. 이 때, 세제로는 피셔사(Fischer Co.) 제품을 사용하였으며, 증류수로는 밀러포어사(Millipore Co.) 제품의 필터(Filter)로 2차로 걸러진 증류수를 사용하였다. ITO를 30분간 세척한 후 증류수로 2회 반복하여 초음파 세척을 10분간 진행하였다. 증류수 세척이 끝난 후, 이소프로필알콜, 아세톤, 메탄올의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 플라즈마 세정기로 수송시켰다. 또한, 산소 플라즈마를 이용하여 상기 기판을 5분간 세정한 후 진공 증착기로 기판을 수송시켰다.

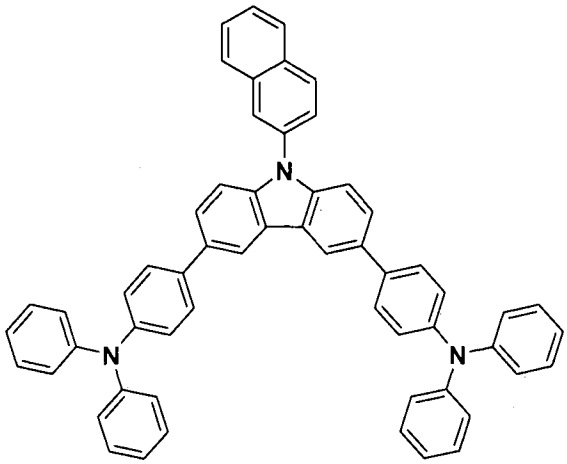
이렇게 준비된 ITO 투명 전극 위에 하기 화학식의 헥사니트릴 헥사아자트리페닐렌 (hexaazatriphenylene; HAT)를 150Å의 두께로 열 진공 증착하여 정공 주입층을 형성하였다.

[HAT]



상기 정공 주입층 위에 정공을 수송하는 물질인 하기 화합물 HT1(1150Å)을 진공 증착하여 정공 수송층을 형성하였다.

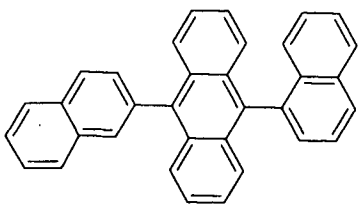
[HT1]



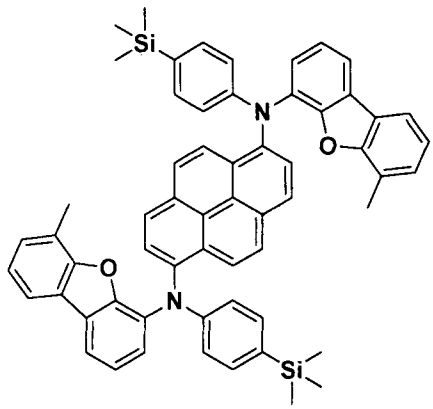
이어서, 상기 정공 수송층 위에 막 두께 150Å으로 상기 제조예 1에서 제조한 화합물 1을 진공 증착하여 전자 차단층을 형성하였다.

이어서, 상기 전자 저지층 위에 막 두께 300Å으로 아래와 같은 BH와 BD를 25:1의 중량비로 진공증착하여 발광층을 형성하였다.

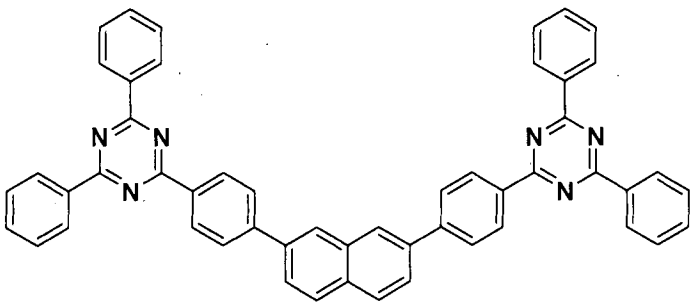
[BH]



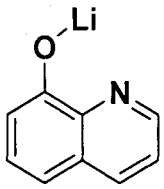
[BD]



[ET]



[LiQ]



상기 발광층 위에 상기 화합물 ET과 상기 화합물 LiQ(Lithium Quinolate)를 1:1의 중량비로 진공증착하여 300Å의 두께로 전자 수송층을 형성하였다. 상기 전자 수송층 위에 순차적으로 12Å두께로 리튬플로라이드(LiF)와 2,000Å 두께로 알루미늄을 증착하여 전자 주입층 및 음극을 형성하였다.

상기의 과정에서 유기물의 증착속도는 0.4~ 0.7Å/sec를 유지하였고, 음극의 리튬플로라이드는 0.3Å/sec, 알루미늄은 2Å/sec의 증착 속도를 유지하였으며, 증착시 진공도는 2×10^{-7} ~5×10^{-6} torr를 유지하여, 유기 발광 소자를 제작하였다.

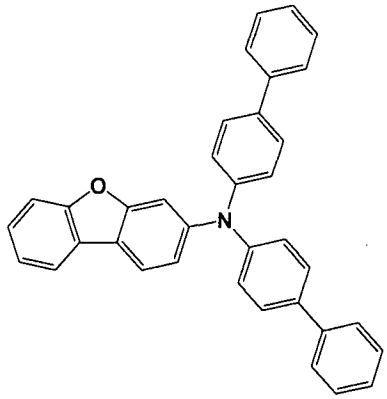
실시예 1-2 내지 실시예 1-15

전자 차단층 형성시 화합물 1 대신 하기 표 1과 같이 변경하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 1-1과 동일한 방법을 이용하여 실시예 1-2 내지 1-15의 유기 발광 소자를 각각 제작하였다.

비교예 1-1

전자 차단층 형성시 화합물 1 대신 하기 EB-1을 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 1-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다

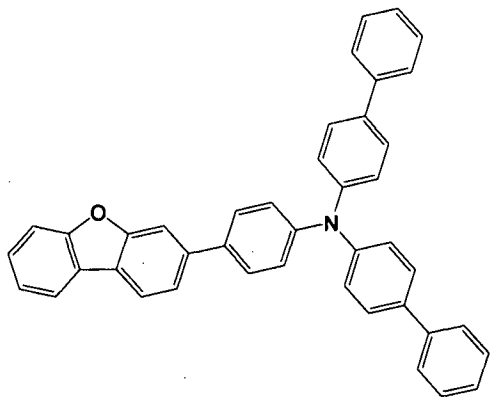
[EB-1]



비교예 1-2

전자 차단층 형성시 화합물 1 대신 하기 EB-2을 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 1-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다

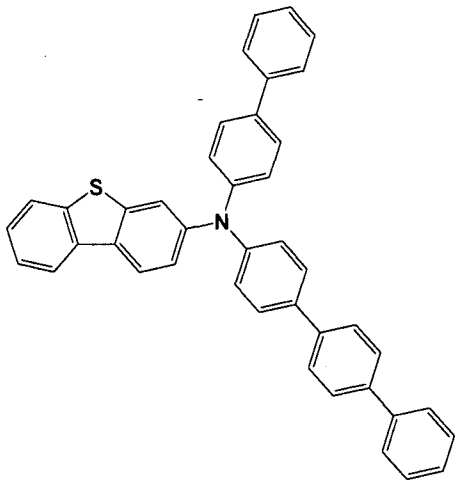
[EB-2]



비교예 1-3

전자 차단층 형성시 화합물 1 대신 하기 EB-3을 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 1-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다

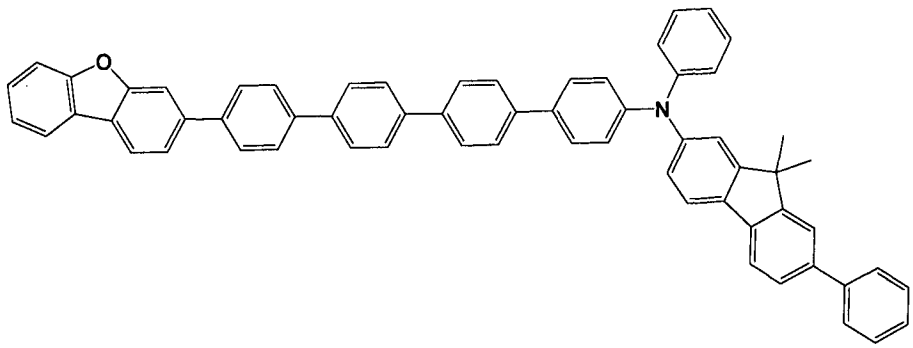
[EB-3]



비교예 1-4

전자 차단층 형성시 화합물 1 대신 하기 EB-4을 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 1-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다

[EB-4]



실험예 1

상기 실시예 1-1 내지 1-15 및 비교예 1-1 내지 1-4에서 제작된 유기 발광 소자에 전류를 인가하여, 전압, 효율, 휘도, 색좌표 및 수명을 측정하고 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다. T95은 휘도가 초기휘도(650nit)에서 95%로 감소되는데 소요되는 시간을 의미한다.

【표 1】

	전자 차단층 화합물	전압 (V@10mA/cm^2)	효율 (cd/A@10mA/cm^2)	색좌표 (x,y)	수명 (T95, h)
실시예 1-1	화합물 1	3.72	5.47	(0.140, 0.045)	225
실시예 1-2	화합물 4	3.86	5.32	(0.140, 0.045)	215
실시예 1-3	화합물 5	3.88	5.31	(0.139, 0.046)	210
실시예 1-4	화합물 6	3.87	5.38	(0.139, 0.047)	230
실시예 1-5	화합물 8	3.74	5.41	(0.138, 0.044)	220
실시예 1-6	화합물 9	3.85	5.28	(0.140, 0.042)	200
실시예 1-7	화합물 11	3.81	5.29	(0.140, 0.041)	205

실시예 1-8	화합물 12	3.72	5.45	(0.141, 0.045)	210
실시예 1-9	화합물 13	3.77	5.42	(0.142, 0.045)	205
실시예 1-10	화합물 14	3.98	5.11	(0.137, 0.047)	245
실시예 1-11	화합물 16	3.94	5.18	(0.136, 0.048)	240
실시예 1-12	화합물 17	3.88	5.31	(0.137, 0.044)	250
실시예 1-13	화합물 19	3.74	5.28	(0.136, 0.045)	215
실시예 1-14	화합물 20	3.68	5.57	(0.142, 0.042)	250
실시예 1-15	화합물 21	3.64	5.58	(0.143, 0.043)	215
비교예 1-1	EB-1	4.05	4.87	(0.136, 0.047)	165

비교예 1-2	EB-2	4.16	4.77	(0.136, 0.048)	170
비교예 1-3	EB-3	4.10	4.82	(0.136, 0.046)	185
비교예 1-4	EB-4	5.12	4.13	(0.136, 0.047)	115

상기 표 1에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 화합물을 전자 차단층으로 사용하여 제조된 유기 발광 소자의 경우에 비교예의 유기 발광 소자에 비하여 구동전압, 전류효율, 수명 및 안정성 측면에서 우수한 성능을 나타냄을 확인할 수 있다.

구체적으로, 본원 발명의 코어와 같은 구조를 가지면서 1번 및 3번 방향에 치환기가 없는 비교예 1-1 내지 1-3의 화합물을 전자억제층으로 사용하여 제조된 유기 발광 소자는, 실시예 대비 효율이 10% 이상, 수명은 30% 이상 떨어지는 결과를 나타내었다.

한편, 비교예 1-4의 화합물은 코어와 아릴아민기 사이의 거리가 너무 멀어서 유기 발광 소자의 특성이 크게 나빠지는 결과를 보였다.

이에, 본원 발명 실시예의 화합물의 경우, 소자의 효율을 높여주는 동시에 안정성이 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었다.

실시예 2-1

ITO(indium tin oxide)가 1,000Å의 두께로 박막 코팅된 유리 기판을 세제를 녹인 증류수에 넣고 초음파로 세척하였다. 이 때, 세제로는 피셔사(Fischer Co.) 제품을 사용하였으며, 증류수로는 밀러포어사(Millipore

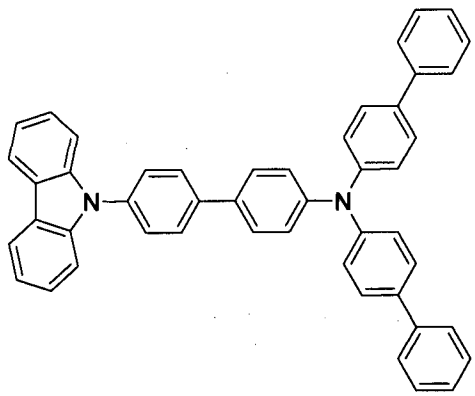
Co.) 제품의 필터(Filter)로 2차로 걸러진 증류수를 사용하였다. ITO를 30분간 세척한 후 증류수로 2회 반복하여 초음파 세척을 10분간 진행하였다. 증류수 세척이 끝난 후, 이소프로필알콜, 아세톤, 메탄올의 용제로 초음파 세척을 하고 건조시킨 후 플라즈마 세정기로 수송시켰다. 또한, 산소 플라즈마를 이용하여 상기 기판을 5분간 세정한 후 진공 증착기로 기판을 수송시켰다.

이렇게 준비된 ITO 투명 전극 위에 상기 HAT를 150Å의 두께로 열 진공 증착하여 정공 주입층을 형성하였다.

상기 정공 주입층 위에 정공을 수송하는 물질로서 상기 제조예 1에서 제조한 화합물 1을 막 두께 1150Å으로 진공 증착하여 정공 수송층을 형성하였다.

이어서, 상기 정공 수송층 위에 막 두께 150Å으로 하기 화합물 EB를 진공 증착하여 전자 차단층을 형성하였다.

[EB]



이어서, 상기 전자 저지층 위에 막 두께 300Å으로 상기 BH와 BD를 25:1의 중량비로 진공증착하여 발광층을 형성하였다.

상기 발광층 위에 상기 화합물 ET과 상기 화합물 LiQ(Lithium Quinolate)를 1:1의 중량비로 진공증착하여 300Å의 두께로 전자 수송층을 형성하였다. 상기 전자 수송층 위에 순차적으로 12Å두께로 리튬플로라이드(LiF)와 2,000Å 두께로 알루미늄을 증착하여 전자 주입층 및 음극을 형성하였다.

상기의 과정에서 유기물의 증착속도는 0.4~ 0.7Å/sec를 유지하였고, 음극의 리튬플로라이드는 0.3Å/sec, 알루미늄은 2Å/sec의 증착 속도를 유지하였으며, 증착시 진공도는 2×10^{-7} ~5×10^{-6} torr를 유지하여, 유기

발광 소자를 제작하였다.

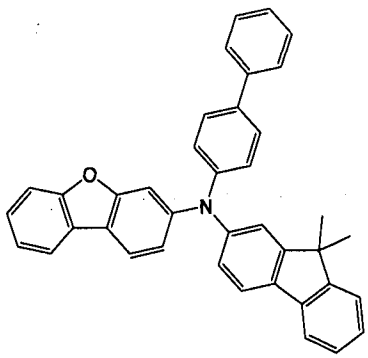
실시예 2-2 내지 실시예 2-12

정공 수송층 형성시 전자 수송 물질을 화합물 1 대신 하기 표 2와 같이 변경하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 2-1과 동일한 방법을 이용하여 실시예 2-2 내지 2-12의 유기 발광 소자를 각각 제작하였다.

비교예 2-1

정공 수송층 형성시 전자 수송 물질을 화합물 1 대신 하기 HT-1을 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 2-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다.

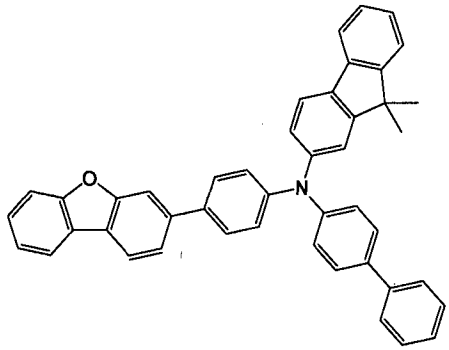
[HT-1]



비교예 2-2

정공 수송층 형성시 전자 수송 물질을 화합물 1 대신 하기 HT-2를 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 2-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다.

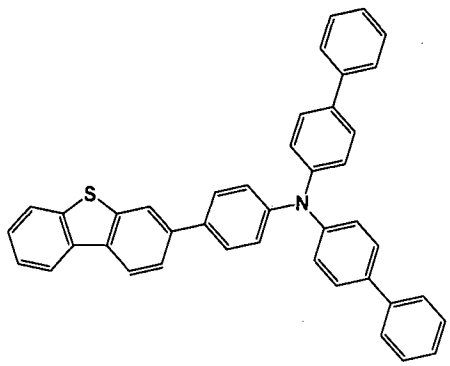
[HT-2]



비교예 2-3

정공 수송층 형성시 전자 수송 물질을 화합물 1 대신 하기 HT-3을 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 2-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다.

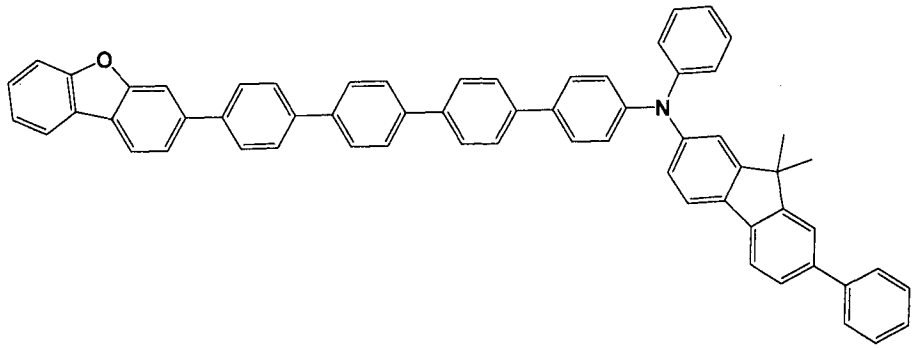
[HT-3]



비교예 2-4

정공 수송층 형성시 전자 수송 물질을 화합물 1 대신 하기 HT-4을 사용하였다는 점을 제외하고는, 상기 실시예 2-1과 동일한 방법을 이용하여 유기 발광 소자를 제작하였다.

[HT-4]



실험예 2

상기 실시예 2-1 내지 2-12 및 비교예 2-1 내지 2-4에서 제작된 유기 발광 소자에 전류를 인가하여, 전압, 효율, 휘도, 색좌표 및 수명을 측정하고 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다. T95은 휘도가 초기휘도(650nit)에서 95%로 감소되는데 소요되는 시간을 의미한다.

【표 2】

	정공 수송층 화합물	전압 (V@10mA/cm^2)	효율 (cd/A@10mA/cm^2)	색좌표 (x,y)	수명 (T95, h)
실시예 2-1	화합물 1	3.81	5.53	(0.140, 0.045)	260
실시예 2-2	화합물 2	3.95	5.42	(0.140, 0.045)	250
실시예 2-	화합물 3	3.94	5.44	(0.139,	255

3				0.046)	
실시예 2-4	화합물 4	3.96	5.45	(0.139, 0.047)	275
실시예 2-5	화합물 6	3.87	5.57	(0.138, 0.044)	265
실시예 2-6	화합물 7	3.99	5.38	(0.140, 0.042)	245
실시예 2-7	화합물 9	3.91	5.39	(0.140, 0.041)	240
실시예 2-8	화합물 10	3.82	5.59	(0.141, 0.045)	255
실시예 2-9	화합물 15	3.85	5.55	(0.142, 0.045)	240
실시예 2-10	화합물 18	4.01	5.26	(0.137, 0.047)	280
실시예 2-11	화합물 20	3.86	5.43	(0.142, 0.041)	270

실시예 2-12	화합물 21	3.73	5.42	(0.143, 0.042)	265
비교예 2-1	HT-1	4.13	4.83	(0.136, 0.047)	200
비교예 2-2	HT-2	4.21	4.74	(0.136, 0.048)	215
비교예 2-3	HT-3	4.29	4.87	(0.136, 0.046)	220
비교예 2-4	HT-4	4.92	4.10	(0.143, 0.042)	110

상기 표 2에서 보는 바와 같이, 본 발명에 따른 화합물을 정공 수송층으로 사용하여 제조된 유기 발광 소자의 경우에 비교예의 유기 발광 소자에 비하여 전류효율, 구동전압, 수명 및 안정성 측면에서 우수한 성능을 나타냄을 확인할 수 있다.

구체적으로, 본원 발명의 코어와 같은 구조를 가지면서 1번 및 3번 방향에 치환기가 없는 비교예 2-1 내지 2-3의 화합물을 정공수송층으로 사용하여 제조된 유기 발광 소자는, 실시예 대비 효율이 10% 이상, 수명은 30% 이상 떨어지는 결과를 나타내었다.

한편, 비교예 2-4의 화합물은 코어와 아릴아민기 사이의 거리가 너무 멀어서 유기 발광 소자의 특성이 크게 나빠지는 결과를 보였다.

이에, 본원 발명 실시예의 화합물의 경우, 소자의 효율을 높여주는 동시에 안정성이 크게 증가하는 것을 확인할 수 있었다.

따라서, 본 발명에 따른 화합물은 전자 차단 능력뿐만 아니라, 정공 수송 능력이 우수하여 유기 발광 소자의 전자차단층 및/또는 정공수송층에 적용 가능함을 알 수 있다.

【부호의 설명】

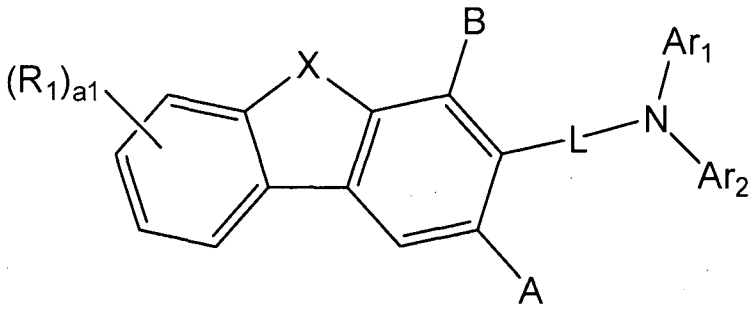
1: 기판	2: 양극
3: 발광층	4: 음극
5: 정공주입층	6: 정공수송층
7: 발광층	8: 전자수송층

【청구범위】

【청구항 1】

하기 화학식 1로 표시되는 화합물:

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

X는 O 또는 S이고,

A 및 B는 각각 독립적으로, 수소; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 내지 3개 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴이되, A 및 B가 모두 수소인 경우는 제외하고,

L은 단일 결합; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴렌; 또는 치환 또는 비치환된 O, N, Si 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 이상을 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴렌이고,

Ar_1 및 Ar_2는 각각 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 내지 3개 포함하는 C_{2-60} 헤테로아릴이고,

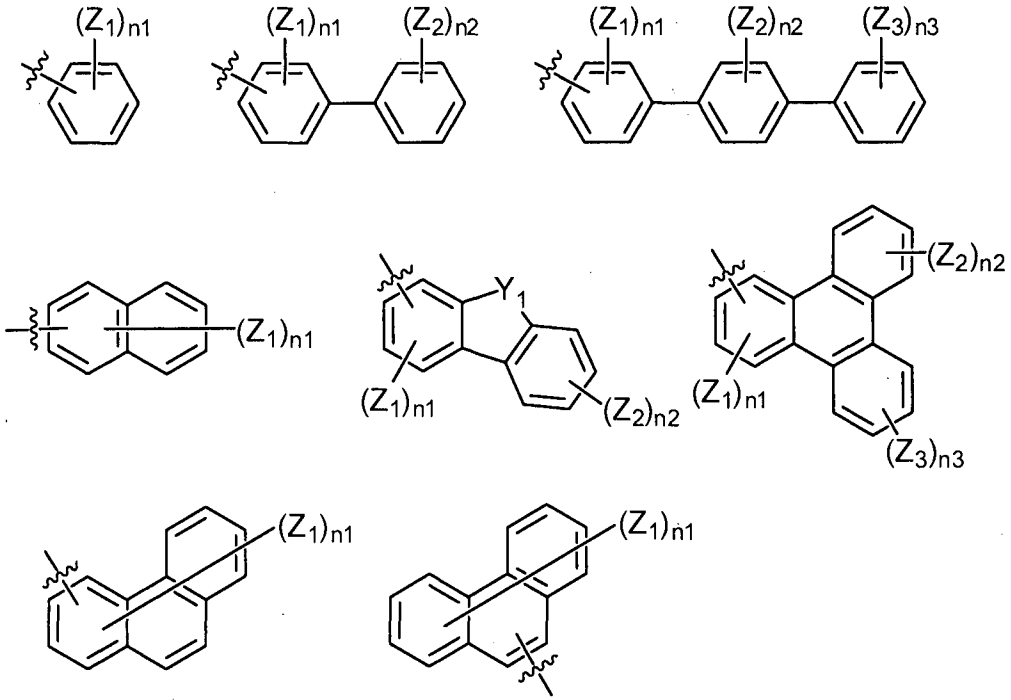
R_1은 수소; 중수소; 할로겐; 시아노; 니트로; 아미노; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 알킬; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 할로알킬; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 알콕시; 치환 또는 비치환된 C_{1-60} 할로알콕시; 치환 또는 비치환된 C_{3-60} 사이클로알킬; 치환 또는 비치환된 C_{2-60} 알케닐; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴; 치환 또는 비치환된 C_{6-60} 아릴옥시; 또는 치환 또는 비치환된 N, O 및 S로 구성되는 군으로부터 선택되는 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C_{2-60} 헤테로고리기이고,

a1은 0 내지 4의 정수이다.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

A 및 B는 각각 독립적으로, 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:



상기에서,

Y_1은 O, S, 또는 CZ_4Z_5이고,

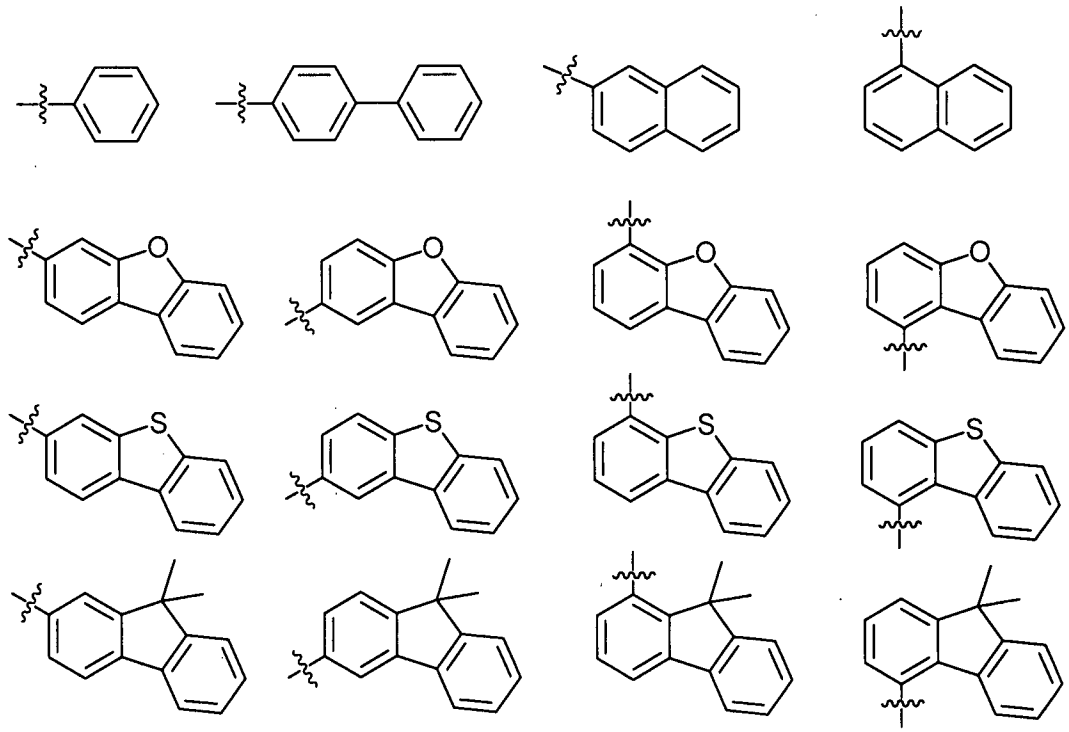
Z_1 내지 Z_5는 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로겐; 시아노; 니트로; 아미노; C_{1-20} 알킬; C_{1-20} 할로알킬; C_{6-20} 아릴; O 또는 S의 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴이고,

n1 내지 n3는 각각 독립적으로, 0 내지 3의 정수이다.

【청구항 3】

제2항에 있어서,

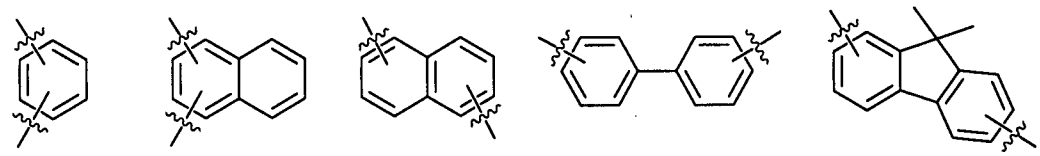
A 및 B는 각각 독립적으로, 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:



【청구항 4】

제1항에 있어서,

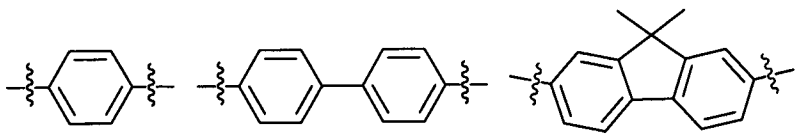
L은 단일 결합, 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:



【청구항 5】

제4항에 있어서,

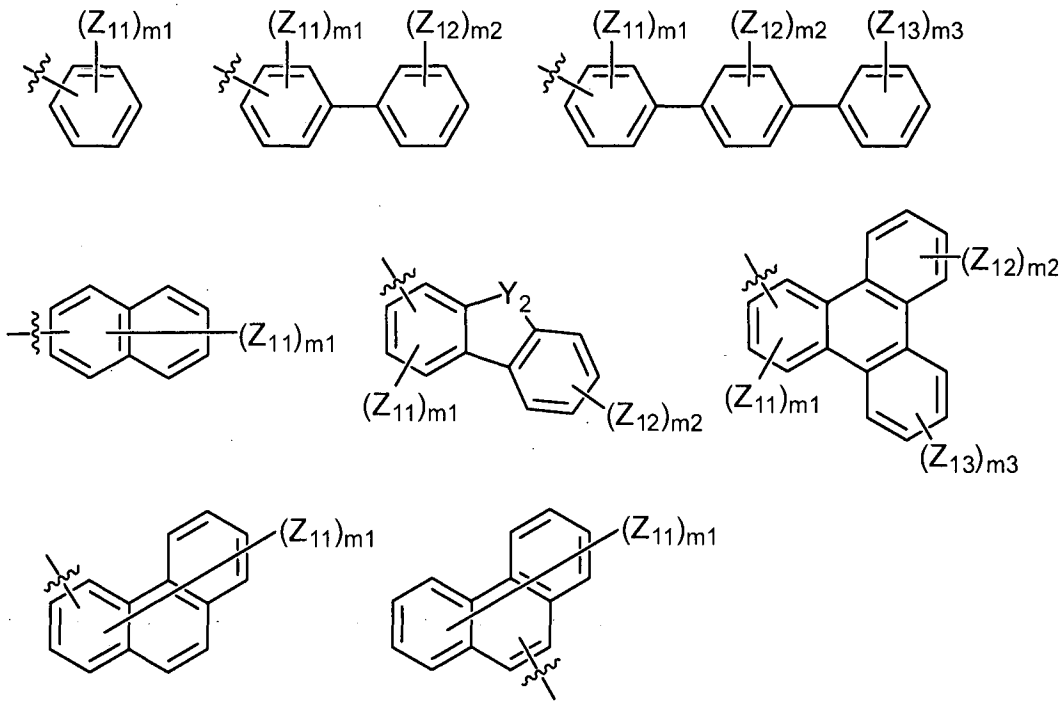
L은 단일 결합, 또는 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:



【청구항 6】

제1항에 있어서,

Ar_1 및 Ar_2는 각각 독립적으로, 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:



상기에서,

Y_2는 O, S, 또는 $CZ_{14}Z_{15}$이고,

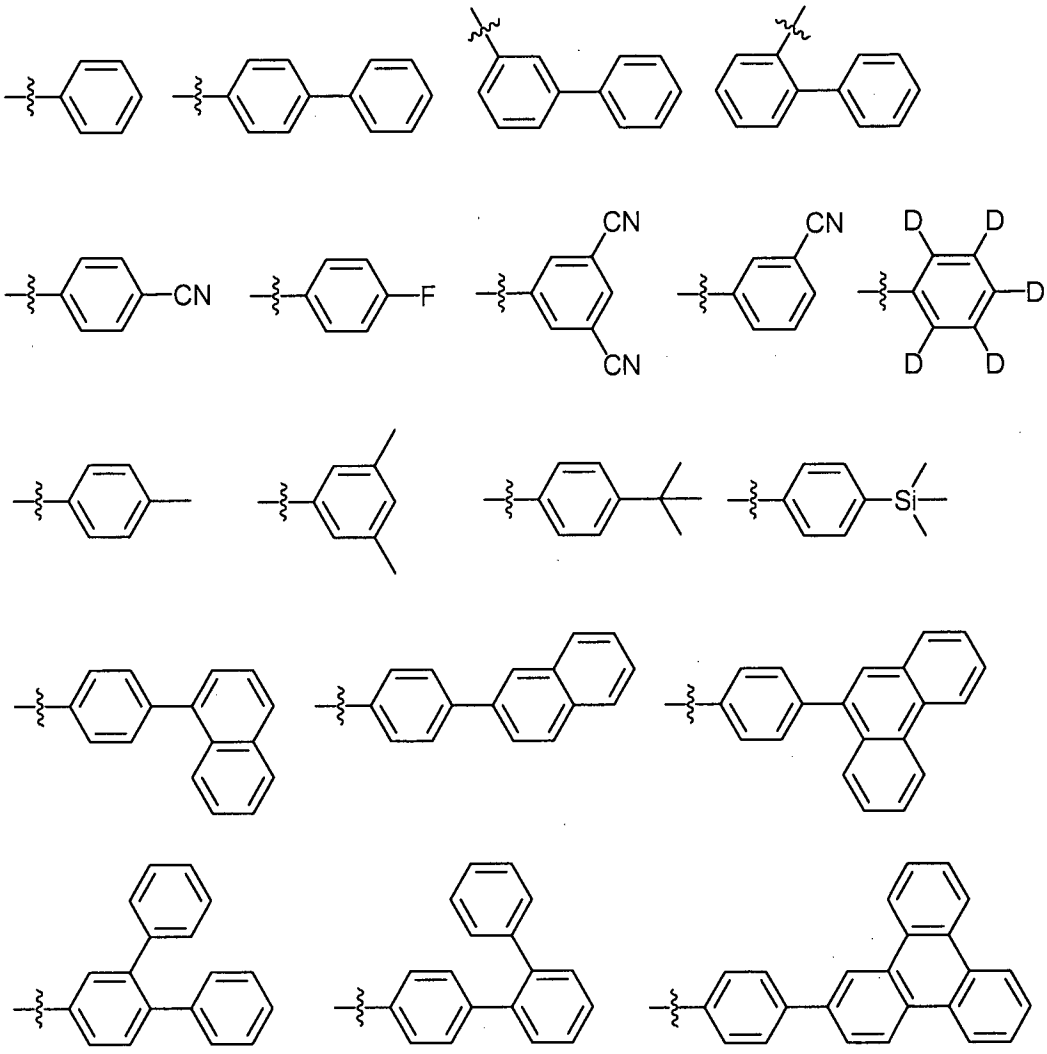
Z_{11} 내지 Z_{15}는 각각 독립적으로, 수소; 중수소; 할로겐; 시아노; 니트로; 아미노; 실릴; C_{1-20} 알킬; C_{1-20} 할로알킬; C_{6-20} 아릴; O 또는 S의 헤테로원자를 1개 이상 포함하는 C_{2-20} 헤테로아릴이되, Z_{14} 및 Z_{15}는 서로 연결되어 단환 또는 다환의 고리를 형성할 수 있고,

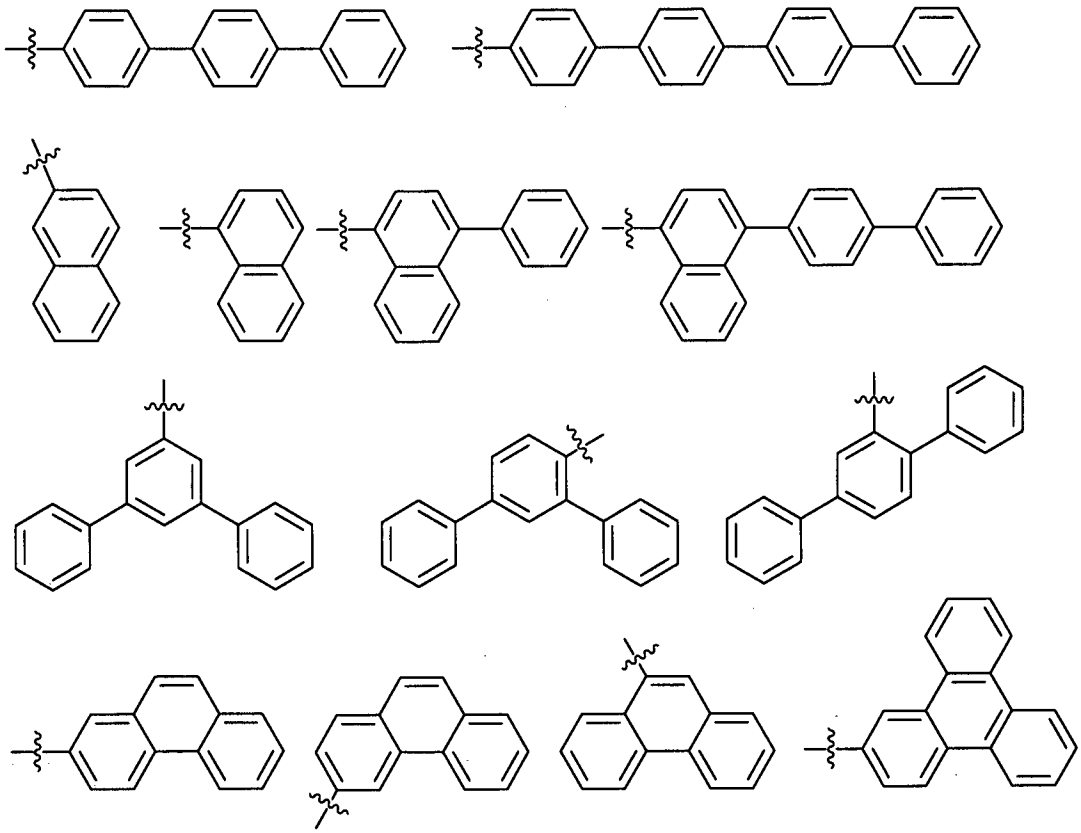
m1 내지 m3는 각각 독립적으로, 0 내지 3의 정수이다.

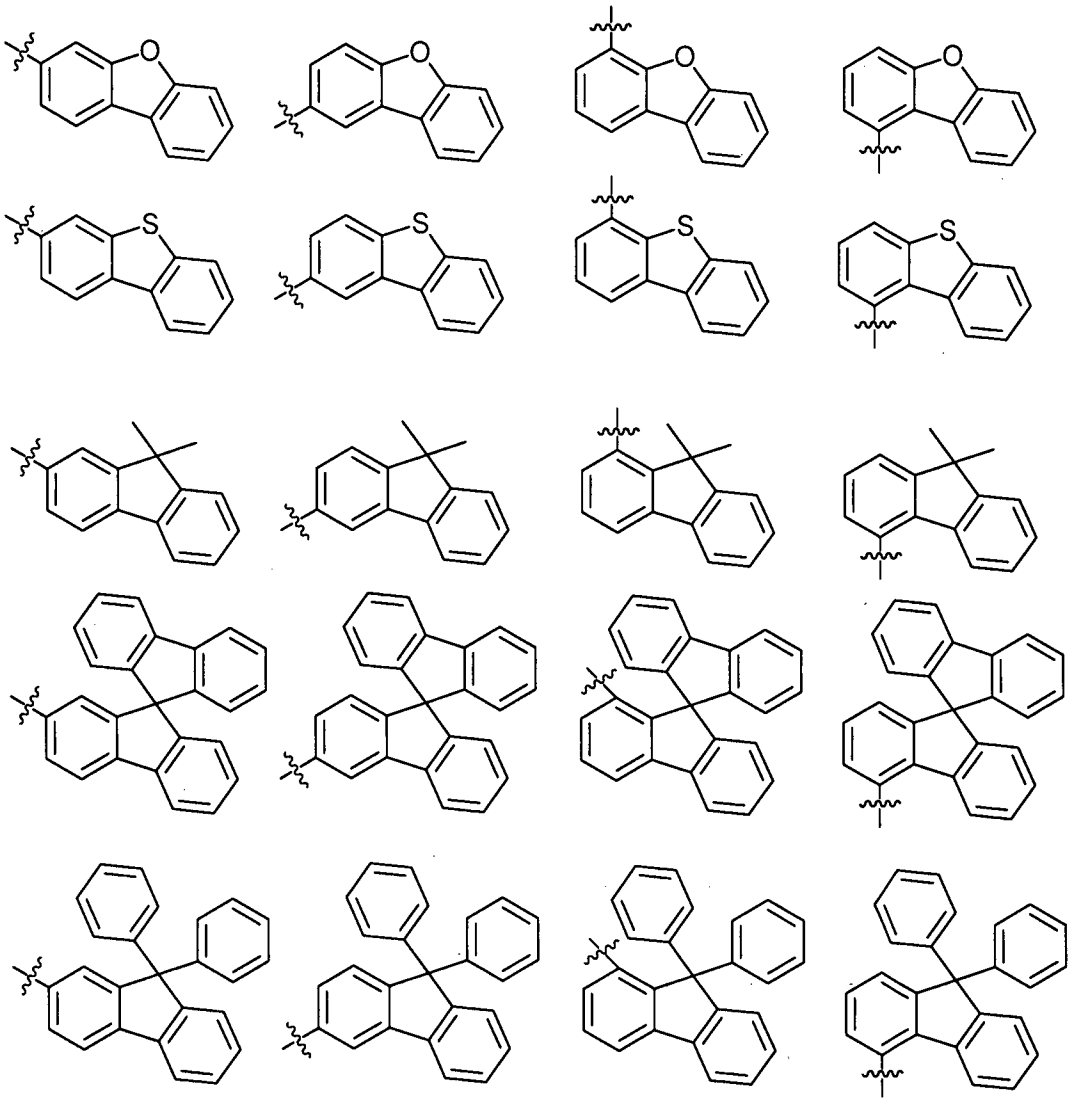
【청구항 7】

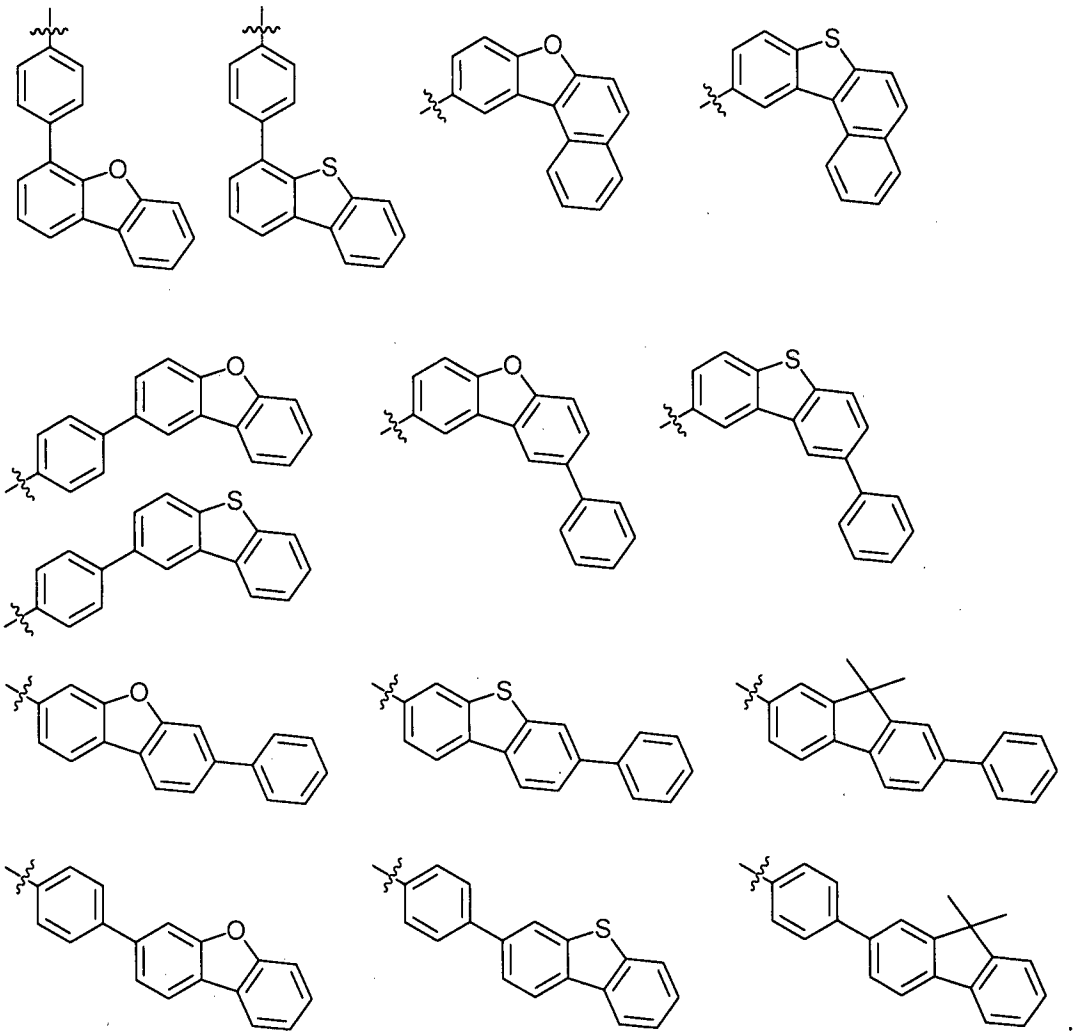
제6항에 있어서,

Ar_1 및 Ar_2는 각각 독립적으로, 하기로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:


CN
F
CN
CN
CN
D
D
D
D
D
Si







【청구항 8】

제1항에 있어서,

R_1은 수소, 중수소, 할로겐, 시아노, 니트로, 메틸, 또는 페닐이고,

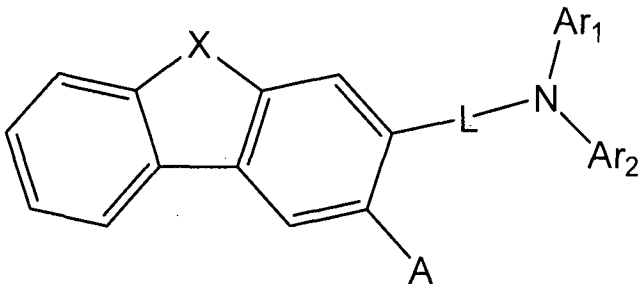
a1은 0 또는 1인, 화합물.

【청구항 9】

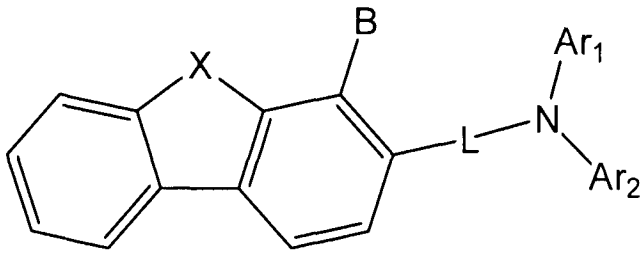
제1항에 있어서,

상기 화합물은 하기 화학식 1A 또는 1B로 표시되는, 화합물:

[화학식 1A]



[화학식 1B]



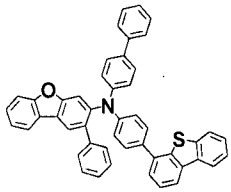
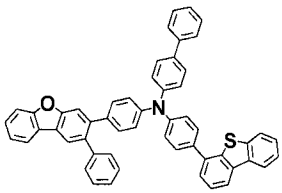
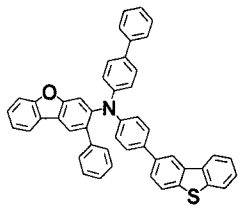
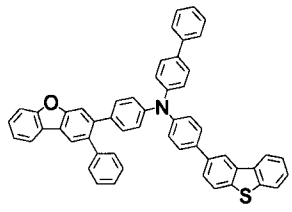
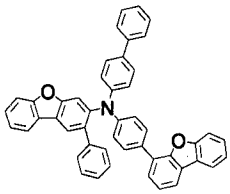
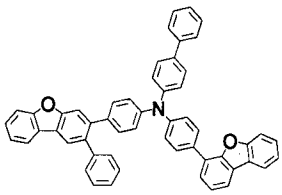
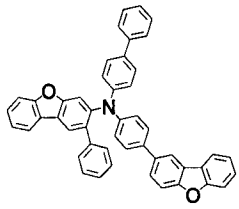
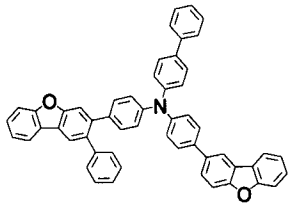
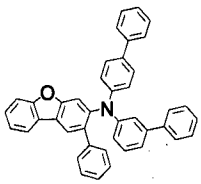
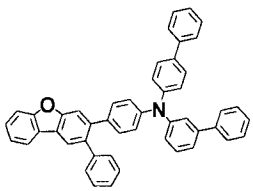
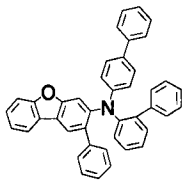
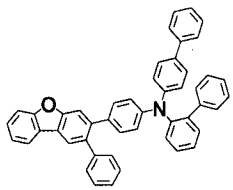
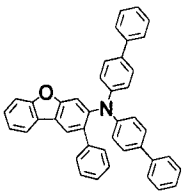
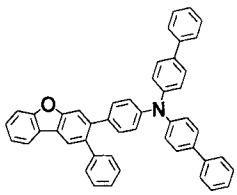
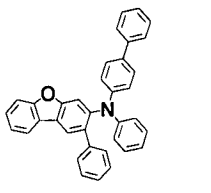
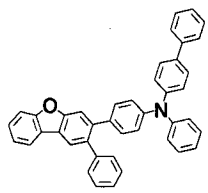
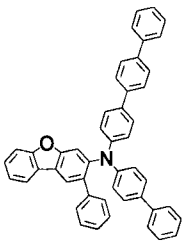
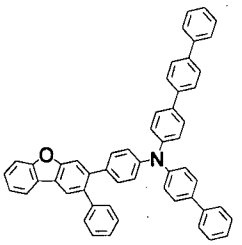
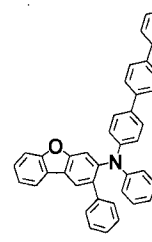
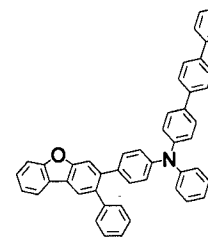
상기 화학식 1A 및 1B 에서,

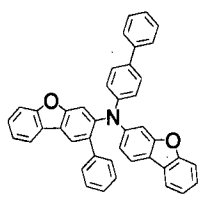
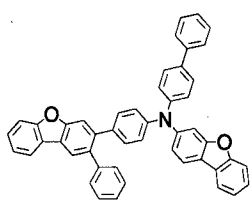
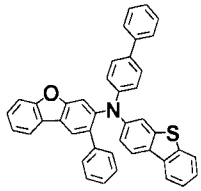
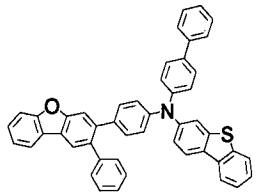
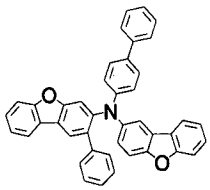
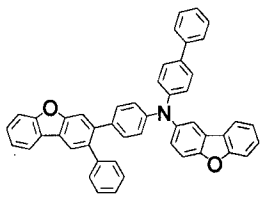
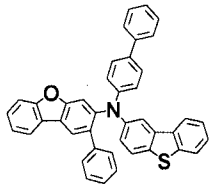
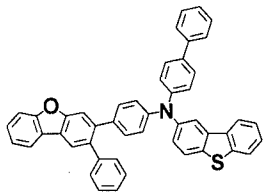
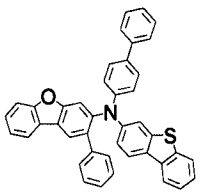
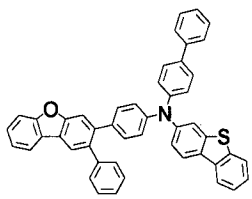
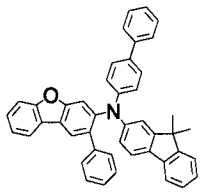
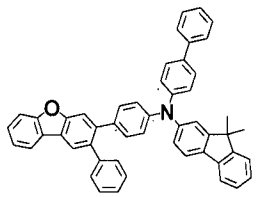
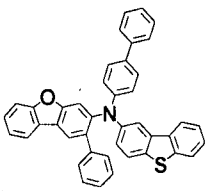
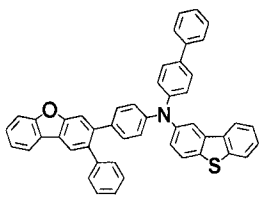
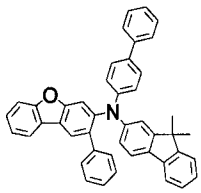
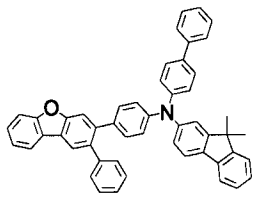
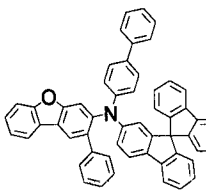
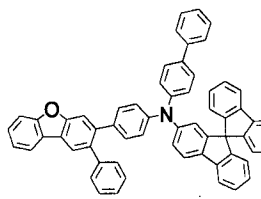
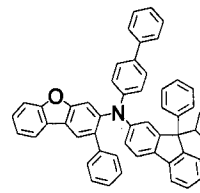
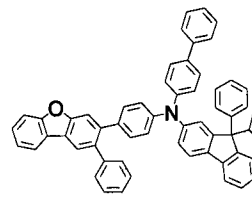
X, A, B, L, Ar_1 및 Ar_2에 대한 설명은 제1항에서 정의한 바와 같다.

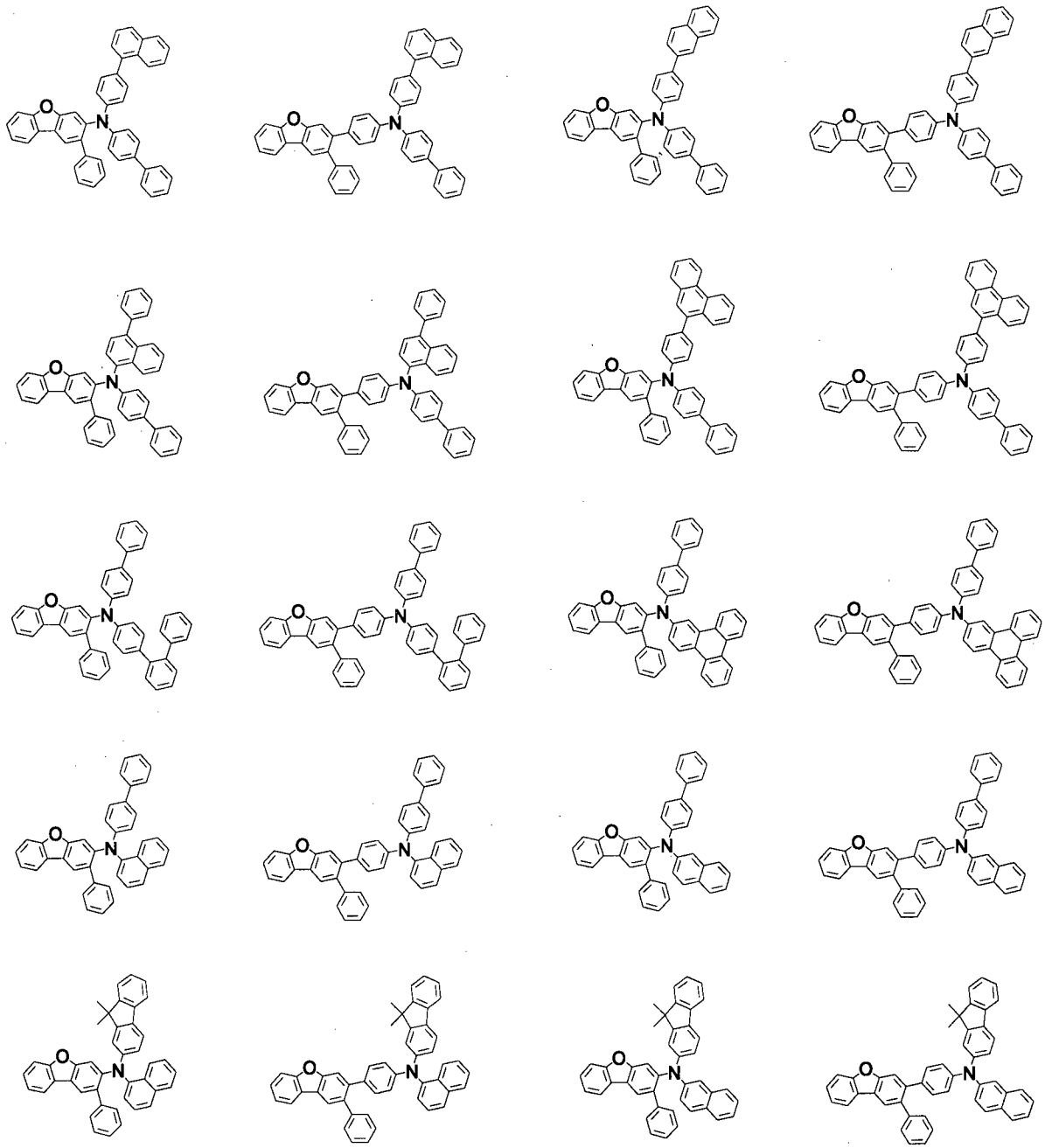
【청구항 10】

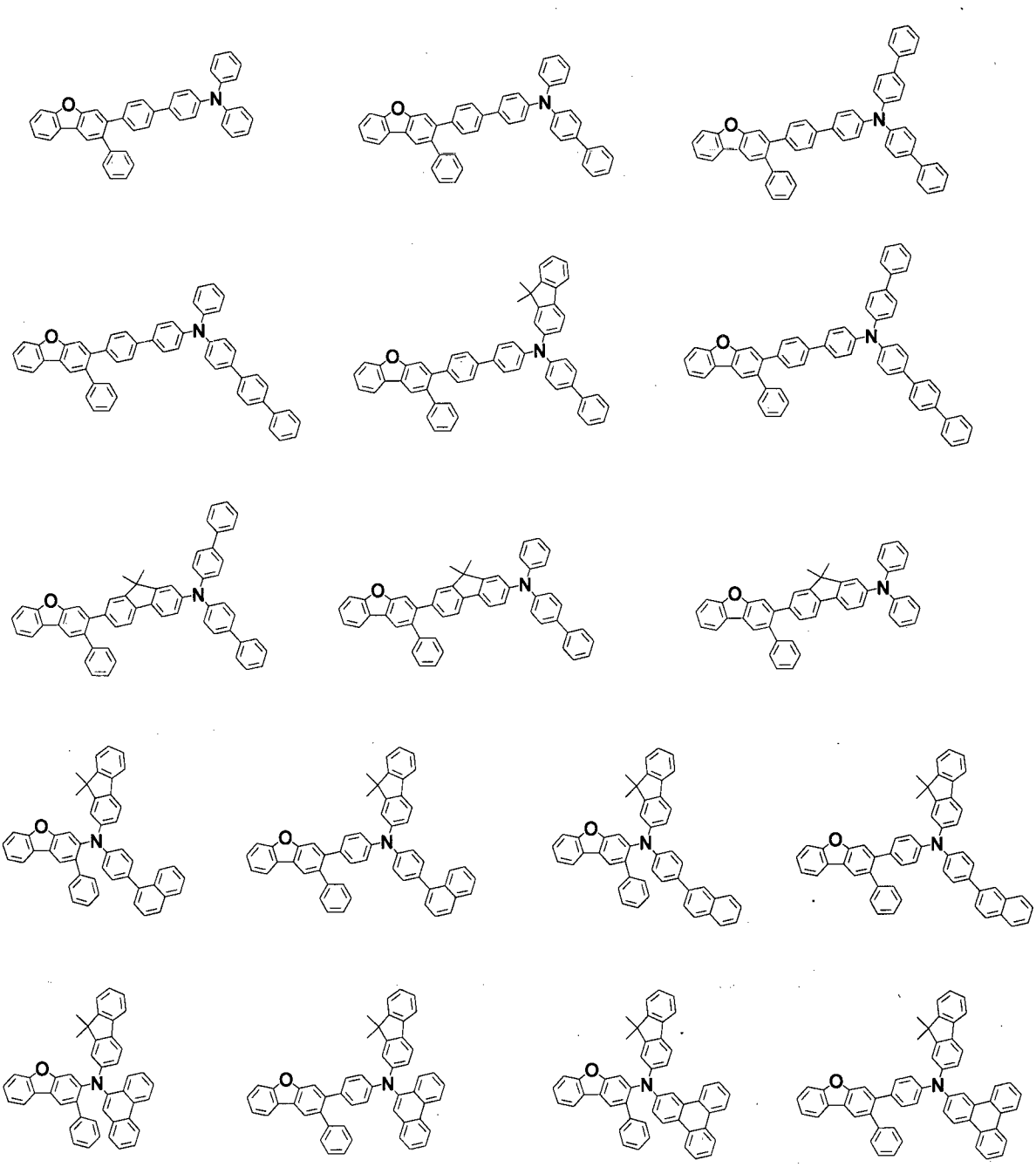
제1항에 있어서,

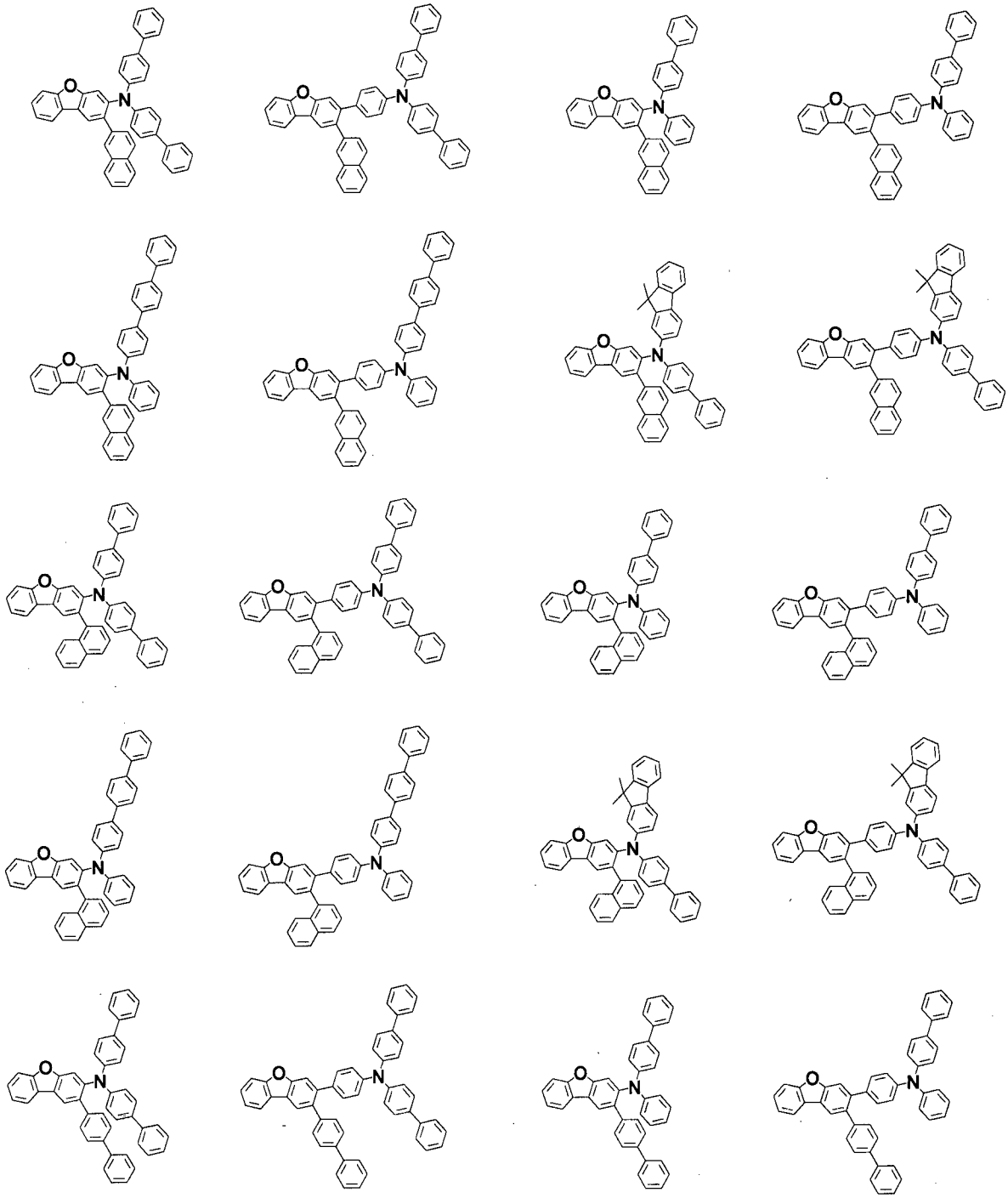
상기 화합물은 하기 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 하나인, 화합물:

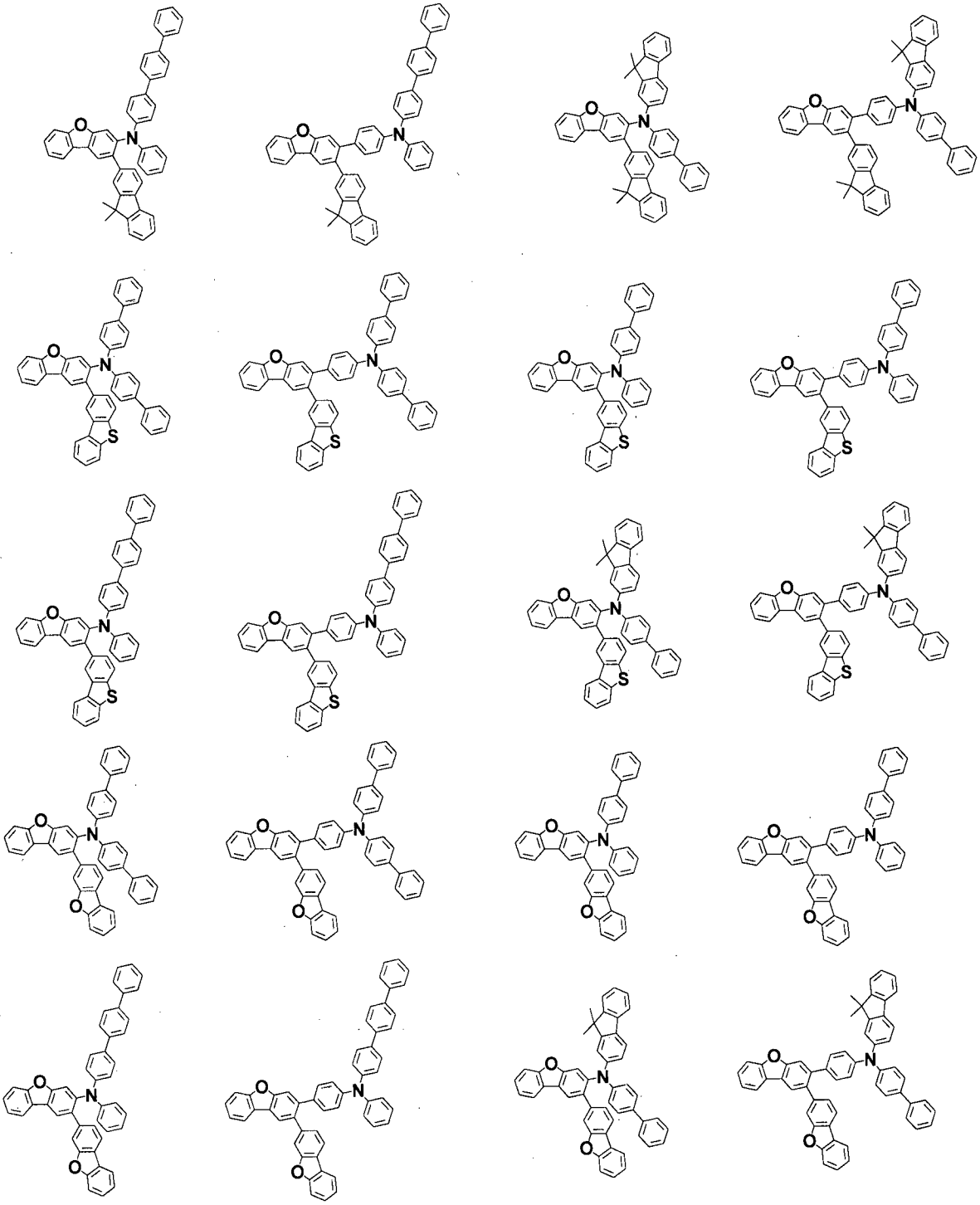





















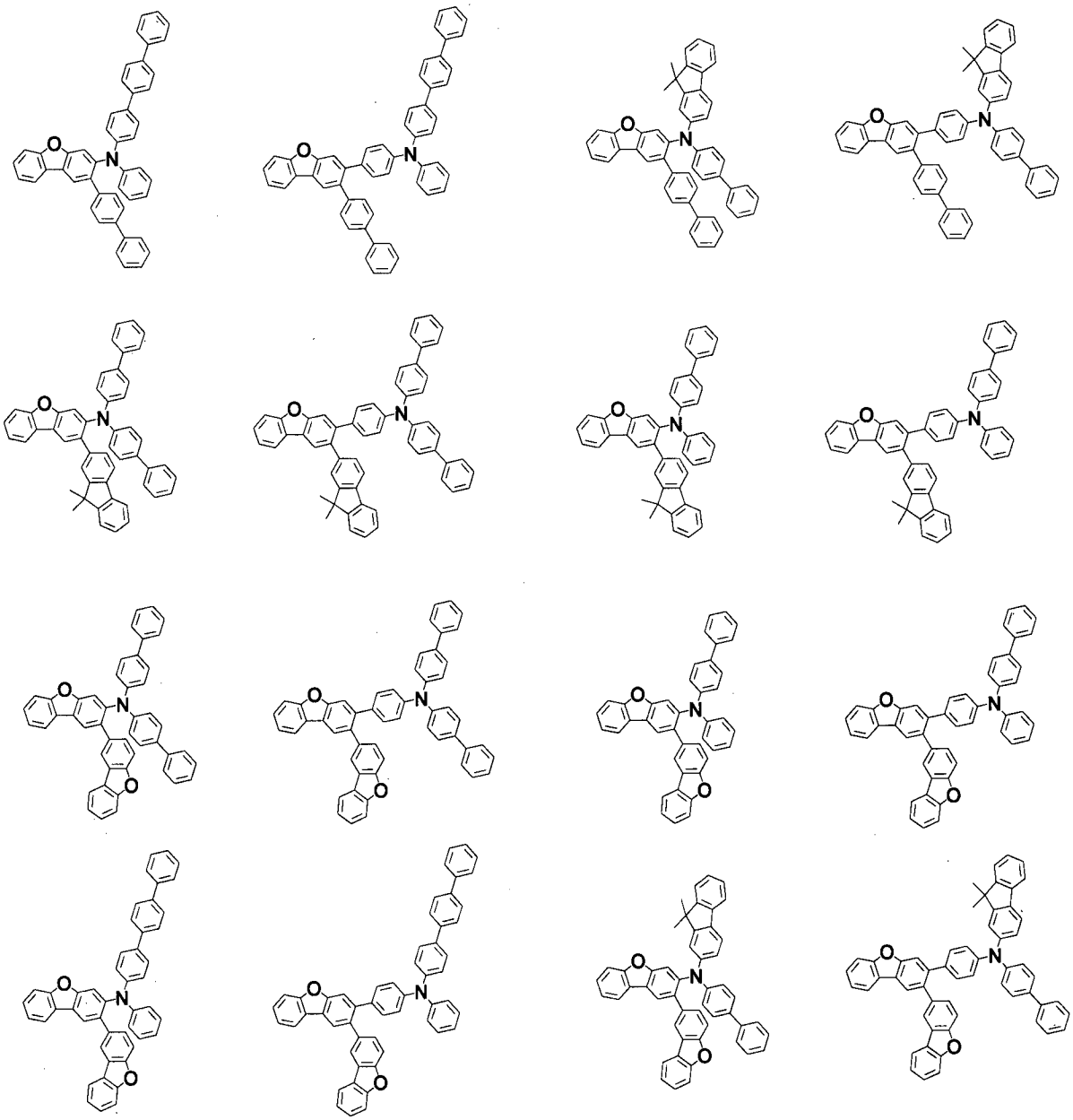





















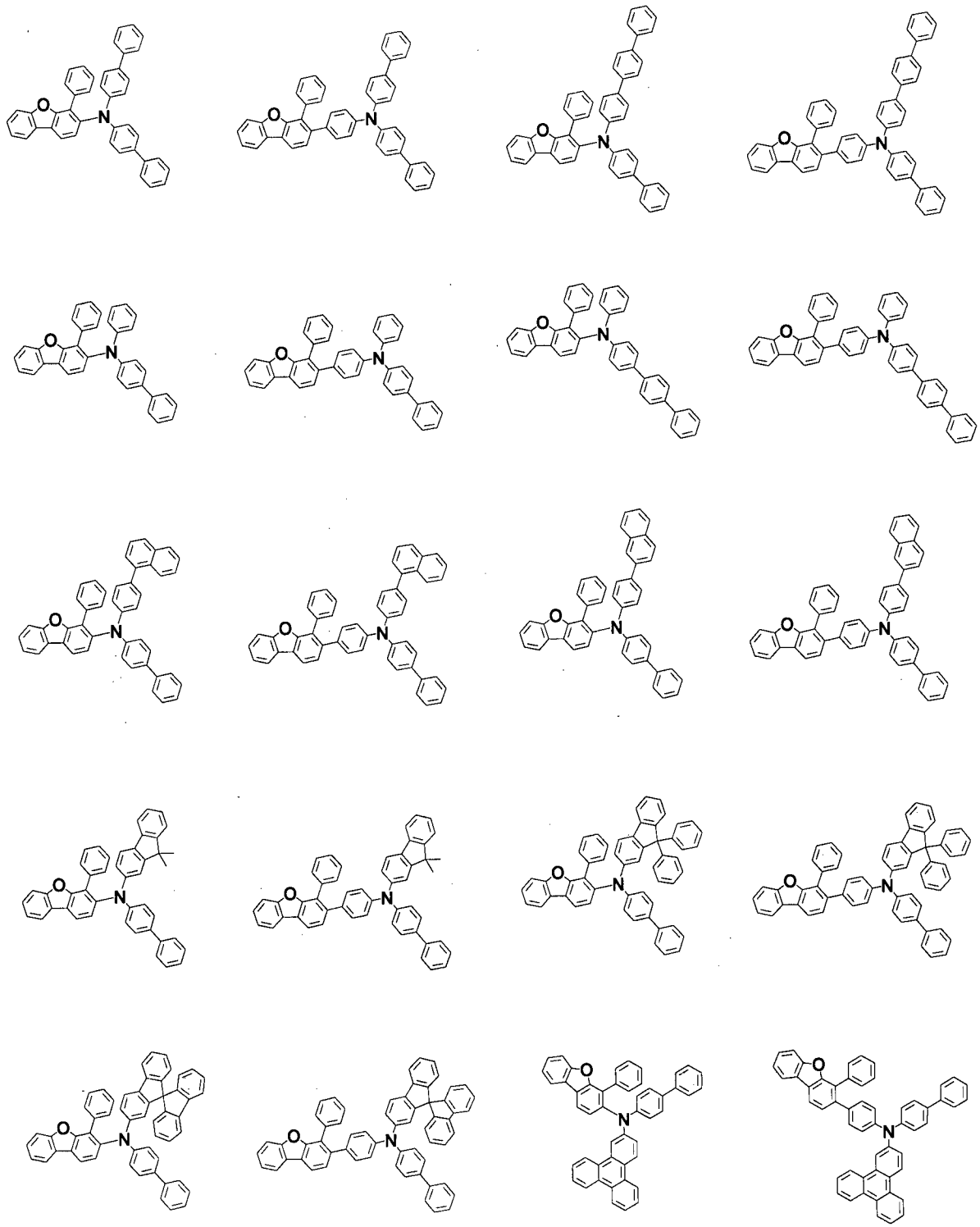


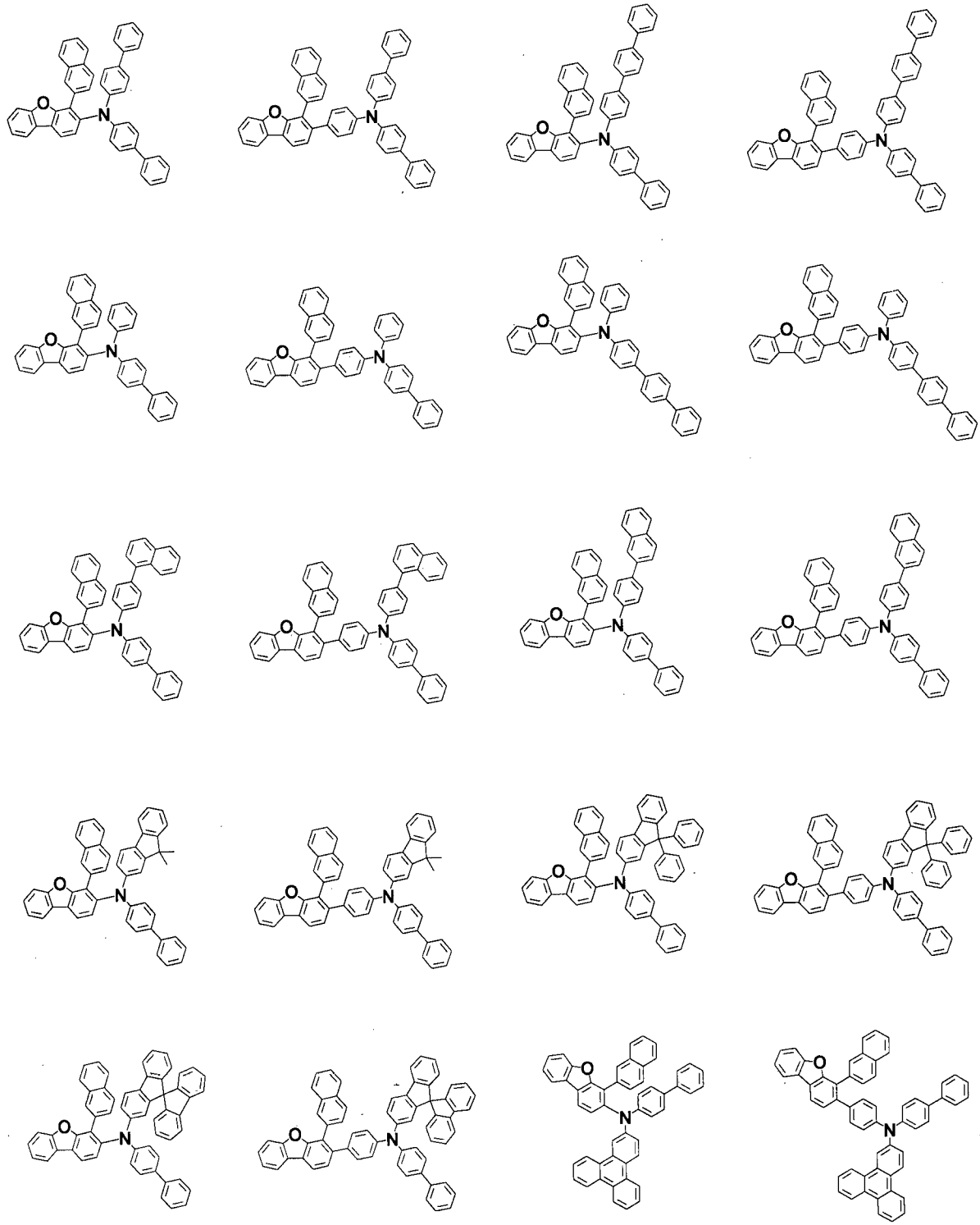


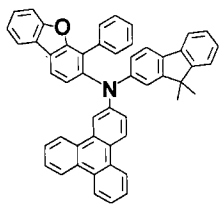
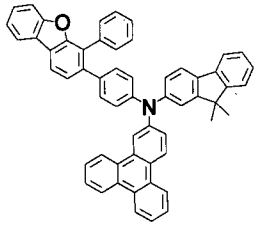
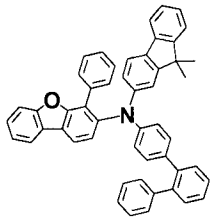
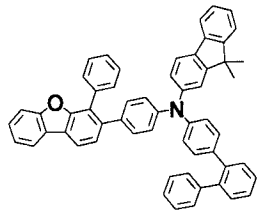
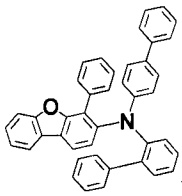
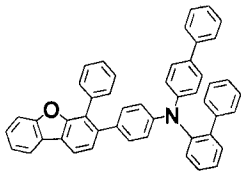
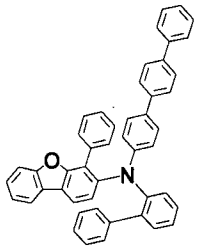
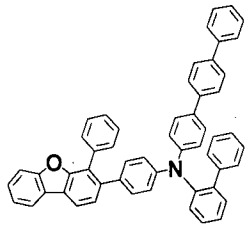
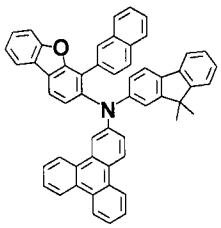
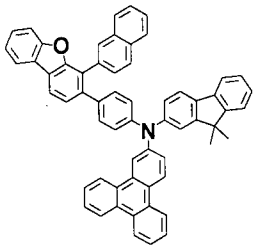
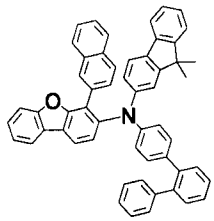
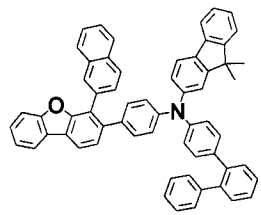
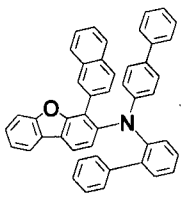
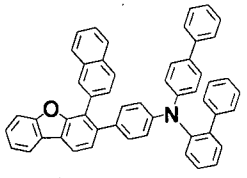
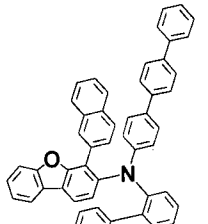


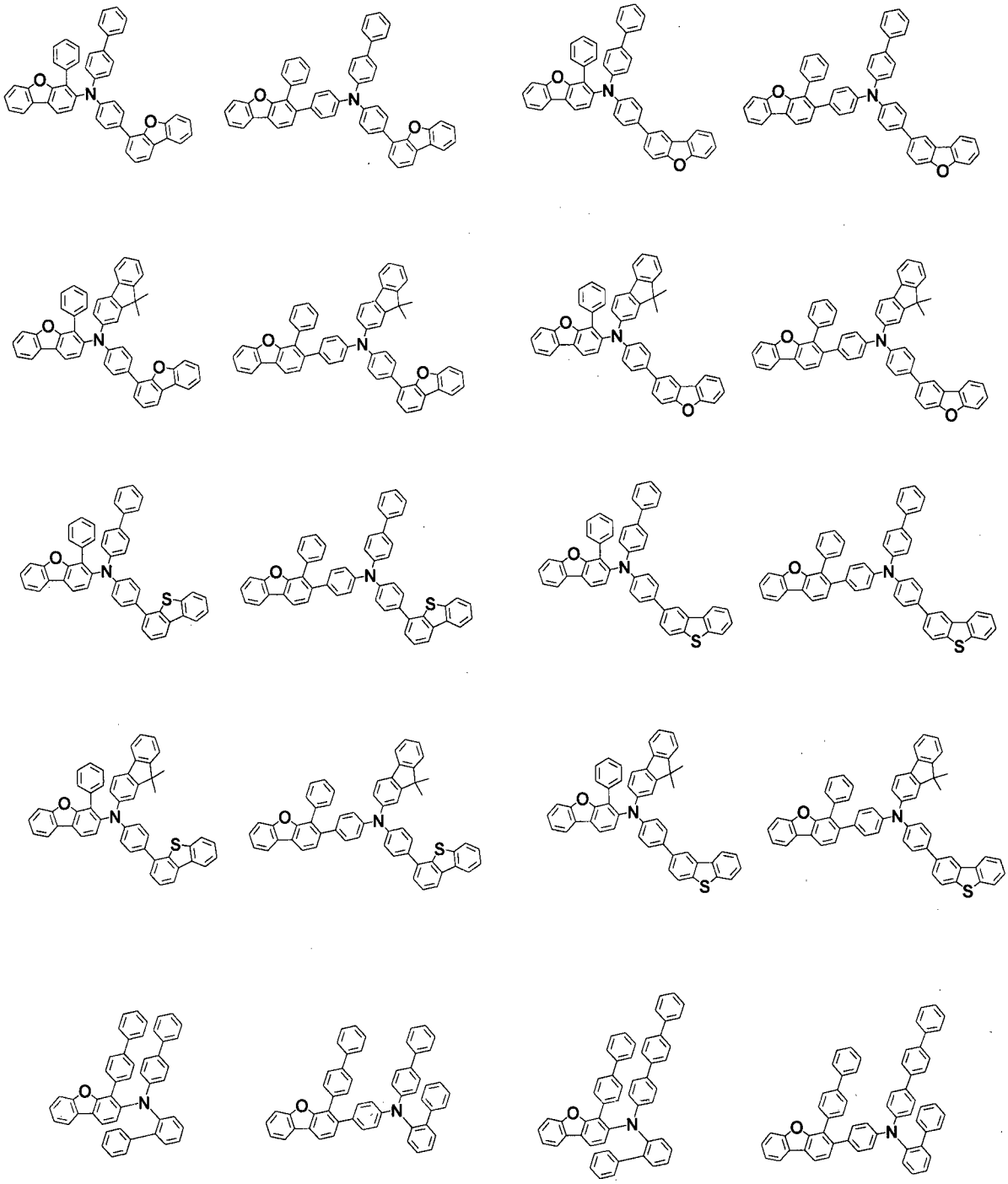


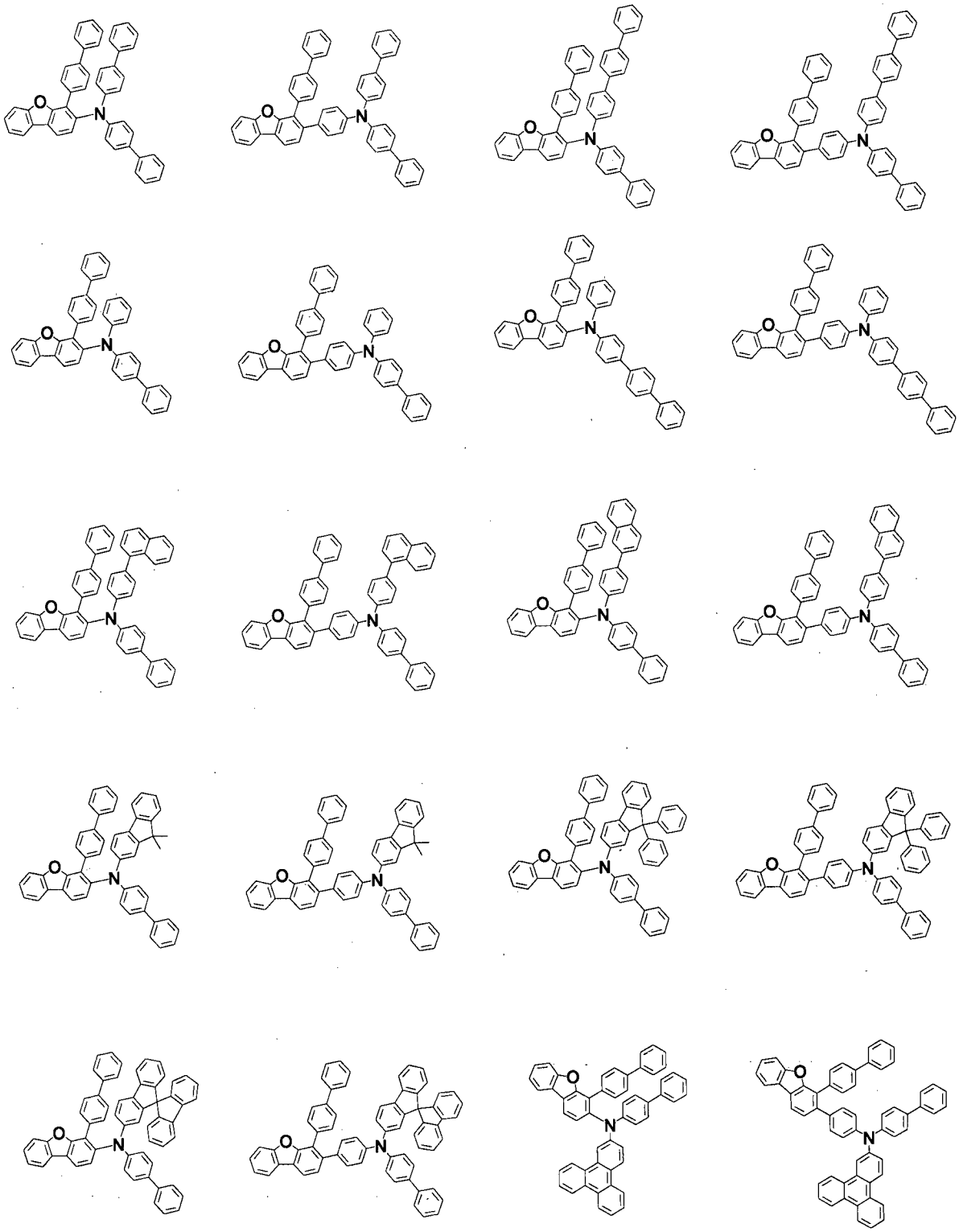


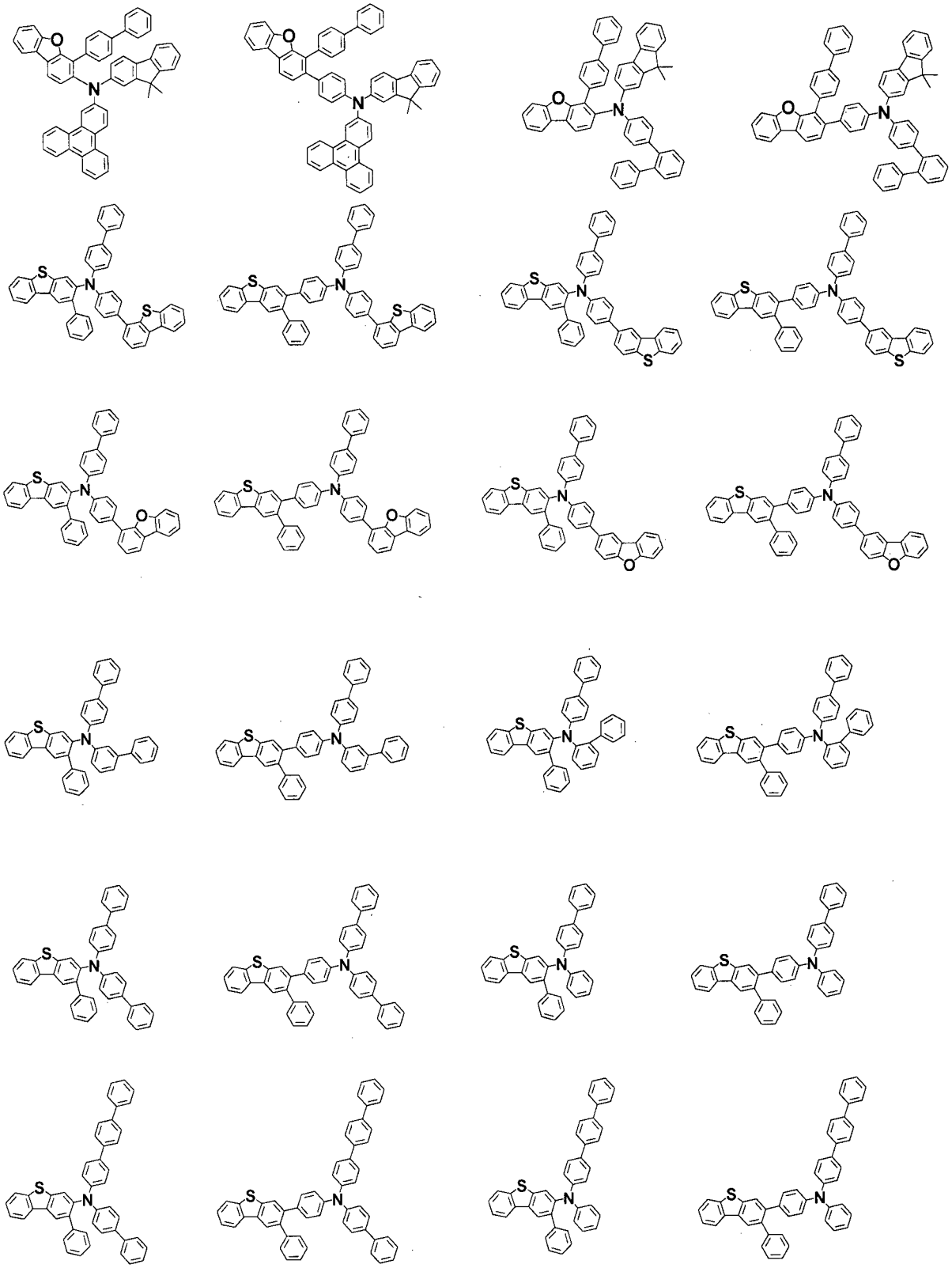


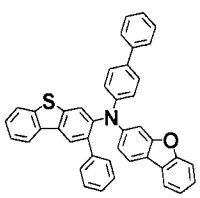
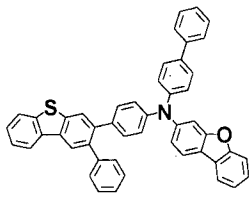
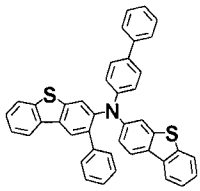
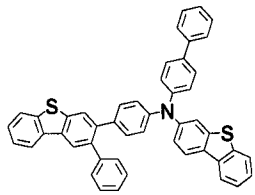
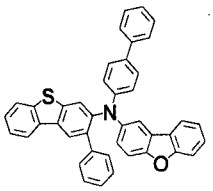
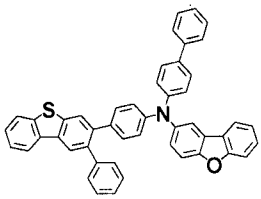
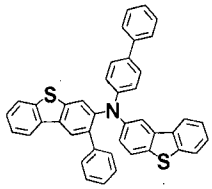
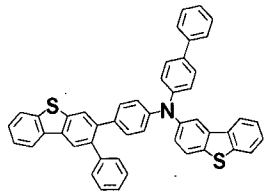
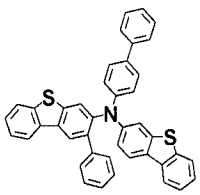
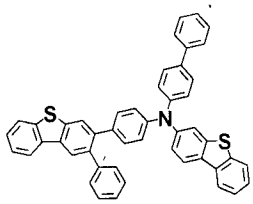
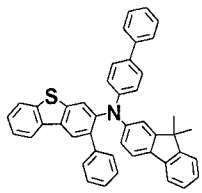
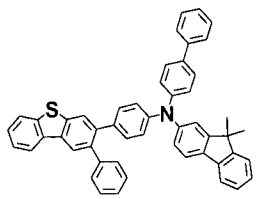
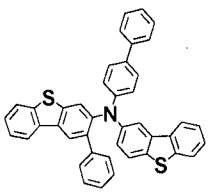
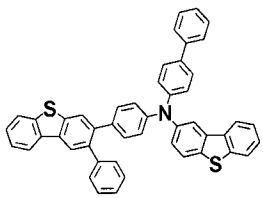
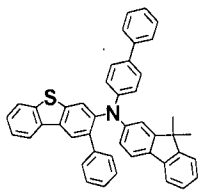
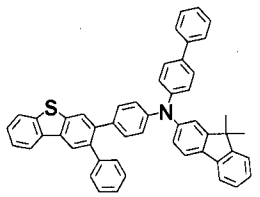
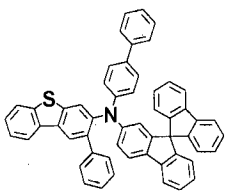
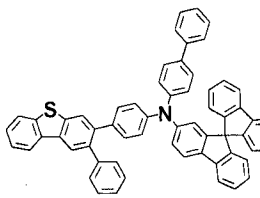
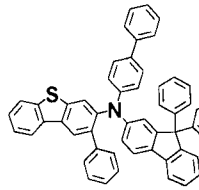
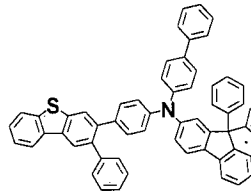


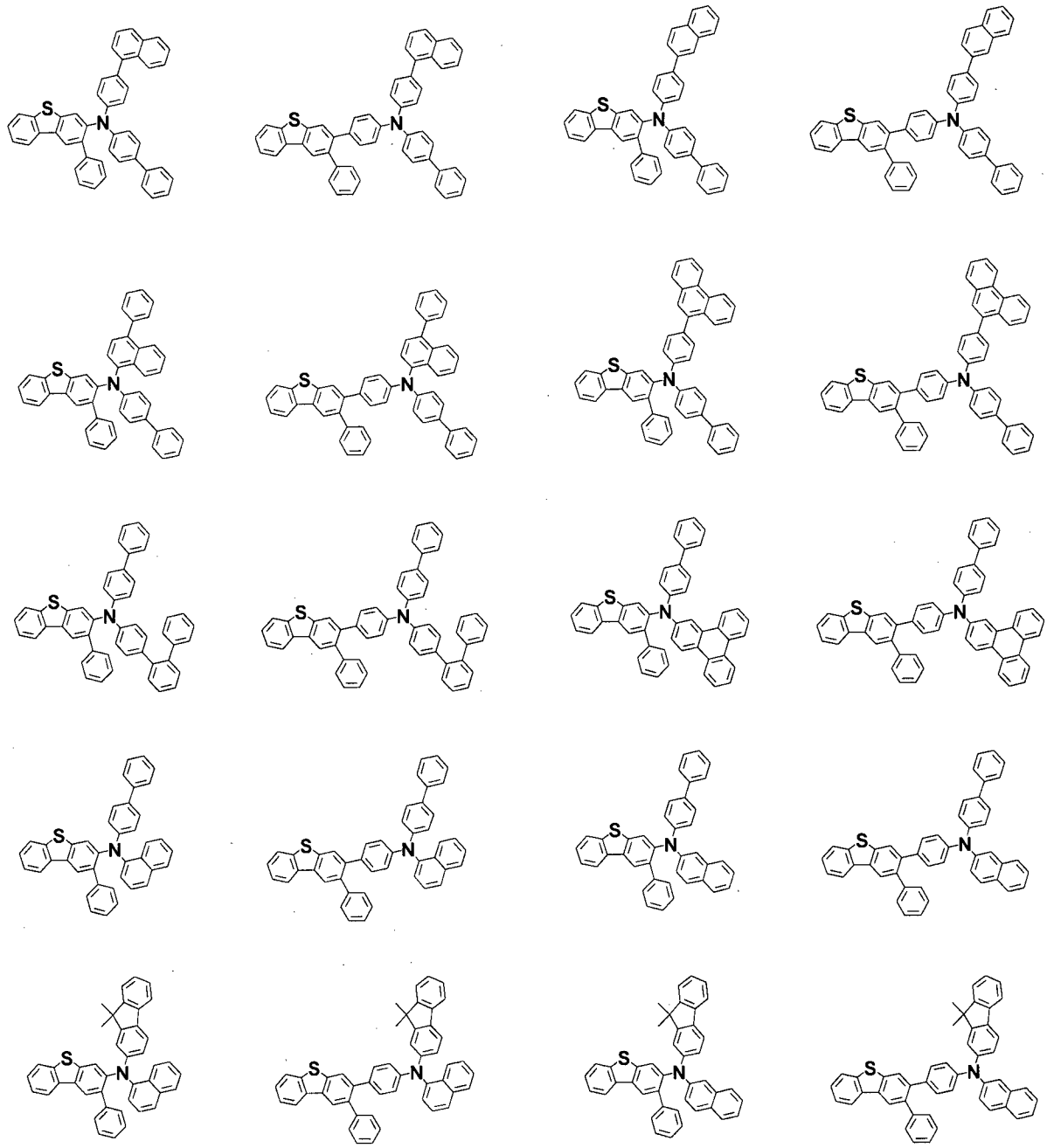
















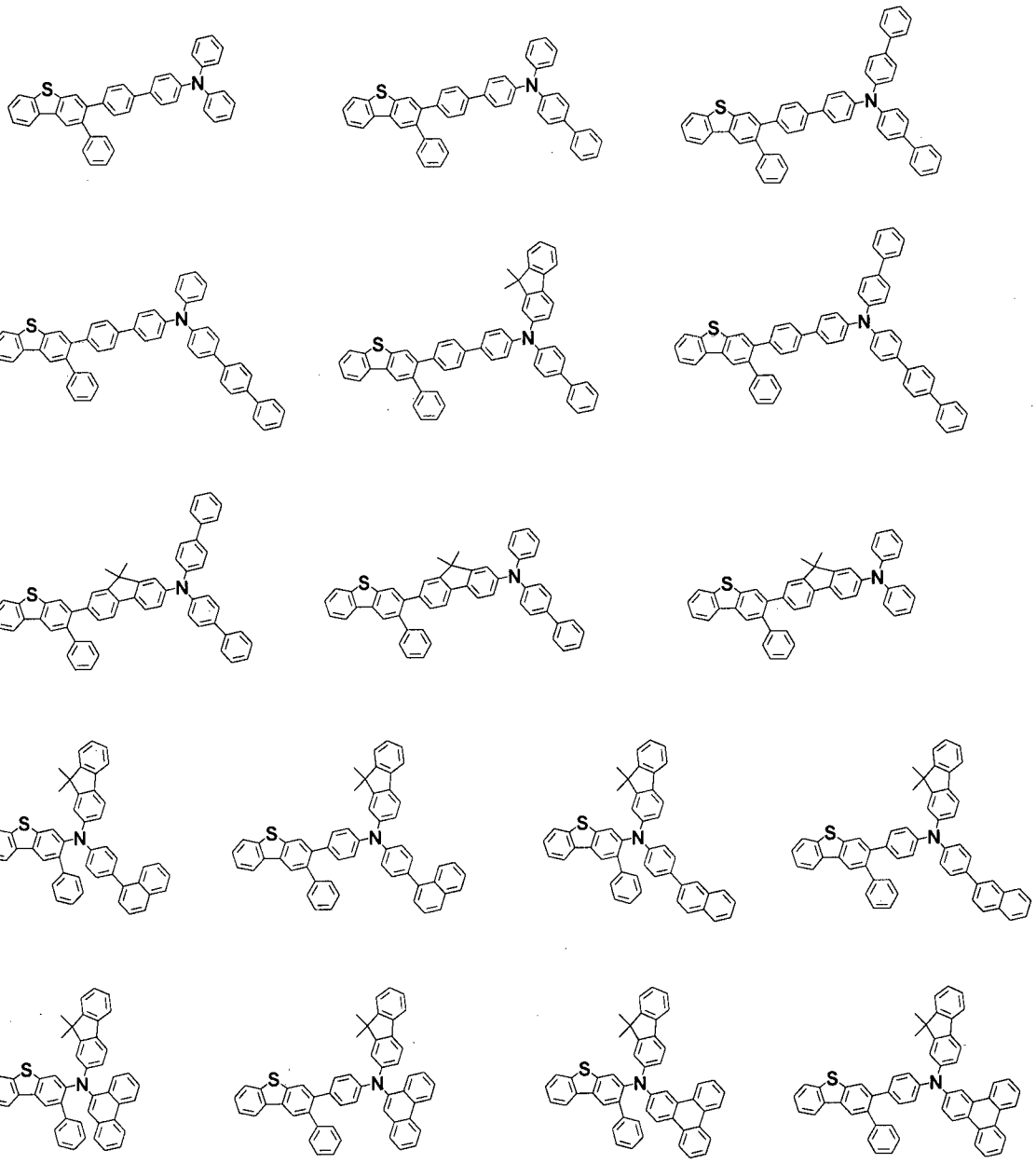


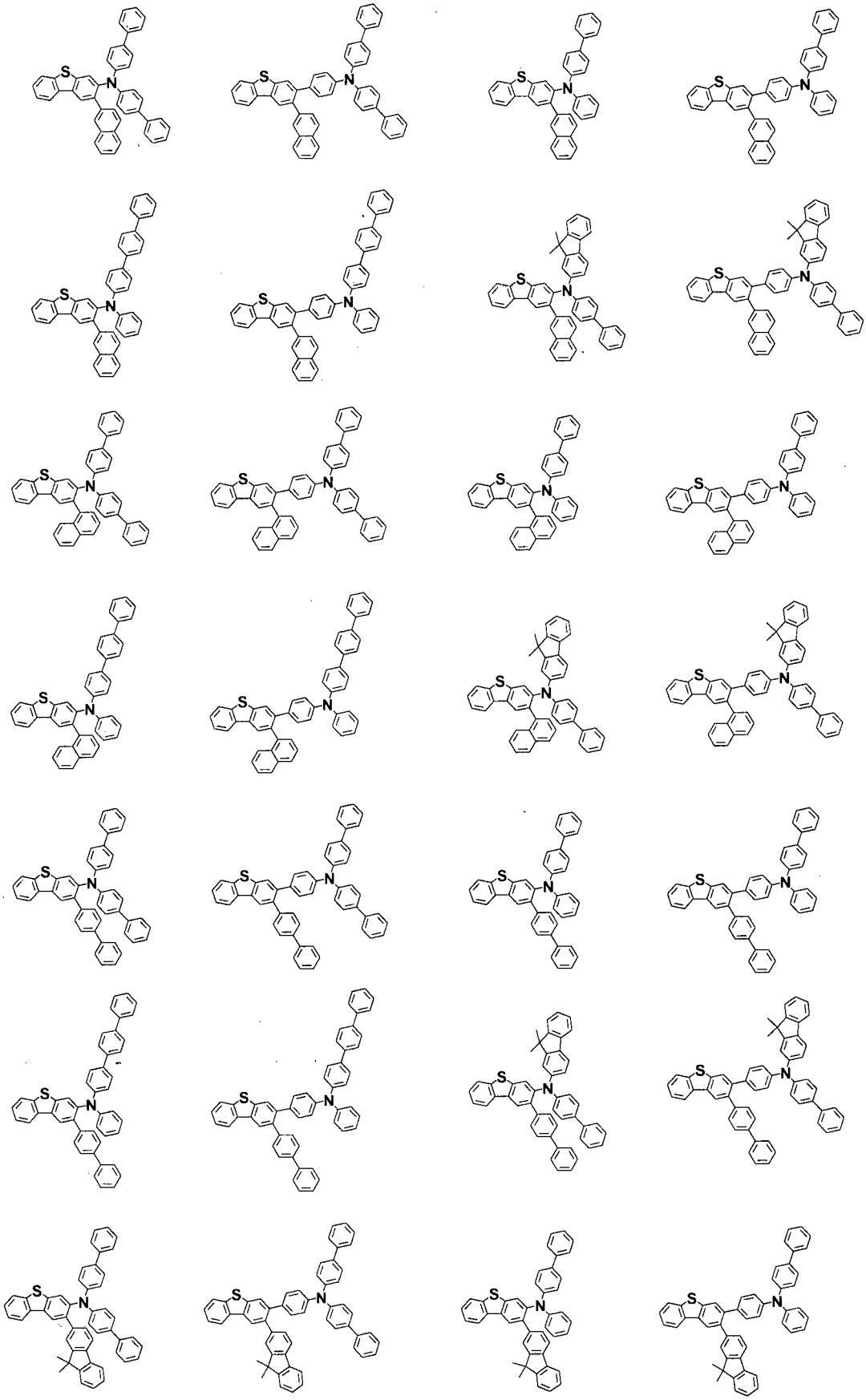


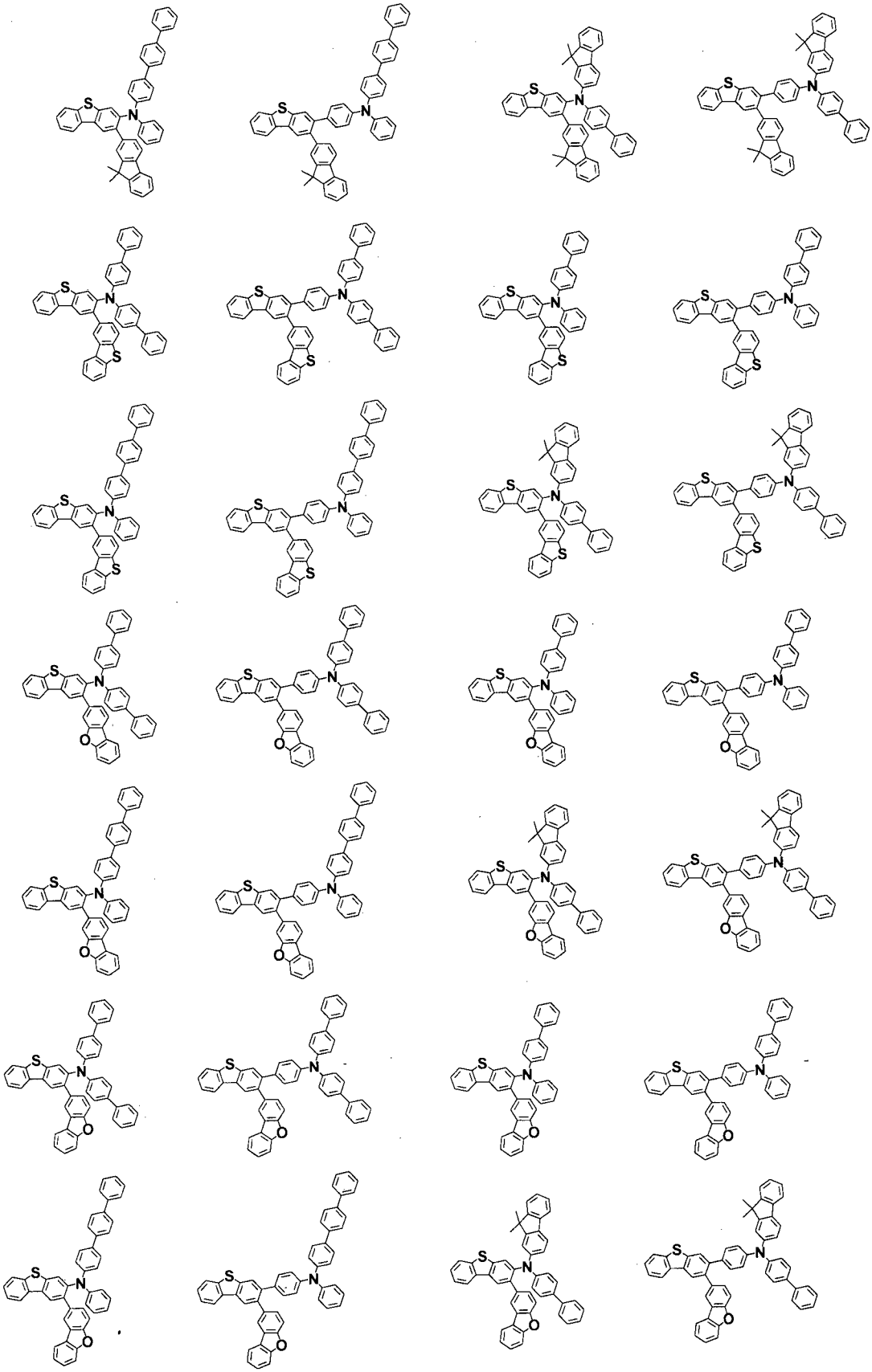


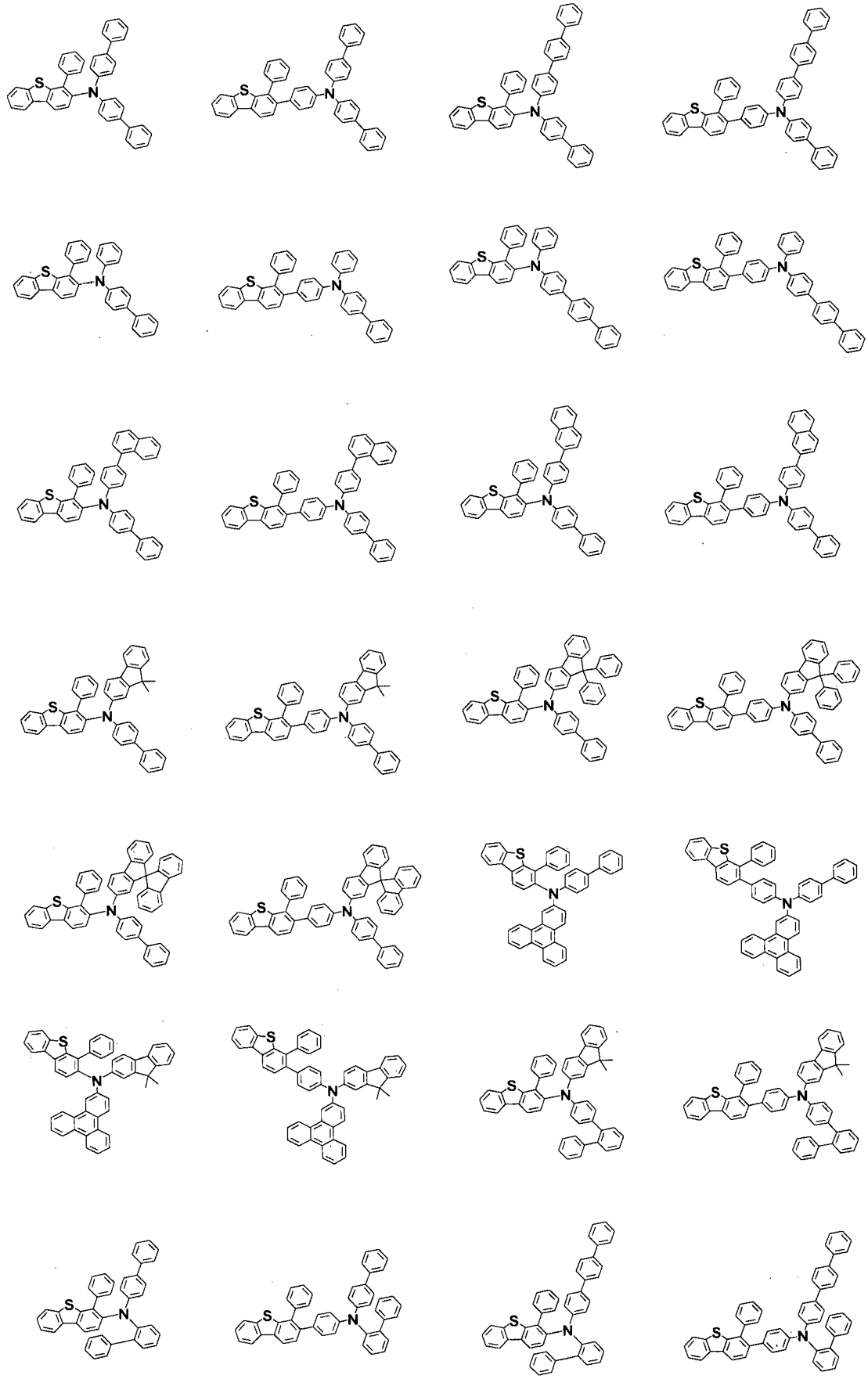





















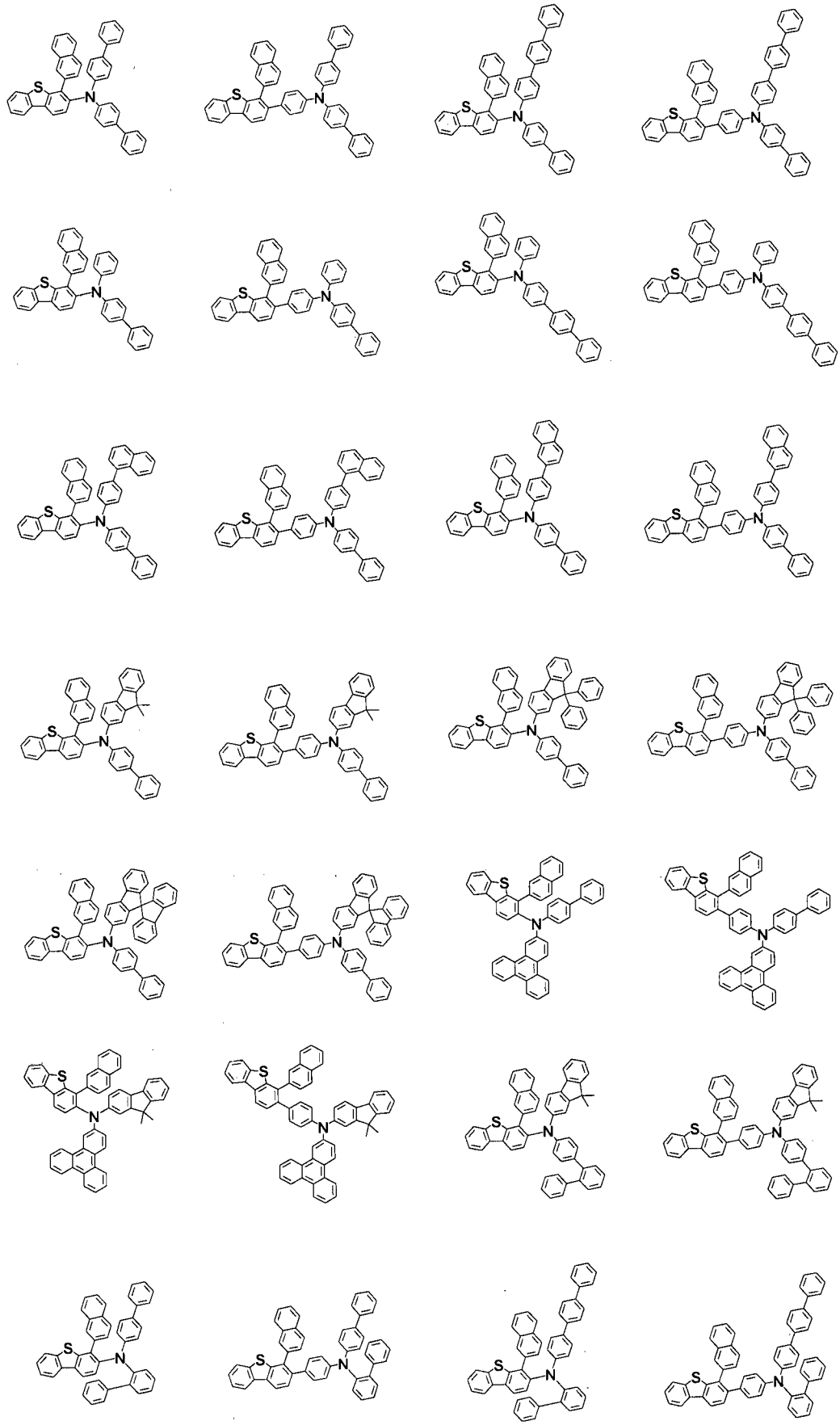


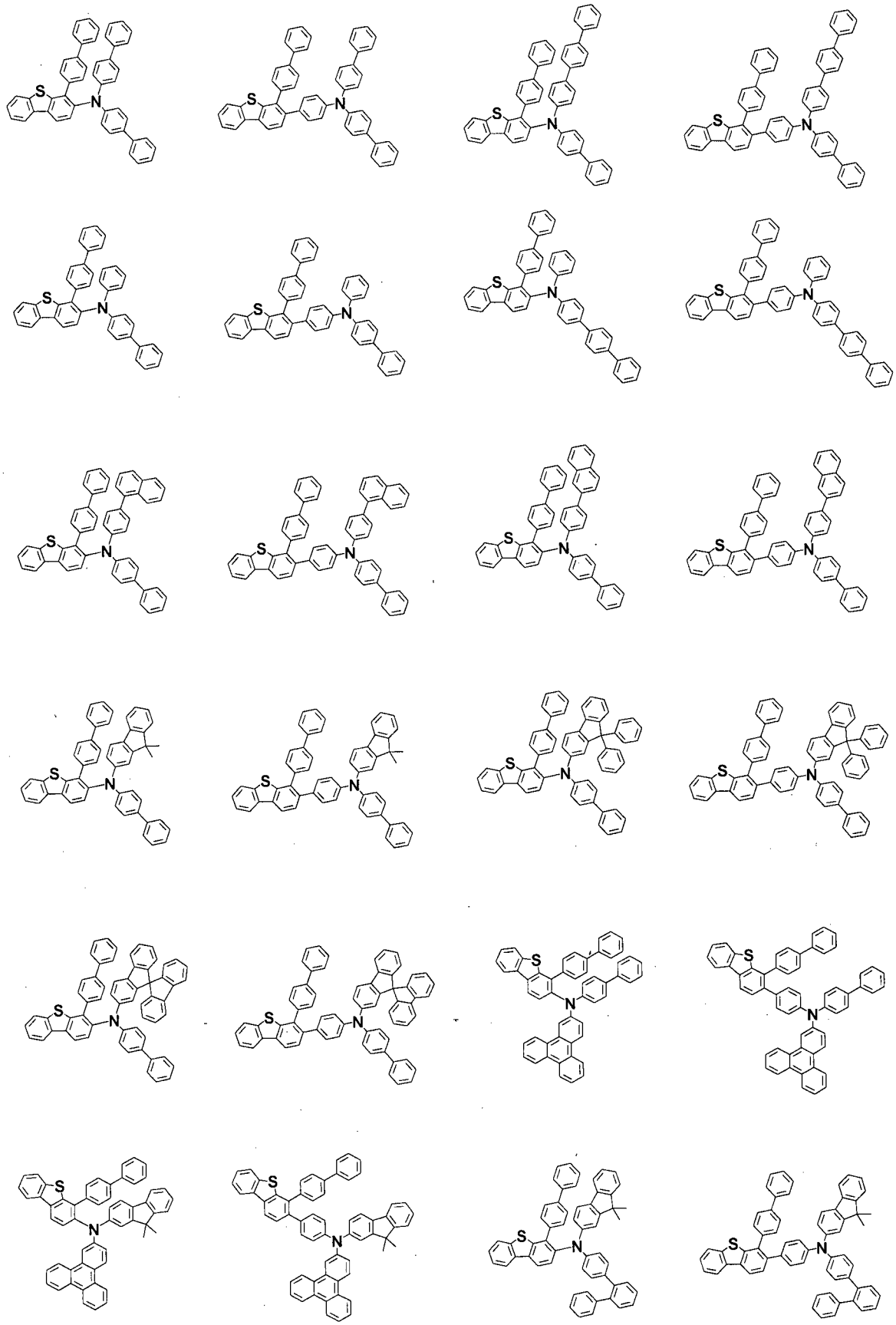


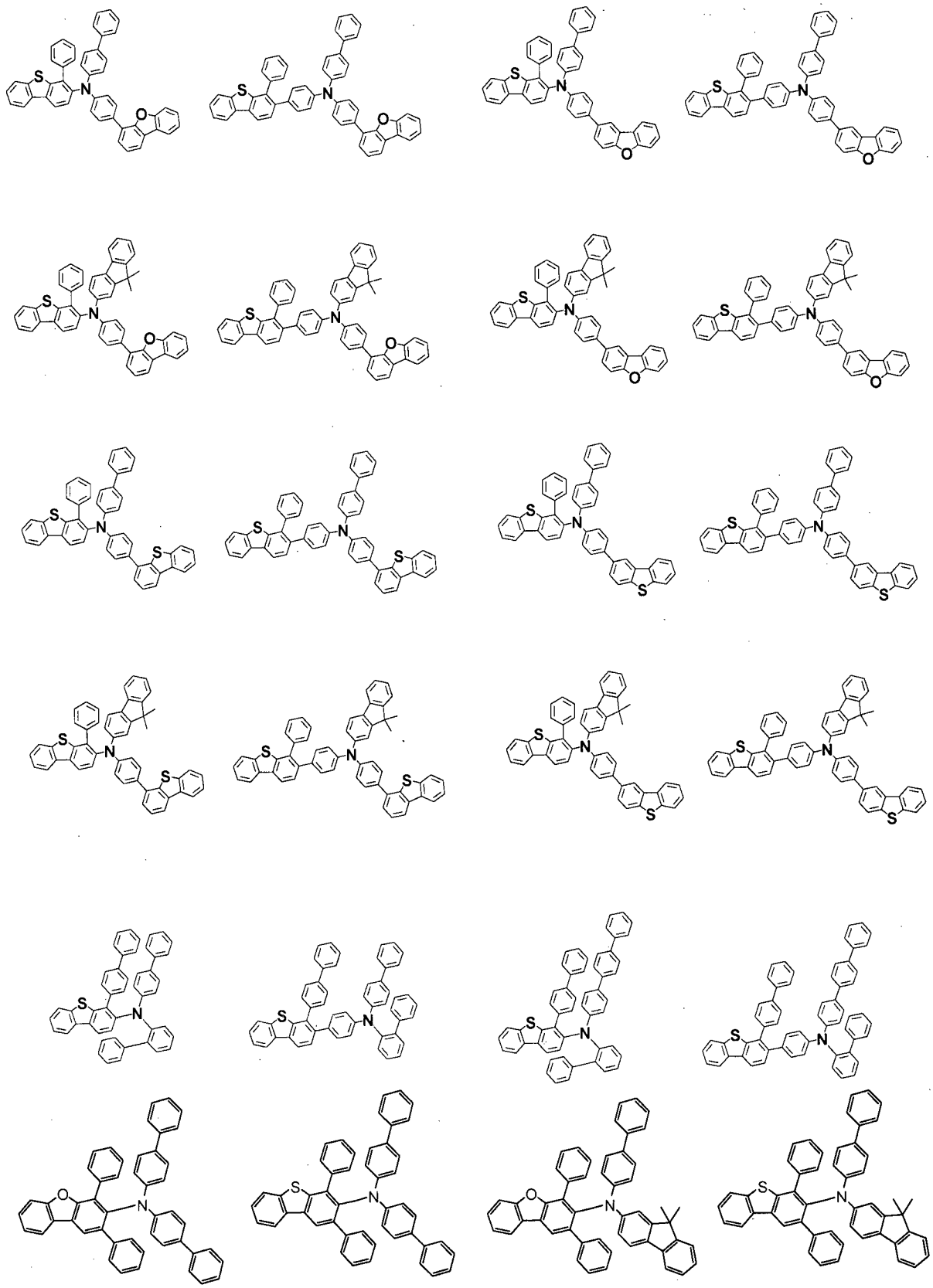












【청구항 11】

제1 전극; 상기 제1 전극과 대향하여 구비된 제2 전극; 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 구비된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기 발광 소자로서, 상기 유기물층 중 1층 이상은 제1항 내지 제10항 중 어느 하나의 항에 따른 화합물을 포함하는 것인, 유기 발광 소자.

【청구항 12】

제11항에 있어서,

상기 화합물을 포함하는 유기물층은 정공주입층; 정공수송층; 또는 정공주입과 정공수송을 동시에 하는 층인, 유기 발광 소자.

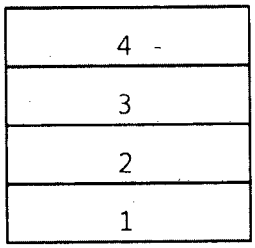
【청구항 13】

제11항에 있어서,

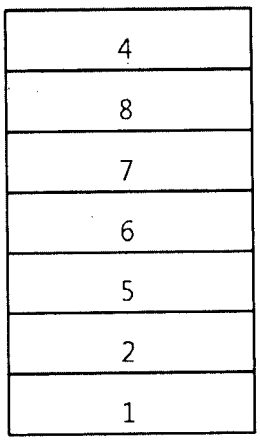
상기 화합물을 포함하는 유기물층은 전자 차단층인, 유기 발광 소자.

【도면】

【도 1】



【도 2】



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/KR2017/015256

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
C07D 409/12(2006.01)i, C07D 407/12(2006.01)i, C07D 307/91(2006.01)i, C07D 333/76(2006.01)i, H01L 51/00(2006.01)i, H01L 51/50(2006.01)i
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C07D 409/12; C07D 239/70; H01L 51/50; C09K 11/06; C07D 307/91; C07D 307/77; C07D 239/84; C07D 407/12; C07D 333/76; H01L 51/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above
Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
eKOMPASS (KIPO internal), STN (Registry, Caplus) & Keywords: dibenzofuran, dibenzothiophene, arylamine substituent, organic matter layer, organic light emitting element

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2013-168534 A1 (KONICA MINOLTA, INC.) 14 November 2013 See claim 1; paragraphs [0034], [0035], [0109]-[0114], [0122]-[0131]; compound 44.	1-13
X	WO 2016-208862 A1 (DUK SAN NEOLUX CO., LTD.) 29 December 2016 See claims 1-9; compound P-1.	1-13
X	KR 10-2016-0132344 A (DONGJIN SEMICHEM CO., LTD.) 18 November 2016 See claims 1-8; page 8, 18th compound.	1-13
X	KR 10-2012-0009761 A (ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS KOREA LTD.) 02 February 2012 See claims 1-10; compound 28.	1-13
X	WO 2006-128800 A1 (CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.) 07 December 2006 See claims 1, 5, 8-10; pages 43, 44; compounds A-45, A-46.	1-13
X	KR 10-2016-0019839 A (SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.) 22 February 2016 See claims 1-9; paragraphs [0056], [0057]; compound 16.	1-13
PX	WO 2017-126818 A1 (DUK SAN NEOLUX CO., LTD.) 27 July 2017 See claims 1, 3-10; compounds 3-5.	1-13

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
09 APRIL 2018 (09.04.2018)	**09 APRIL 2018 (09.04.2018)**
Name and mailing address of the ISA/KR Korean Intellectual Property Office Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-481-8578	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/KR2017/015256

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
WO 2013-168534 A1	14/11/2013	JP 6128119 B2	17/05/2017
WO 2016-208862 A1	29/12/2016	KR 10-2017-0001830 A	05/01/2017
KR 10-2016-0132344 A	18/11/2016	CN 107667099 A	06/02/2018
		TW 201708209 A	01/03/2017
		WO 2016-178544 A2	10/11/2016
		WO 2016-178544 A3	12/01/2017
KR 10-2012-0009761 A	02/02/2012	CN 103119125 A	22/05/2013
		JP 2013-538793 A	17/10/2013
		TW 201300499 A	01/01/2013
		WO 2012-011756 A1	26/01/2012
WO 2006-128800 A1	07/12/2006	AT 455162 T	15/01/2010
		CN 101184822 A	21/05/2008
		CN 101184822 B	26/11/2014
		CN 102603688 A	25/07/2012
		CN 102603688 B	25/11/2015
		EP 1885818 A1	13/02/2008
		EP 1885818 B1	13/01/2010
		JP 2008-545729 A	18/12/2008
		JP 5107237 B2	26/12/2012
		KR 10-1345104 B1	26/12/2013
		KR 10-1425423 B1	01/08/2014
		KR 10-2008-0018218 A	27/02/2008
		KR 10-2013-0080872 A	15/07/2013
		TW 200712171 A	01/04/2007
		US 2009-0131673 A1	21/05/2009
		US 2011-0248217 A1	13/10/2011
		US 2014-0217335 A1	07/08/2014
		US 7989644 B2	02/08/2011
		US 8735610 B2	27/05/2014
		US 8946984 B2	03/02/2015
KR 10-2016-0019839 A	22/02/2016	CN 106660985 A	10/05/2017
		EP 3135744 A1	01/03/2017
		JP 2016-040824 A	24/03/2016
		KR 10-2017-0043099 A	20/04/2017
		US 2016-0043316 A1	11/02/2016
		US 2017-0133591 A1	11/05/2017
		WO 2016-024792 A1	18/02/2016
WO 2017-126818 A1	27/07/2017	CN 106986835 A	28/07/2017
		KR 10-2017-0087691 A	31/07/2017

국 제 조 사 보 고 서

국제출원번호
PCT/KR2017/015256

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

C07D 409/12(2006.01)i, C07D 407/12(2006.01)i, C07D 307/91(2006.01)i, C07D 333/76(2006.01)i, H01L 51/00(2006.01)i, H01L 51/50(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)
C07D 409/12; C07D 239/70; H01L 51/50; C09K 11/06; C07D 307/91; C07D 307/77; C07D 239/84; C07D 407/12; C07D 333/76; H01L 51/00

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌
한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))
eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) , STN(Registry, Caplus) & 키워드: 디벤조퓨란, 디벤조티오펜, 아릴아민 치환기, 유기물층, 유기발광소자

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	WO 2013-168534 A1 (KONICA MINOLTA, INC.) 2013.11.14 청구항 1; 단락 [0034], [0035], [0109]-[0114], [0122]-[0131]; 화합물 44 참조.	1-13
X	WO 2016-208862 A1 (덕산네오룩스 주식회사) 2016.12.29 청구항 1-9; 화합물 P-1 참조.	1-13
X	KR 10-2016-0132344 A (주식회사 동진쎄미켐) 2016.11.18 청구항 1-8; 페이지 8, 18번째 화합물 참조.	1-13
X	KR 10-2012-0009761 A (롬엔드하스전자재료코리아유한회사) 2012.02.02 청구항 1-10; 화합물 28 참조	1-13
X	WO 2006-128800 A1 (CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.) 2006.12.07 청구항 1, 5, 8-10; 페이지 43, 44; 화합물 A-45, A-46 참조.	1-13
X	KR 10-2016-0019839 A (삼성디스플레이 주식회사) 2016.02.22 청구항 1-9; 단락 [0056], [0057]; 화합물 16 참조.	1-13
PX	WO 2017-126818 A1 (덕산네오룩스 주식회사) 2017.07.27 청구항 1, 3-10; 화합물 3-5 참조.	1-13

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

"A" 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

"E" 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

"L" 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

"O" 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

"P" 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

"T" 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

"X" 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

"Y" 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

"&" 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

국제조사의 실제 완료일	국제조사보고서 발송일
2018년 04월 09일 (09.04.2018)	2018년 04월 09일 (09.04.2018)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소
대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)
팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관
감유림
전화번호 +82-42-481-3516

국제조사보고서
대응특허에 관한 정보

국제출원번호
PCT/KR2017/015256

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
WO 2013-168534 A1	2013/11/14	JP 6128119 B2	2017/05/17
WO 2016-208862 A1	2016/12/29	KR 10-2017-0001830 A	2017/01/05
KR 10-2016-0132344 A	2016/11/18	CN 107667099 A	2018/02/06
		TW 201708209 A	2017/03/01
		WO 2016-178544 A2	2016/11/10
		WO 2016-178544 A3	2017/01/12
KR 10-2012-0009761 A	2012/02/02	CN 103119125 A	2013/05/22
		JP 2013-538793 A	2013/10/17
		TW 201300499 A	2013/01/01
		WO 2012-011756 A1	2012/01/26
WO 2006-128800 A1	2006/12/07	AT 455162 T	2010/01/15
		CN 101184822 A	2008/05/21
		CN 101184822 B	2014/11/26
		CN 102603688 A	2012/07/25
		CN 102603688 B	2015/11/25
		EP 1885818 A1	2008/02/13
		EP 1885818 B1	2010/01/13
		JP 2008-545729 A	2008/12/18
		JP 5107237 B2	2012/12/26
		KR 10-1345104 B1	2013/12/26
		KR 10-1425423 B1	2014/08/01
		KR 10-2008-0018218 A	2008/02/27
		KR 10-2013-0080872 A	2013/07/15
		TW 200712171 A	2007/04/01
		US 2009-0131673 A1	2009/05/21
		US 2011-0248217 A1	2011/10/13
		US 2014-0217335 A1	2014/08/07
		US 7989644 B2	2011/08/02
		US 8735610 B2	2014/05/27
		US 8946984 B2	2015/02/03
KR 10-2016-0019839 A	2016/02/22	CN 106660985 A	2017/05/10
		EP 3135744 A1	2017/03/01
		JP 2016-040824 A	2016/03/24
		KR 10-2017-0043099 A	2017/04/20
		US 2016-0043316 A1	2016/02/11
		US 2017-0133591 A1	2017/05/11
		WO 2016-024792 A1	2016/02/18
WO 2017-126818 A1	2017/07/27	CN 106986835 A	2017/07/28
		KR 10-2017-0087691 A	2017/07/31